

GaAs MMIC 芯片

1.1 单片集成功分器

型号	工作频率	功能描述	插损 (dB)	隔离度 (dB)	回波损耗 (dB)	尺寸	页码
YTGF-0P5/1P5	0.5~1.5	0° 2路	0.9	-20	-15	1.5*1.3mm	1
YTGF-01/03	1.0~3.0	0° 2路	0.8	-20	-15	1.5*1.2mm	3
YTGF-02/06	2.0~6.0	0° 2路	0.8	-20	-15	1.3*1.0mm	5
YTGF-02/18	2.0~18.0	0° 2路	1.4	-20	-15	2.25*2.0mm	7
YTGF-03/09	3.0~9.0	0° 2路	0.7	-20	-20	1.2*1.0mm	9
YTGF-06/18	6.0~18.0	0° 2路	0.8	-20	-20	1.0*0.85mm	11
YTGF-08/12	8.0~12.0	0° 3路	0.7	-20	-15	1.5*1.5mm	13
YTGF-12/26P5	12.0~26.5	0° 2路	0.7	-20	-20	1.5*2.0mm	17

1.2 单片集成低通滤波器

型号	通带频率	功能描述	插损 (dB)	回波损耗 (dB)	带外衰减 (dB)	尺寸	页码
YTLF-1T	DC~1.0	低通滤波器	0.9@0.5GHz; 1.9@1.0GHz	-20	22@1.6GHz; 40@2.0~16 GHz	1.5*0.75mm	21
YTLF-1P5T	DC~1.5	低通滤波器	0.87@1.0GHz; 1.5@1.5GHz	-20	22@2.3GHz; 40@2.6~11 GHz	1.5*0.75mm	22
YTLF-2T	DC~2.0	低通滤波器	0.85@1.5GHz; 1.4@2.0GHz	-20	22@2.3GHz; 40@2.6~11 GHz	1.5*0.75mm	23
YTLF-2P5T	DC~2.5	低通滤波器	0.9@2GHz; 1.4@2.5GHz	-20	20@3.9GHz; 40@4.8~20 GHz	1.5*0.75mm	24
YTLF-3T	DC~3.0	低通滤波器	1.0@2.5GHz; 1.2@3GHz	-20	22@4.6GHz; 40@5.2~17 GHz	1.5*0.75mm	25

YTLF-3P5T	DC~3.5	低通滤波器	1.0@3GHz; 1.3@3.5GHz	-25	23@5.2GHz; 40@6.2~30 GHz	1.5*0.7mm	26
YTLF-4	DC~4.0	低通滤波器	1.2@3GHz; 1.8@4GHz	-21	23@5.6GHz; 40@6.8~30GHz	1.5*0.7mm	27
YTLF-4T	DC~4.0	低通滤波器	1.0@3GHz; 1.7@4GHz	-23	23@5.2GHz; 40@6.2~19GHz	1.5*0.7mm	28
YTLF-5T	DC~5.0	低通滤波器	0.8@4GHz; 1.2@5GHz	-22	23@6.9GHz; 40@7.5~20 GHz	1.3*0.7mm	29
YTLF-6	DC~6.0	低通滤波器	1.0@5GHz; 1.4@6GHz	-20	23@8.4GHz; 40@10.0~40 GHz	1.5*0.7mm	30
YTLF-6T	DC~6.0	低通滤波器	1.0@5GHz; 1.7@6GHz	-22	23@7.7GHz; 40@8.3~23 GHz	1.3*0.75mm	31
YTLF-7	DC~7.0	低通滤波器	1.1@6GHz; 1.6@7GHz	-20	23@9.5GHz; 40@11.4GHz	1.5*0.7mm	32
YTLF-8	DC~8.0	低通滤波器	1.3@7GHz; 1.8@8GHz	-20	23@10.3GHz; 40@12.3 GHz	1.5*0.7mm	33
YTLF-9	DC~9.0	低通滤波器	1.2@8GHz; 1.6@9GHz	-20	20@12.3GHz; 40@14.6 GHz	1.2*0.7mm	34
YTLF-10	DC~10	低通滤波器	1.2@9GHz; 2.1@10GHz	-20	20@12.5GHz; 40@14.8 GHz	1.3*0.7mm	35
YTLF-12	DC~12	低通滤波器	1.3@11GHz; 2.5@12GHz	-20	20@14.7GHz; 40@17.2GHz	1.3*0.75mm	36
YTLF-14	DC~14	低通滤波器	1.5@13GHz; 2.1@14GHz	-20	20@17.3GHz; 40@20.2GHz	1.2*0.75mm	37
YTLF-16	DC~16	低通滤波器	1.6@15GHz; 2.5@16GHz	-21	20@19.5GHz; 40@22.7GHz	1.0*0.5mm	38
YTLF-19	DC~19	低通滤波器	1.4@18GHz; 2.5@19GHz	-20	20@22.7GHz; 40@26.5GHz	1.2*0.7mm	39

1.3 单片集成高通滤波器

型号	通带频率	功能描述	插损	回波损耗	带外衰减	尺寸	页
----	------	------	----	------	------	----	---

			(dB)	(dB)	(dB)		码
YTHF-2T	2~18	高通滤波器	2.4@2.0GHz; 0.9@3.0GHz	-20	20dB@1.5GHz; 40@1.45 GHz	1.5*0.75mm	40
YTHF-3T	3~18	高通滤波器	1.5@3.0GHz; 0.8@4.0GHz	-20	25dB@1.9GHz; 48@1.7 GHz	1.5*0.75mm	41
YTHF-4T	4~20	高通滤波器	2.1@4.0GHz; 1.1@5.0GHz	-20	20dB@3.1GHz; 40@2.8 GHz	1.5*0.75mm	42
YTHF-5T	5~30	高通滤波器	1.8@5.0GHz; 1.1@6.0GHz	-20	22@3.6GHz; 43@3.2 GHz	1.5*0.75mm	43
YTHF-6T	6~30	高通滤波器	1.8@6.0GHz; 1.1@7.0GHz	-20	22@3.6GHz; 43@3.2 GHz	1.2*0.75mm	44
YTHF-7T	7~30	高通滤波器	1.4@7.0GHz; 1.0@8.0GHz	-20	22@5.0GHz; 41@4.4 GHz	1.2*0.75mm	45
YTHF-8T	8~30	高通滤波器	1.8@8.0GHz; 1.3@9.0GHz	-20	21@6.5GHz; 40@6.2 GHz	1.5*0.75mm	46
YTHF-9	9~30	高通滤波器	1.35@9.0GHz; 1.35@10.0GHz	-20	21@6.0GHz; 40@4.8 GHz	1.2*0.75mm	47
YTHF-10	10~30	高通滤波器	1.4@10.0GHz; 1.2@11.0GHz	-20	21@6.8GHz; 40@5.4 GHz	1.5*0.75mm	48

1.4 单片集成幅度均衡器

型号	工作频率	均衡类型	均衡量 (dB)	插损 (dB)	回波损耗 (dB)	尺寸	页码
YTJH-1/2-2	1~2	负斜率型	2*	0.30	-22	0.75*1.0mm	54
YTJH-1/2-3	1~2	负斜率型	3*	0.45	-22	0.75*1.0mm	55
YTJH-1/6-3P5	1~6	负斜率型	3.5	0.43	-20	0.8*0.85mm	56
YTJH-1/8-4	1~8	负斜率型	4	0.47	-22	0.8*0.85mm	57

YTJH-2/4-3	2~4	负斜率型	3	0.6	-21	0.8*0.85mm	58
YTJH-2/4-4	2~4	负斜率型	4	0.6	-20	0.8*0.85mm	59
YTJH-2/18-8	2~18	负斜率型	8.4	1.2	-18	0.75*0.85mm	60
YTJH-6/12-3	6~12	负斜率型	3.4	0.9	-20	0.8*0.85mm	61
YTJH-6/18-3	6~18	负斜率型	3	1	-25	0.75*0.85mm	62
YTJH-6/18-4	6~18	负斜率型	4	0.9	-22	0.75*0.85mm	63
YTJH-6/18-5	6~18	负斜率型	5	1	-25	0.75*0.85mm	64
YTJH-6/18-6	6~18	负斜率型	6	1.2	-22	0.75*0.85mm	65
YTJH-8/12-2	8~12	负斜率型	2	0.7	-22	0.75*1.0mm	66
YTJH-8/12-3	8~12	负斜率型	3	1	-22	0.75*1.0mm	67
YTJH-8/12-4	8~12	负斜率型	4	1	-16	0.75*0.85mm	68

1.5 单片集成宽带固定/可选衰减器

型号	衰减量	衰减精度 DC-20Ghz	回波损耗 DC-20Ghz	衰减精度 20-40 GHz	回波损耗 (dB)	尺寸	页 码
YTGS-0	0	±0.2	20	±0.8	20	0.5*0.5mm	69
YTGS-0P5	0.5	±0.2	20	±0.5	20	0.5*0.5mm	70
YTGS-1	1	±0.2	20	±0.6	20	0.5*0.5mm	71
YTGS-2	2	±0.3	25	±0.6	23	0.5*0.5mm	72
YTGS-3	3	±0.2	23	±0.5	22	0.5*0.5mm	73
YTGS-4	4	±0.3	20	±0.5	19	0.5*0.5mm	74
YTGS-5	5	±0.4	20	±0.5	18	0.5*0.5mm	75
YTGS-6	6	±0.2	20	±0.5	17	0.5*0.5mm	76
YTGS-8	8	±0.4	20	±0.4	17	0.5*0.5mm	77
YTGS-10	10	±0.3	20	±0.3	18	0.8*0.5mm	78
YTGS-15	15	±0.7	20	±0.7	17	0.8*0.5mm	79

YTGS-20	20	±0.8	18	±0.8	15	0.8*0.5mm	80
YTGS-0P5/0/1	0/0.5/1 可选	±0.1	25	±0.15	20	1.0*0.5mm	81
YTGS-1/0/2	0/1/2 可 选	±0.2	25	±0.3	20	1.0*0.5mm	83
YTGS-1P5/0/3	0/1.5/3 可选	±0.2	25	±0.4	20	1.0*0.5mm	85
YTGS-2/0/4	0/2/4 可 选	±0.2	25	±0.5	20	1.0*0.5mm	87
YTGS-3/0/5	0/3/5 可 选	±0.2	22	±0.6	19	1.0*0.5mm	89

1.6 GaAs MMIC 驱动放大器芯片

型 号	工作频率	输入功率 dBm	输出回波损耗 (dB)	插损 (dB)	输入回波损耗 (dB)	尺寸	页 码
YT451	5~20	+10	11	0.30	18	1.5*1.4mm	

性能特点

通带频段: 0.5~1.5 GHz

通带损耗: 0.9 dB

隔离度: 20dB

回波损耗: -15dB

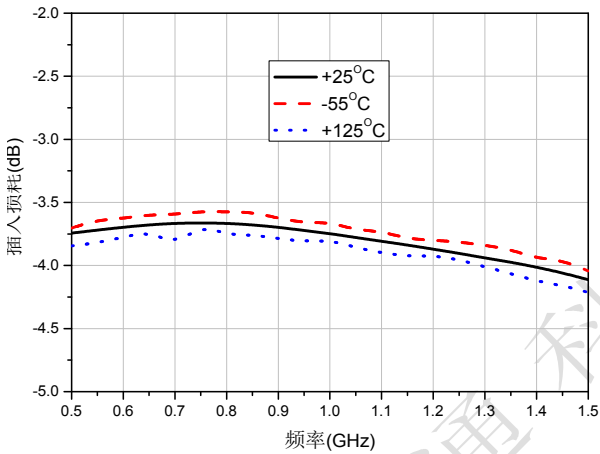
芯片尺寸: 1.5mmx1.3mm x 0.1mm

接口: 50Ω共面波导线

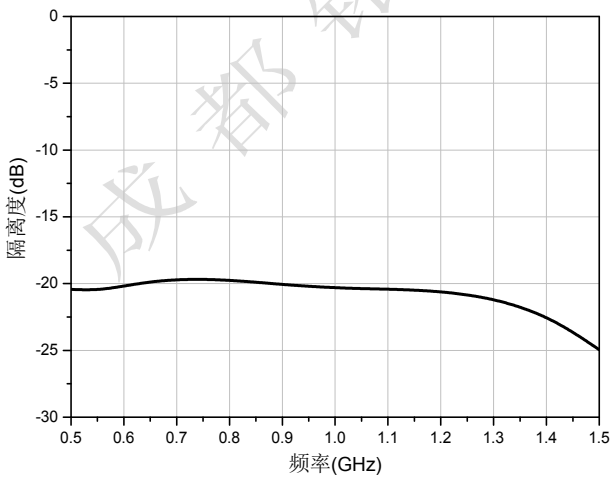
产品简介

YTGF-0P5/1P5是一款砷化镓单片二功分器芯片。该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易集成、等特点, 广泛应用于功率分配及合成。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理, 适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

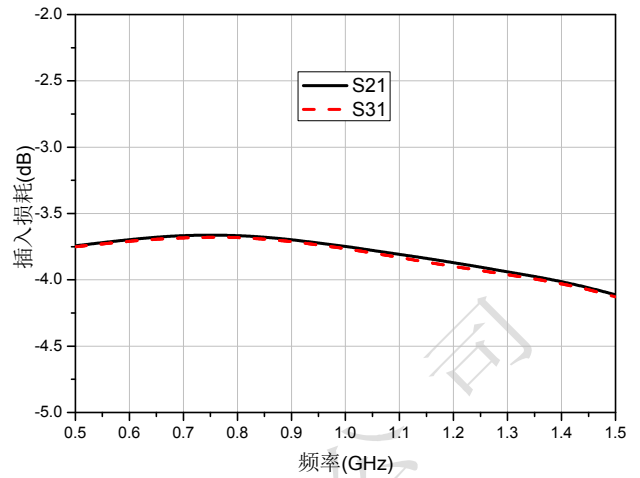
典型曲线 (T_a=+25°C)



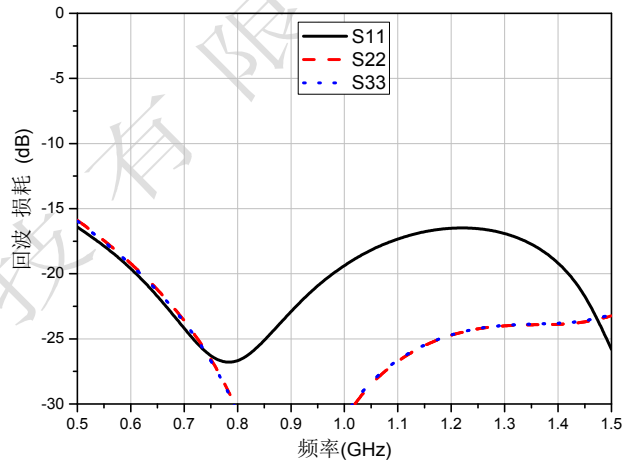
三温插入损耗



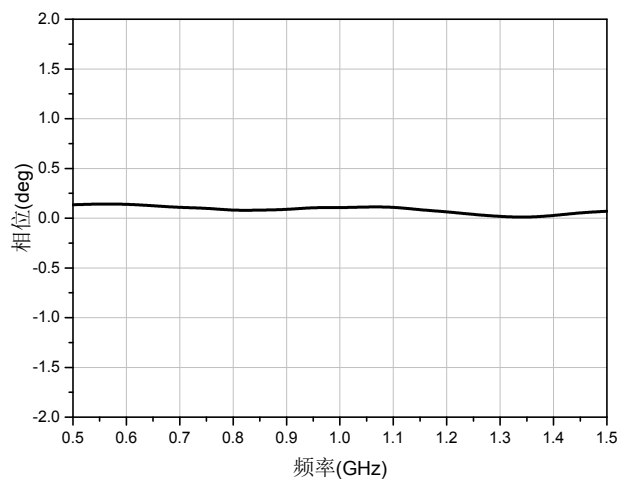
隔离度



插入损耗



回波损耗

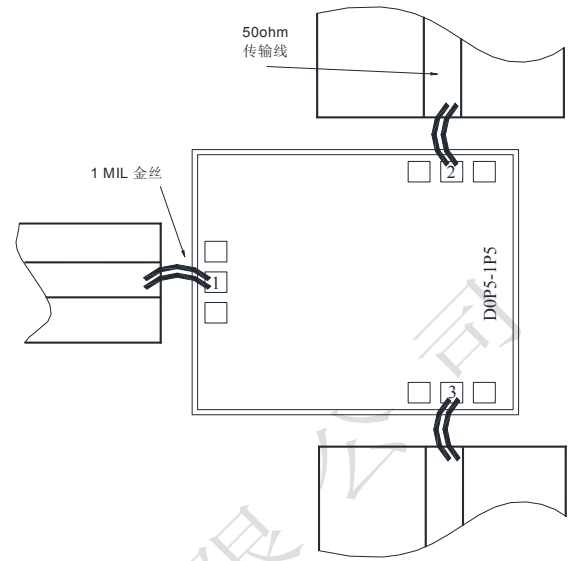
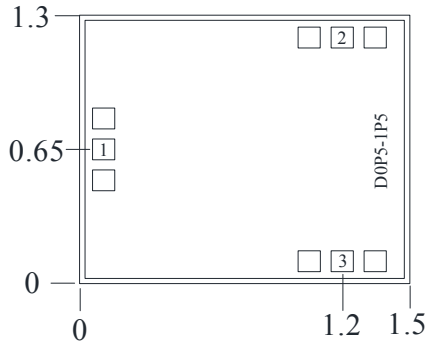


相位一致性

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65℃~+150℃
使用温度	-55℃~+125℃

外形尺寸



说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ±0.05mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.10mm*0.10mm
4. 不能在通孔上进行键合

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1	RFin	RF 输入端口, 阻抗 50ohm
2、3	RFout	RF 输出端口, 阻抗 50ohm
	GND	

应用信息

1. 装配示意图

注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150℃。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: 1~3 GHz

通带损耗: 0.8 dB

隔离度: 20dB

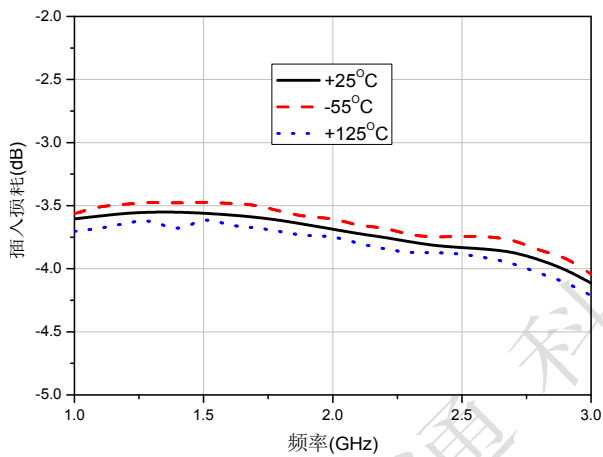
回波损耗: -15dB

芯片尺寸: 1.5mmx1.2mm x 0.1mm

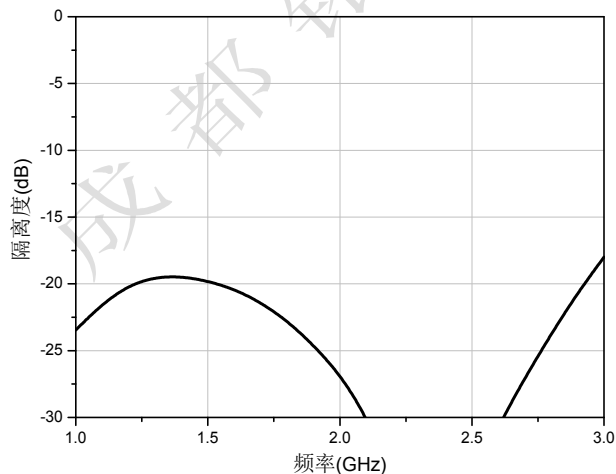
接口: 50Ω共面波导线

产品简介

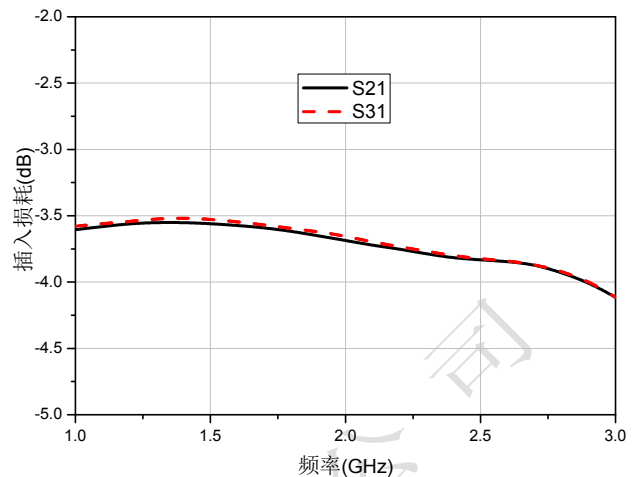
YTGF-01/03是一款砷化镓单片二功分器芯片。该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易集成、等特点, 广泛应用于功率分配及合成。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理, 适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

典型曲线 ($T_A=+25^{\circ}\text{C}$)

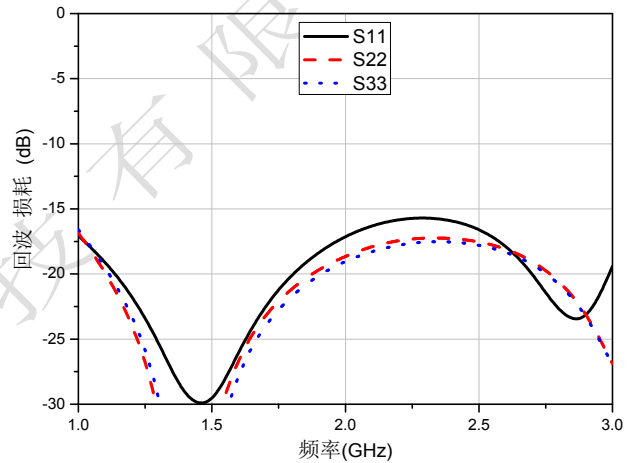
三温插入损耗



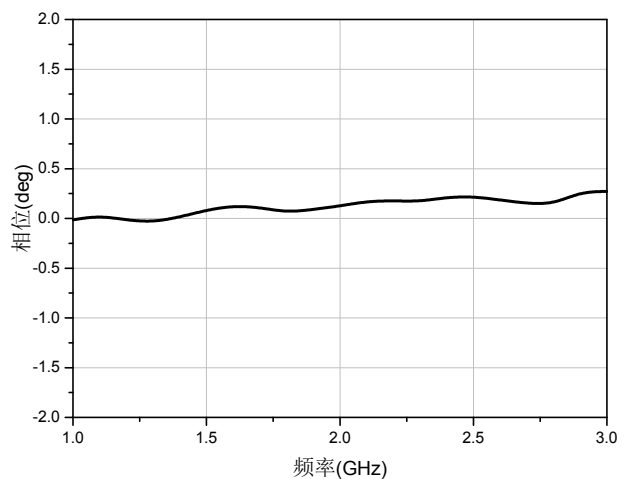
隔离度



插入损耗



回波损耗

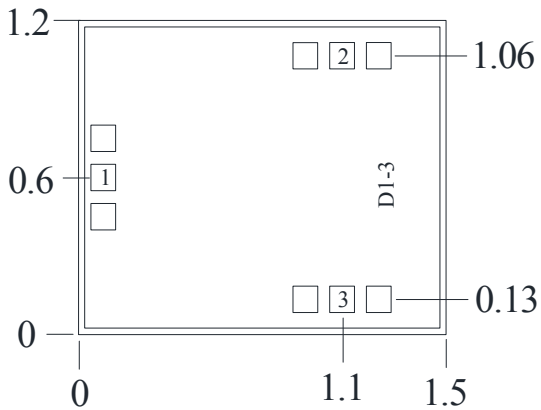


相位一致性

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C~+150°C
使用温度	-55°C~+125°C

外形尺寸



说明:

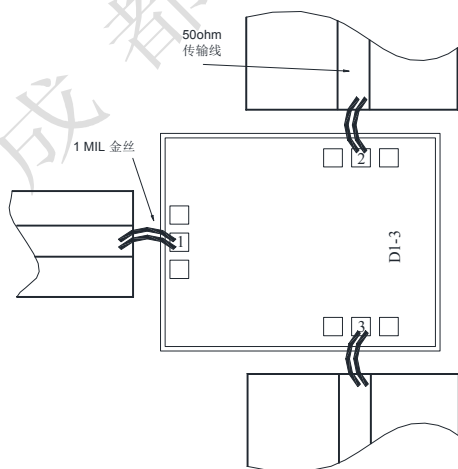
1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.10\text{mm} \times 0.10\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1	RFin	RF 输入端口, 阻抗 50ohm
2、3、4	RFout	RF 输出端口, 阻抗 50ohm
	GND	

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152 \text{ mm}$ ($3 \sim 6 \text{ mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22 \text{ gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: 2~6 GHz

通带损耗: 0.8 dB

隔离度: 20dB

回波损耗: -15dB

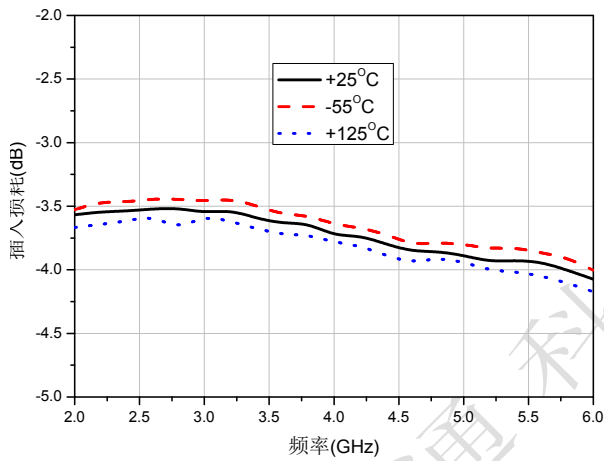
芯片尺寸: 1.3mmx1.0mm x 0.1mm

接口: 50Ω共面波导线

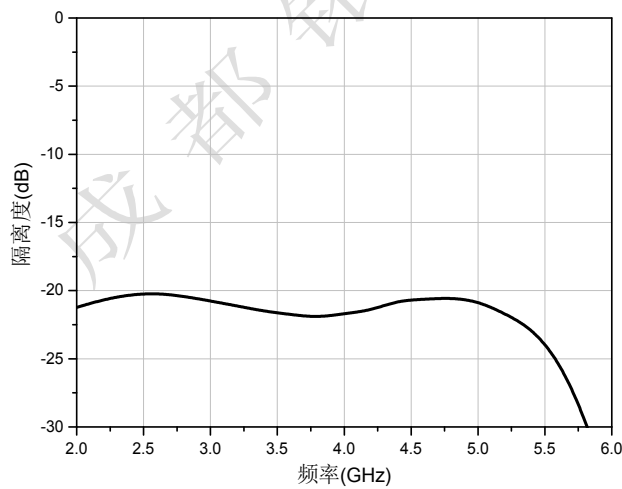
产品简介

YTGF-02/06是一款砷化镓单片二功分器芯片。该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易集成、等特点, 广泛应用于功率分配及合成。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理, 适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

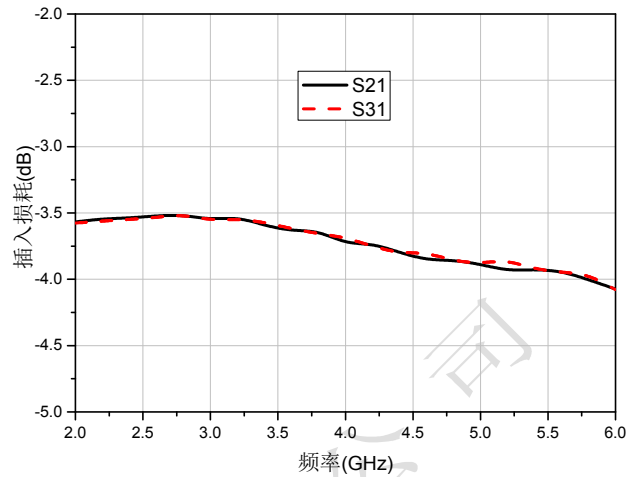
典型曲线 (T_A=+25°C)



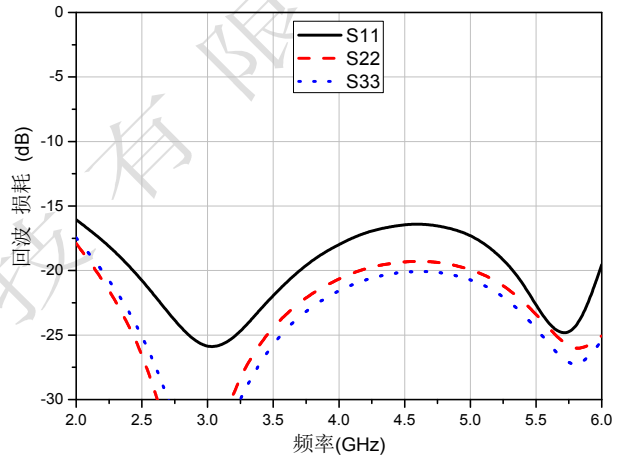
三温插入损耗



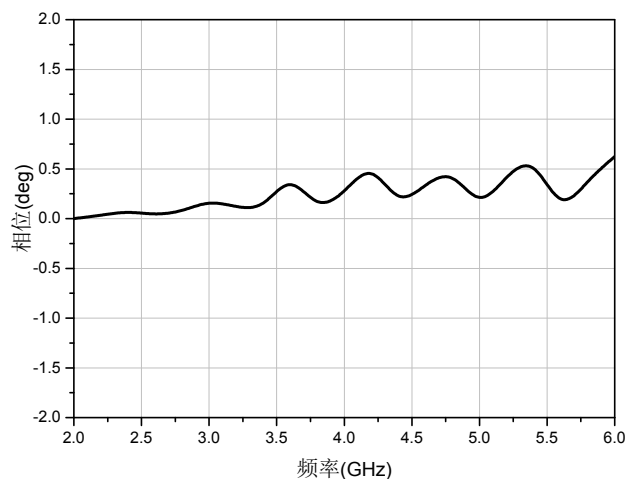
隔离度



插入损耗



回波损耗

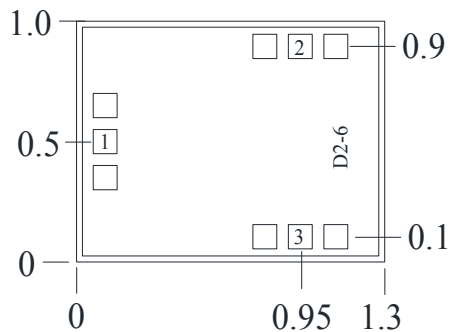


相位一致性

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65℃~+150℃
使用温度	-55℃~+125℃

外形尺寸



说明：

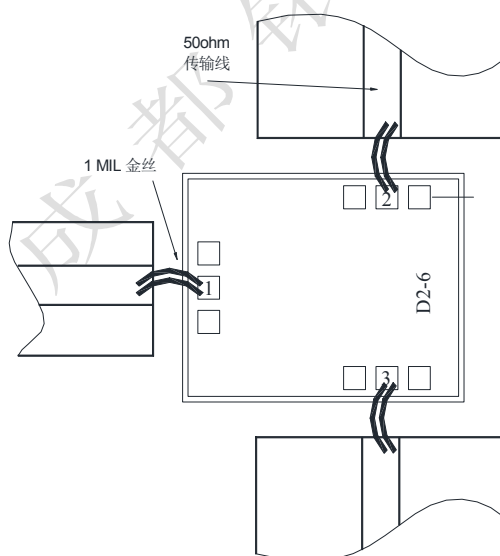
1. 单位：毫米，公差：±0.05mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金，压点尺寸：0.10mm*0.10mm
4. 不能在通孔上进行键合

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1	RFin	RF 输入端口，阻抗 50ohm
2、3、4	RFout	RF 输出端口，阻抗 50ohm
	GND	

应用信息

1. 装配示意图



注：陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150℃。球形键合劈刀压力 40~50gf，楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。

性能特点

通带频段: 2~18 GHz

通带损耗: 1.4 dB

隔离度: 20dB

回波损耗: -15dB

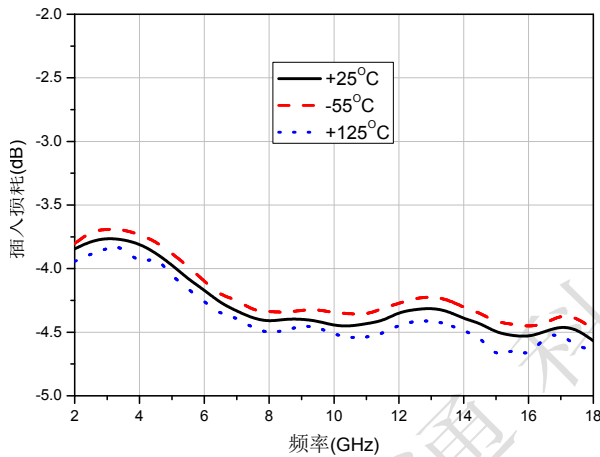
芯片尺寸: 2.25mmx2.0mm x 0.1mm

接口: 50Ω共面波导线

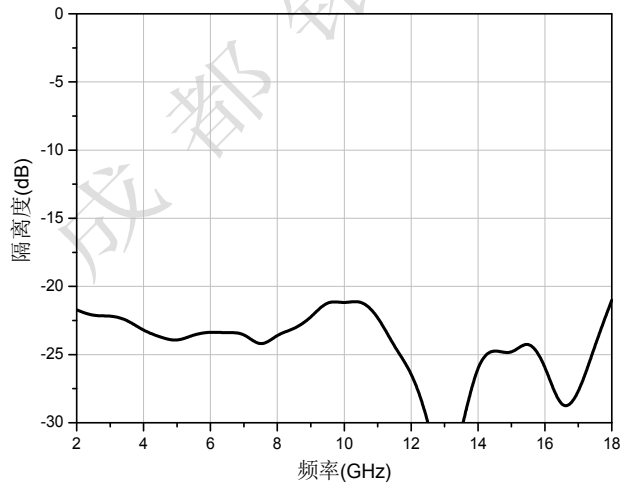
产品简介

YTGF-02/18是一款砷化镓单片二功分器芯片。该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易集成、等特点, 广泛应用于功率分配及合成。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理, 适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

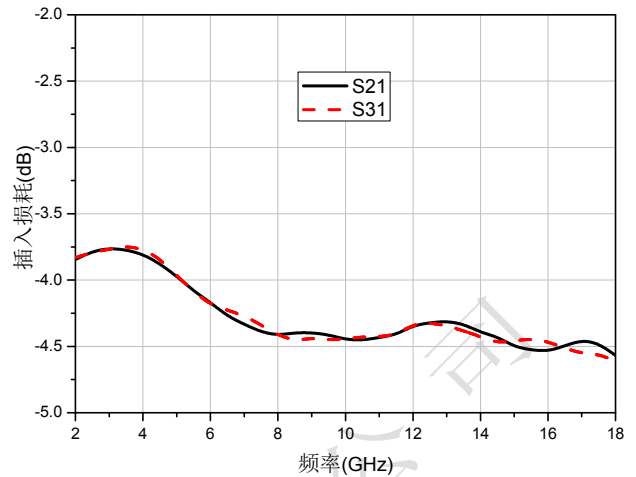
典型曲线 (T_A=+25°C)



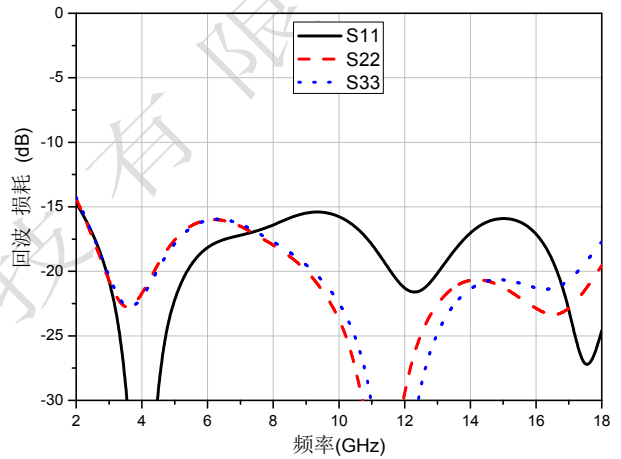
三温插入损耗



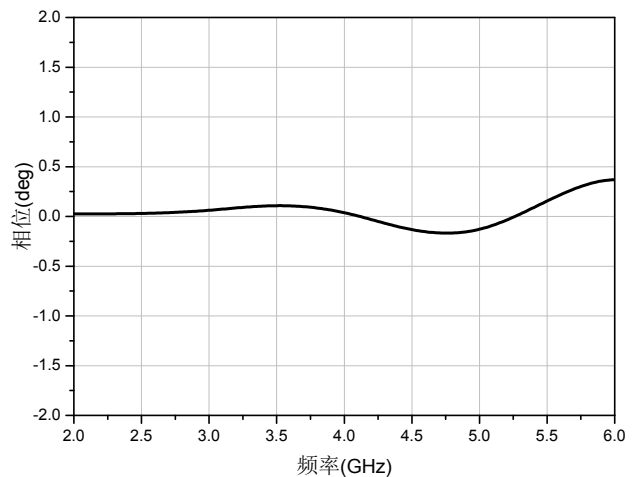
隔离度



插入损耗



回波损耗

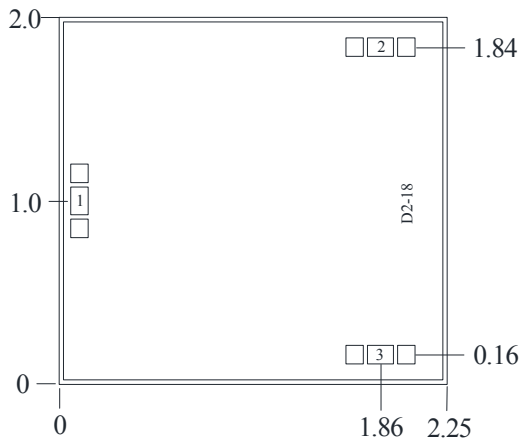


相位一致性

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C~+150°C
使用温度	-55°C~+125°C

外形尺寸



说明：

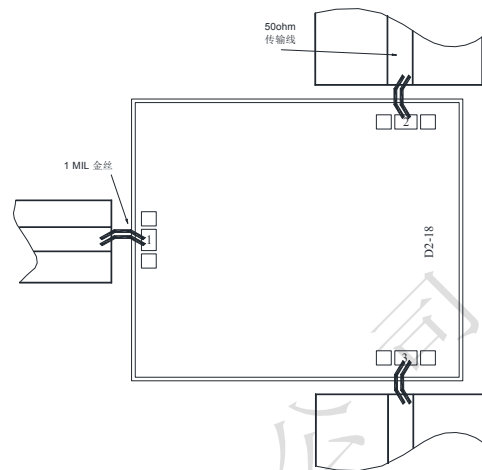
1. 单位：毫米，公差： $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金，压点尺寸： $0.10\text{mm} \times 0.10\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1	RFin	RF 输入端口，阻抗 50ohm
2、3	RFout	RF 输出端口，阻抗 50ohm
	GND	

应用信息

1. 装配示意图



注：陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152 \text{ mm}$ (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$ ，楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。

性能特点

通带频段: 3~9 GHz

通带损耗: 0.7 dB

隔离度: 20dB

回波损耗: -20dB

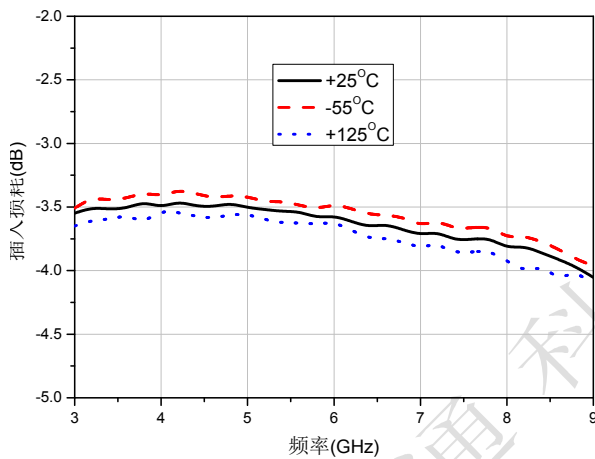
芯片尺寸: 1.2mmx1.0mm x 0.1mm

接口: 50Ω共面波导线

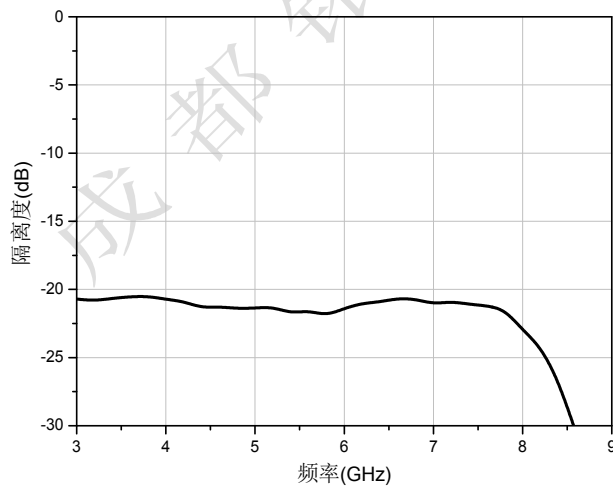
产品简介

YTGF-03/09是一款砷化镓单片二功分器芯片。该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易集成、等特点, 广泛应用于功率分配及合成。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理, 适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

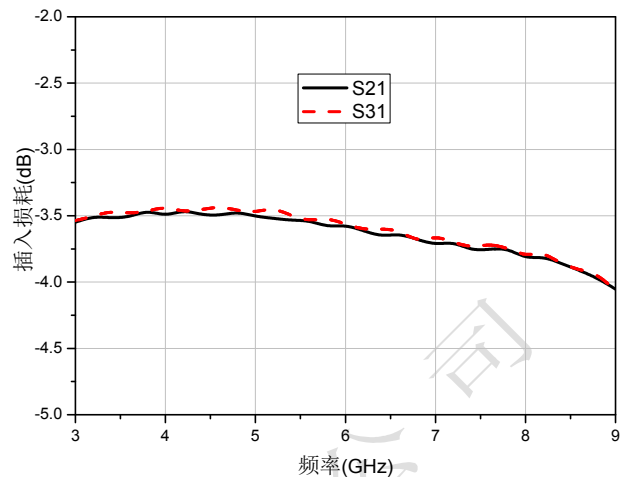
典型曲线 (T_A=+25°C)



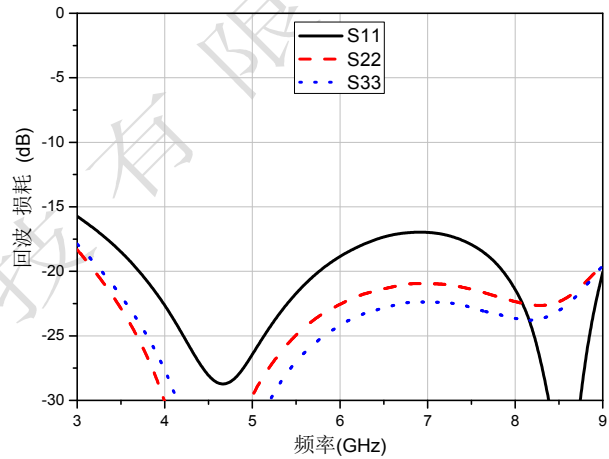
三温插入损耗



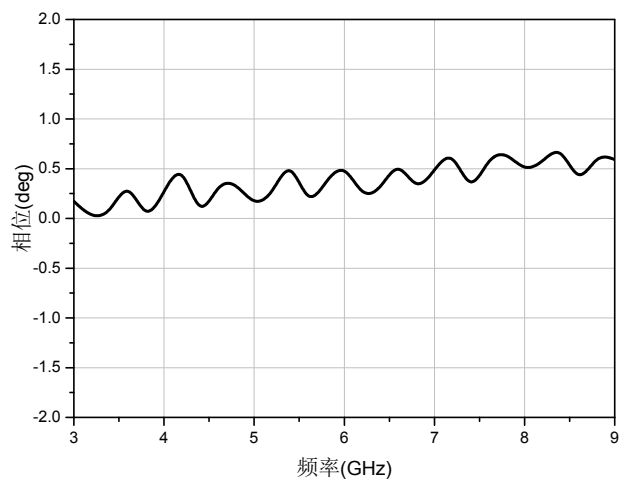
隔离度



插入损耗



回波损耗

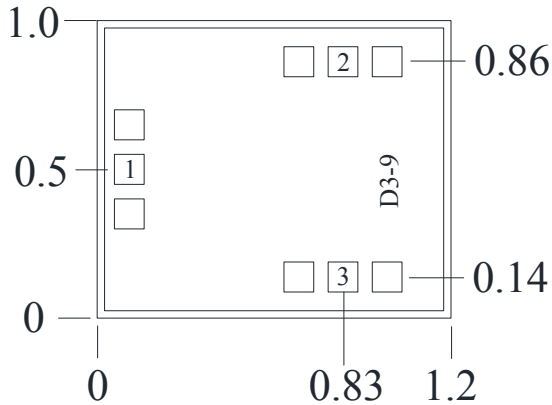


相位一致性

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65℃~+150℃
使用温度	-55℃~+125℃

外形尺寸



说明:

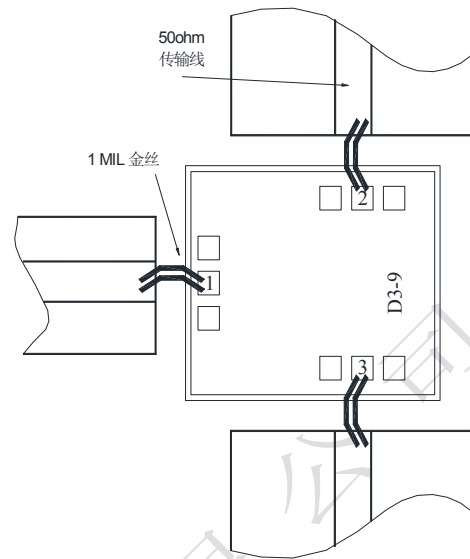
1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.10\text{mm} \times 0.10\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1	RFin	RF 输入端口, 阻抗 50ohm
2、3	RFout	RF 输出端口, 阻抗 50ohm
	GND	

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152\text{mm}$ ($3 \sim 6\text{mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔形键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: 6~18 GHz

通带损耗: 0.8 dB

隔离度: 20dB

回波损耗: -20dB

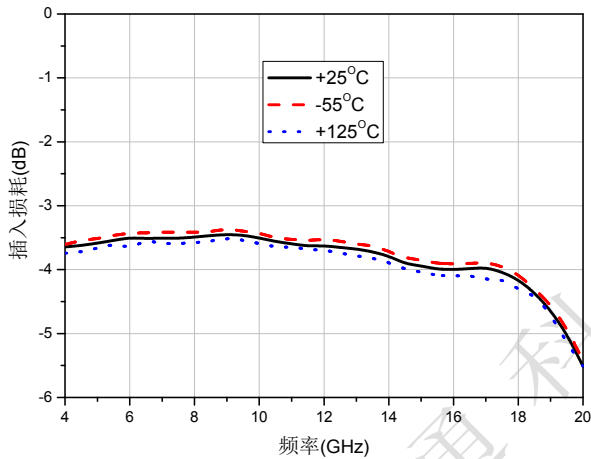
芯片尺寸: 1.0mmx0.85mm x 0.1mm

接口: 50Ω共面波导线

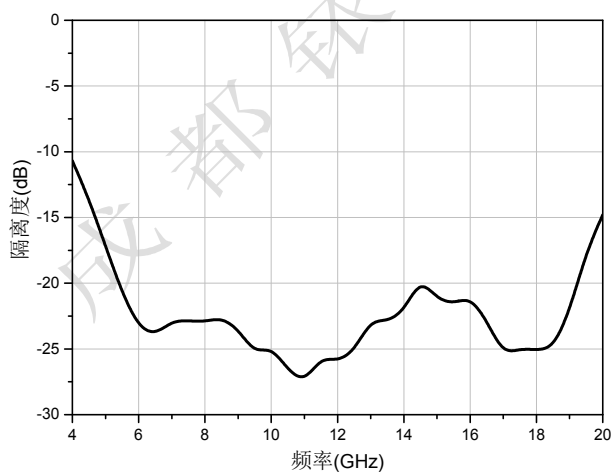
产品简介

YTGF-06/18是一款砷化镓单片功分器芯片。该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易集成、等特点, 广泛应用于功率分配及合成。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理, 适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

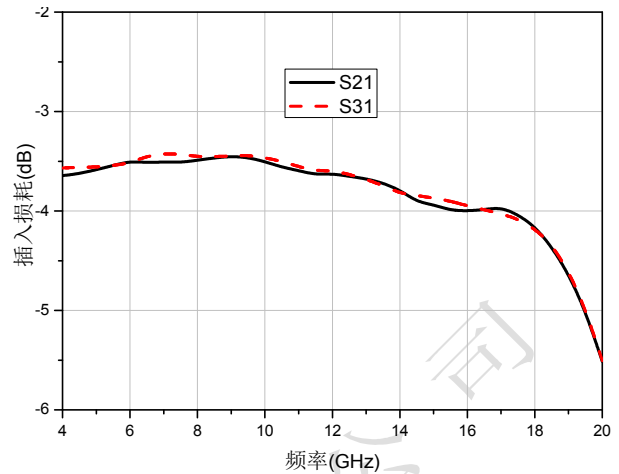
典型曲线 (T_A=+25°C)



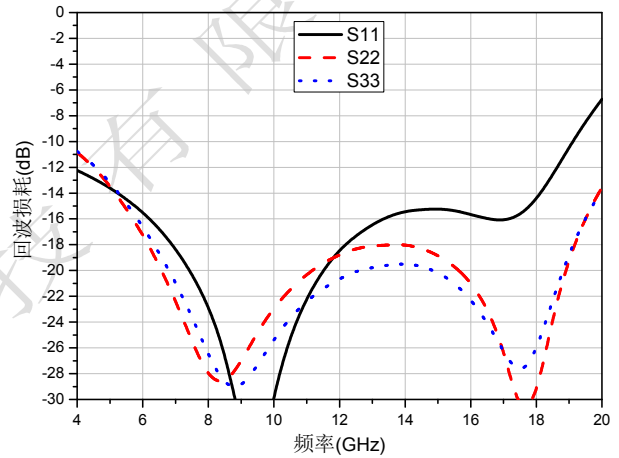
三温插入损耗



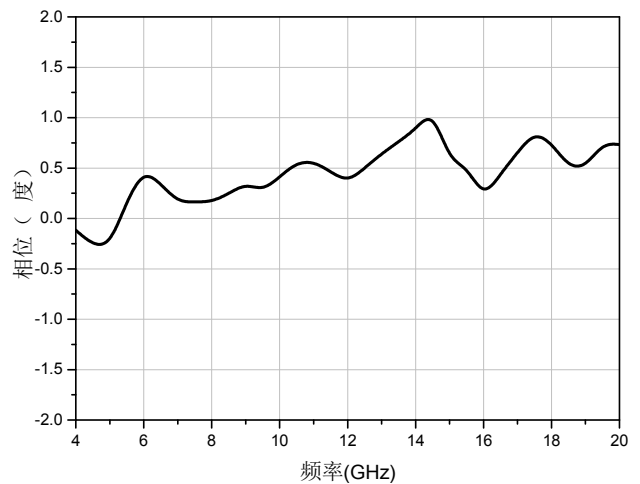
隔离度



插入损耗



回波损耗

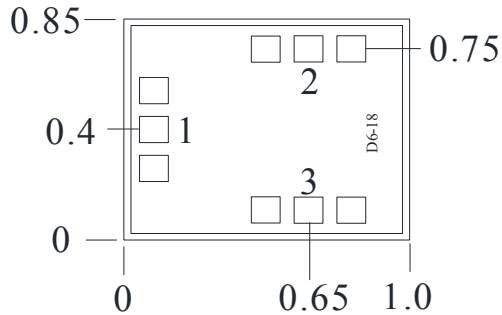


相位一致性

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65℃~+150℃
使用温度	-55℃~+125℃

外形尺寸



说明：

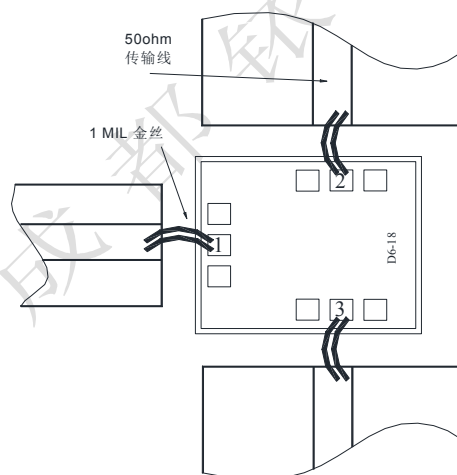
1. 单位：毫米，公差：±0.05mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金，压点尺寸：0.10mm*0.10mm
4. 不能在通孔上进行键合

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1	RFin	RF 输入端口，阻抗 50ohm
2、3	RFout	RF 输出端口，阻抗 50ohm
	GND	

应用信息

1. 装配示意图



注：陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。
常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150℃。球形键合劈刀压力 40~50gf，楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。

性能特点

通带频段: 8~12 GHz

通带损耗: 0.7 dB

隔离度: 20dB

回波损耗: -15dB

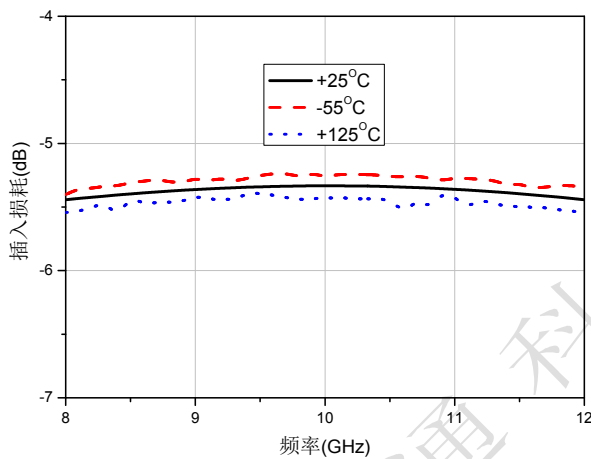
芯片尺寸: 1.5mmx1.5mm x 0.1mm

接口: 50Ω共面波导线

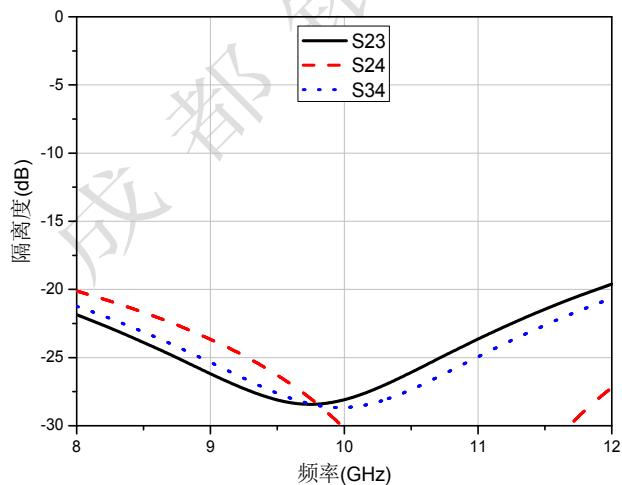
产品简介

YTGF-08/12是一款砷化镓单片三功分器芯片。该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易集成、等特点, 广泛应用于功率分配及合成。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理, 适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

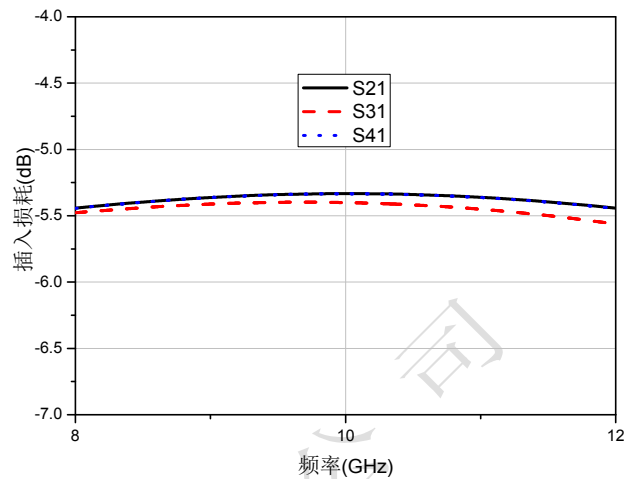
典型曲线 (T_A=+25°C)



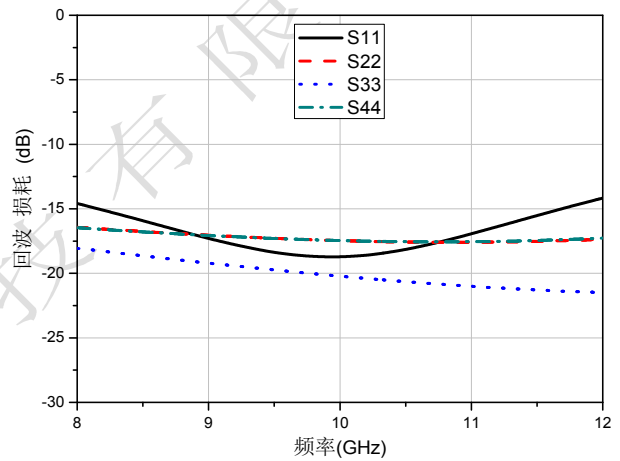
三温插入损耗



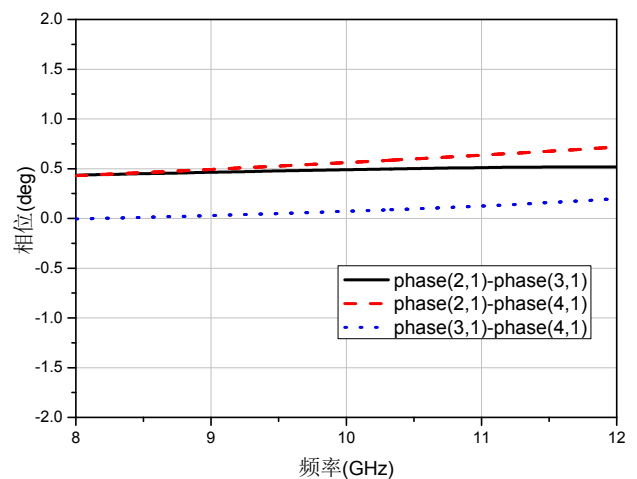
隔离度



插入损耗



回波损耗

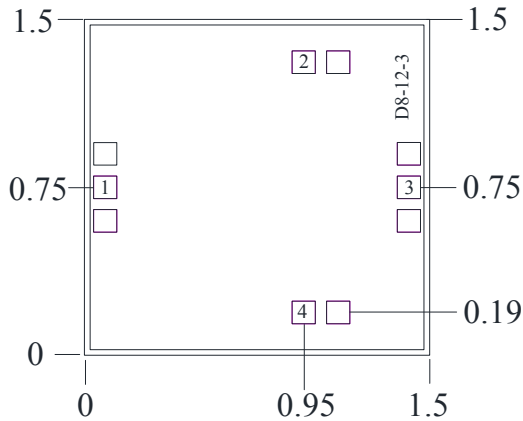


相位一致性

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65℃~+150℃
使用温度	-55℃~+125℃

外形尺寸



说明:

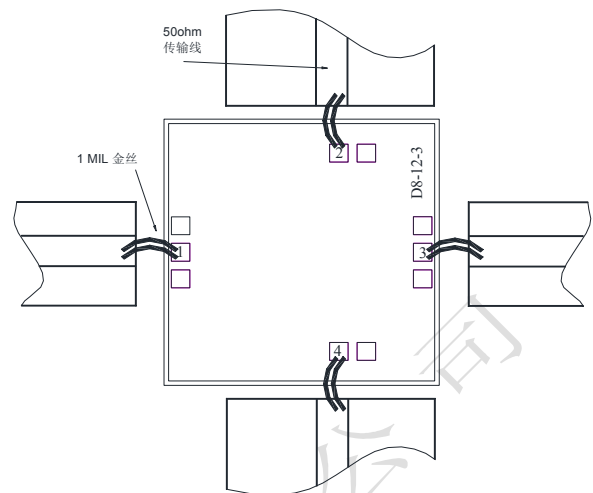
1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.10\text{mm} \times 0.10\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1	RFin	RF 输入端口, 阻抗 50ohm
2、3、4	RFout	RF 输出端口, 阻抗 50ohm
	GND	

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076\sim 0.152\text{mm}$ ($3\sim 6\text{mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40\sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18\sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: 12~18 GHz

通带损耗: 0.5 dB

隔离度: 20dB

回波损耗: -20dB

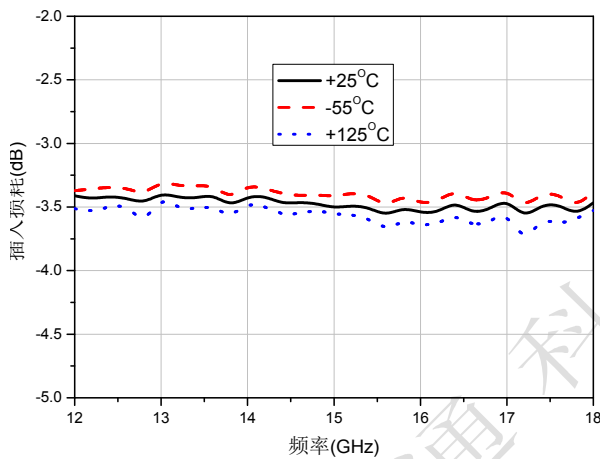
芯片尺寸: 1.5mmx1.5mm x 0.1mm

接口: 50Ω共面波导线

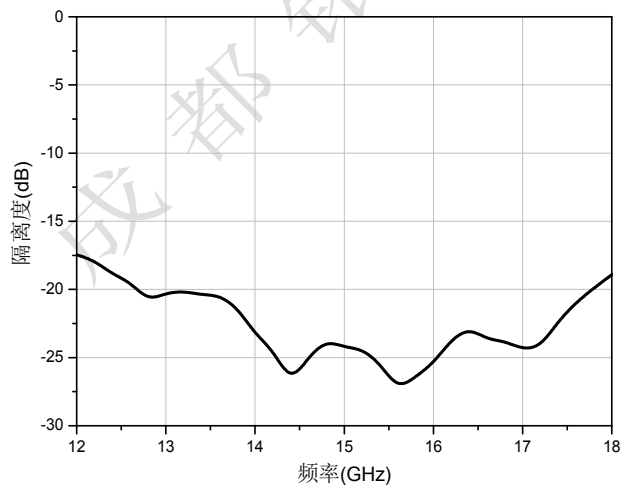
产品简介

YTGF-12/18是一款砷化镓单片二功分器芯片。该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易集成、等特点, 广泛应用于功率分配及合成。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理, 适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

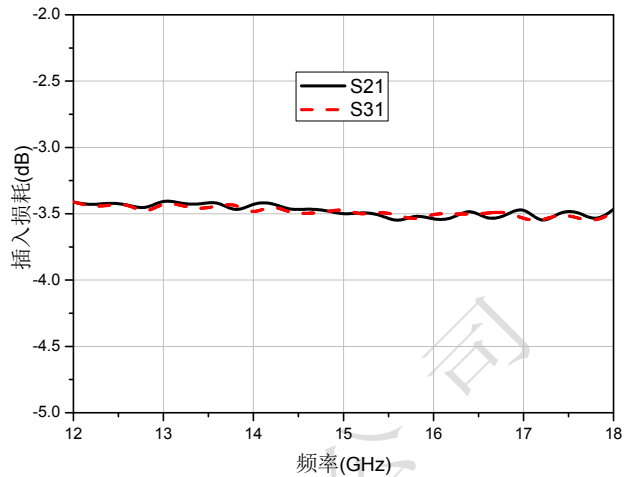
典型曲线 (T_A=+25°C)



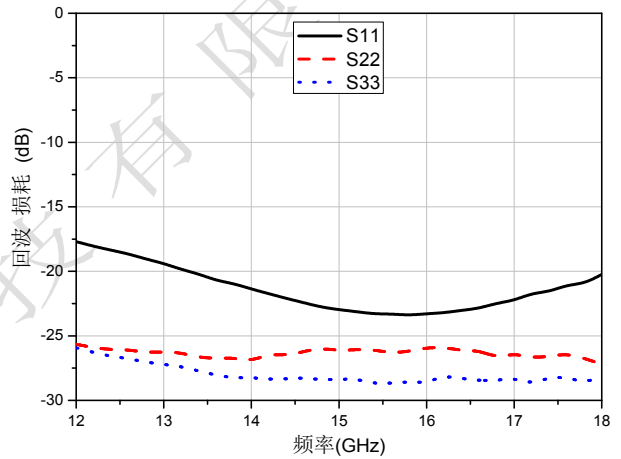
三温插入损耗



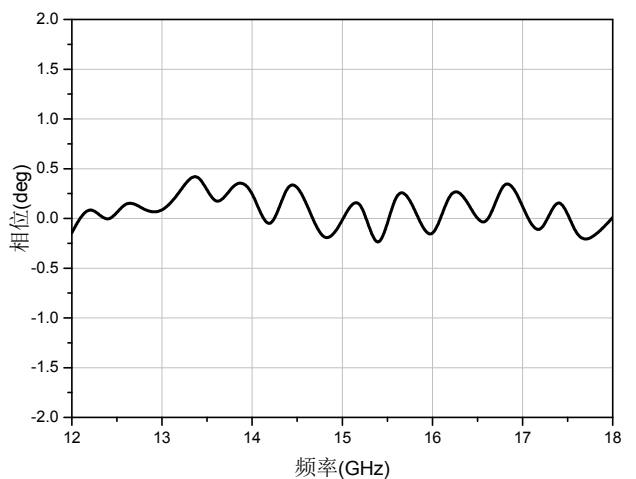
隔离度



插入损耗



回波损耗

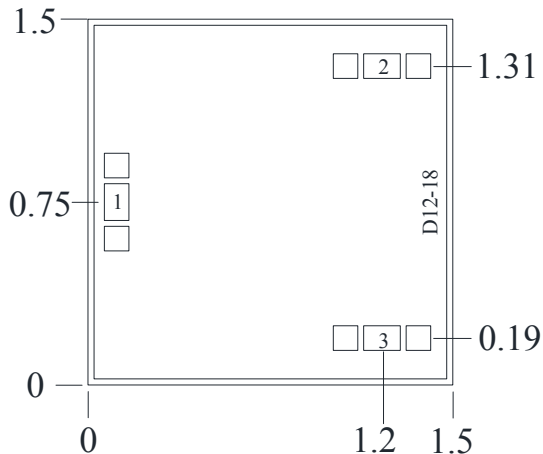


相位一致性

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65℃~+150℃
使用温度	-55℃~+125℃

外形尺寸



说明：

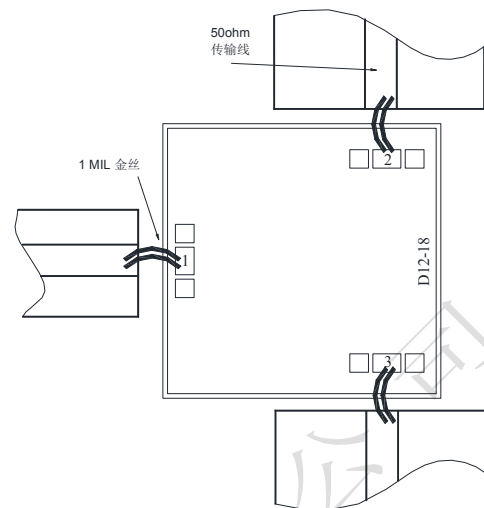
1. 单位：毫米，公差：±0.05mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金，压点尺寸：0.10mm*0.10mm
4. 不能在通孔上进行键合

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1	RFin	RF 输入端口，阻抗 50ohm
2、3	RFout	RF 输出端口，阻抗 50ohm
	GND	

应用信息

1. 装配示意图



注：陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150℃。球形键合劈刀压力 40~50gf，楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。

性能特点

通带频段: 12~26.5 GHz

通带损耗: 0.7 dB

隔离度: 20dB

回波损耗: -20dB

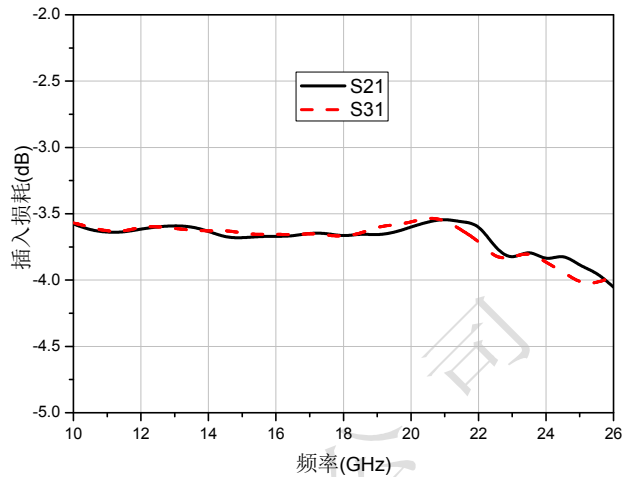
芯片尺寸: 1.5mmx2.0mm x 0.1mm

接口: 50Ω共面波导线

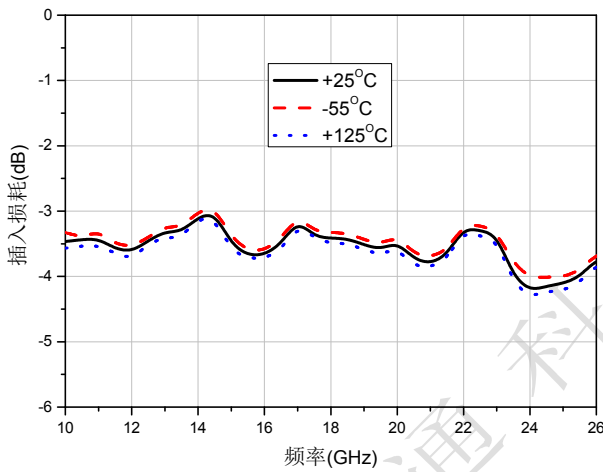
产品简介

YTGF-12/26P5是一款砷化镓单片功分器芯片。该功分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易集成、等特点, 广泛应用于功率分配及合成。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理, 适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

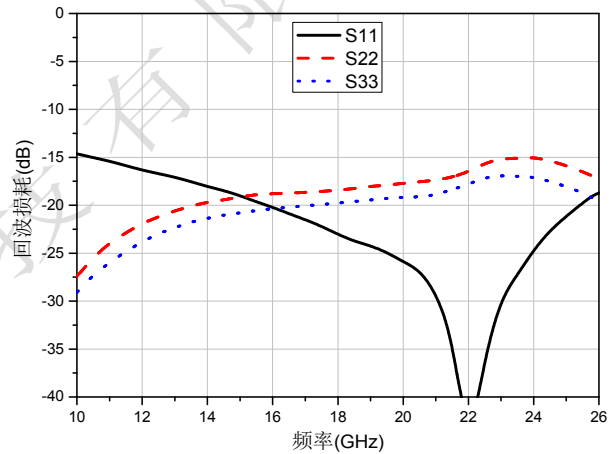
典型曲线 (T_A=+25°C)



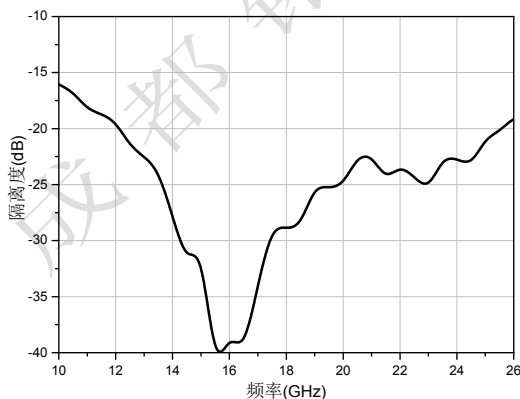
插入损耗



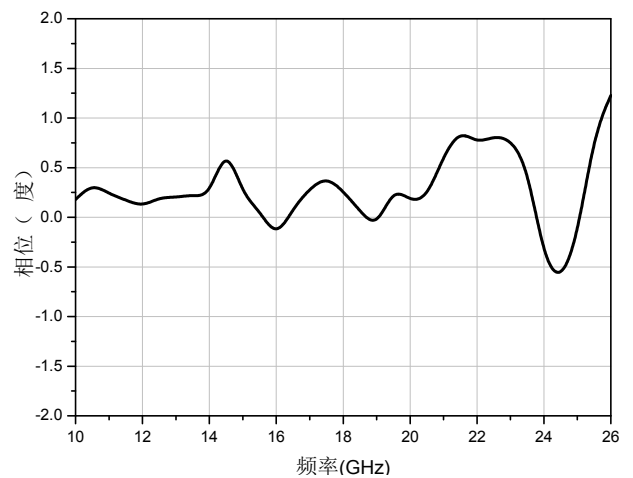
插入损耗



回波损耗



隔离度

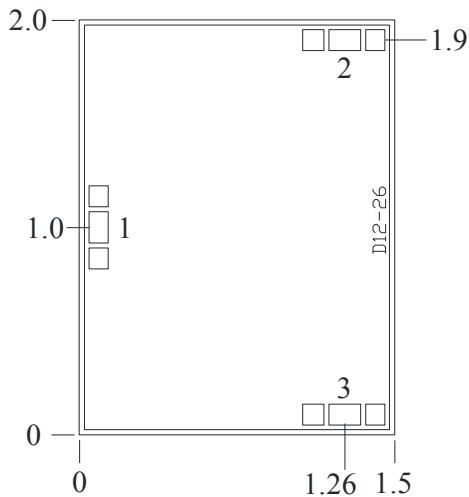


相位一致性

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65℃~+150℃
使用温度	-55℃~+125℃

外形尺寸



说明:

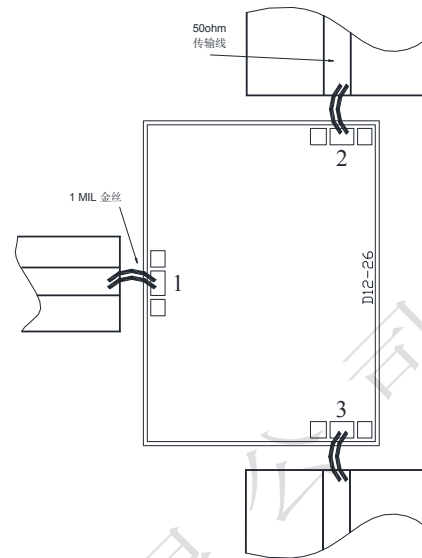
1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.15\text{mm} \times 0.10\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1	RFin	RF 输入端口, 阻抗 50ohm
2、3	RFout	RF 输出端口, 阻抗 50ohm
	GND	

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152\text{ mm}$ ($3 \sim 6\text{ mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{ gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~1GHz

通带损耗: $\leq 1.9\text{dB}$

阻带衰减: $\geq 22\text{dB}@1.6\text{GHz}$

$\geq 40\text{dB}@2.0\sim 16.0\text{GHz}$

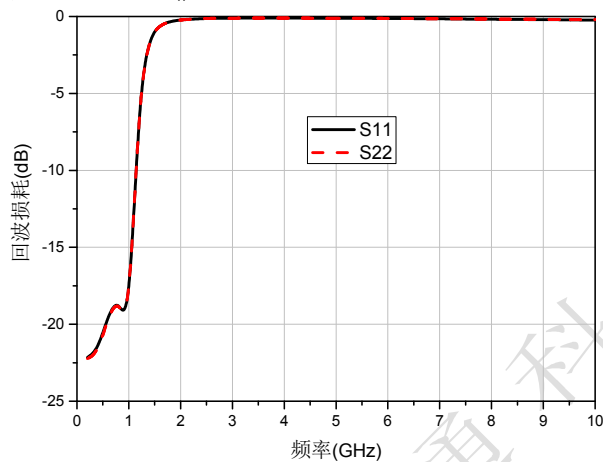
回波损耗: -20dB

接口: 50Ω共面波导线

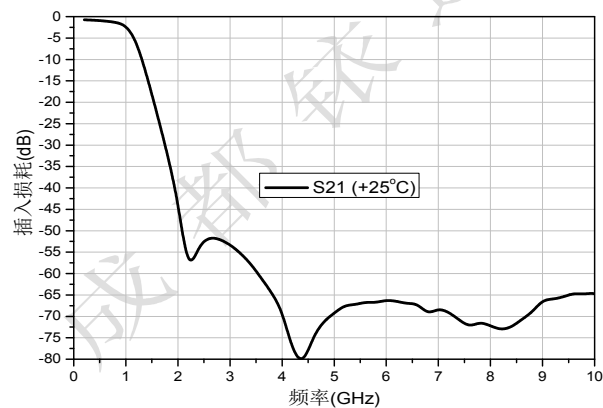
产品简介

YTLF-1T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.5mm×0.75mm×0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

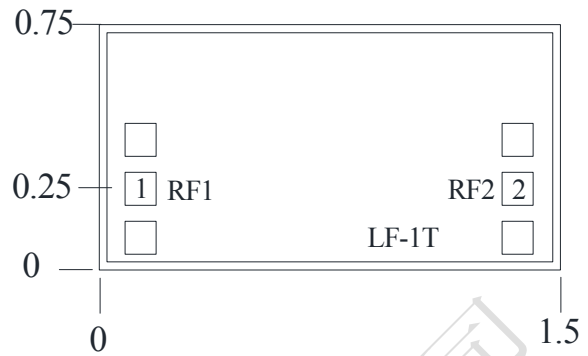


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65℃~+150℃
使用温度	-55℃~+125℃

外形尺寸

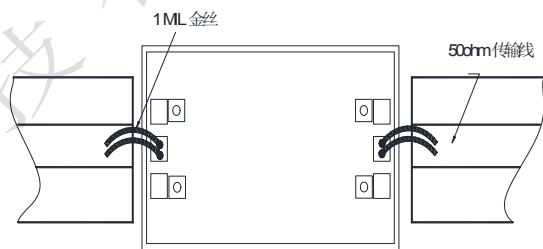


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076\sim 0.152\text{mm}$ (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40\sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18\sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~1.5GHz

通带损耗: $\leq 1.5\text{dB}$

阻带衰减: $\geq 22\text{dB}@2.3\text{GHz}$

$\geq 40\text{dB}@2.6\sim 11.0\text{GHz}$

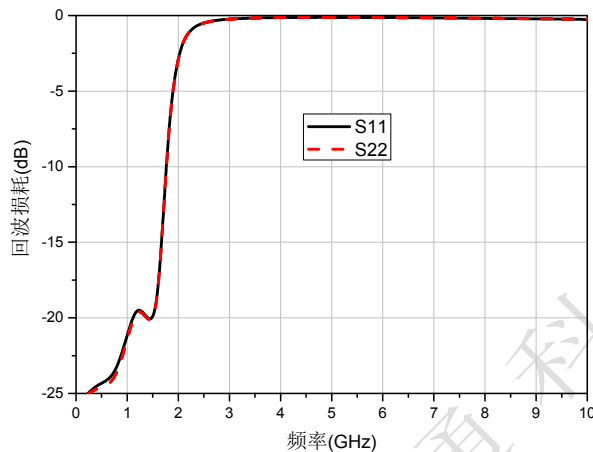
回波损耗: -20dB

接口: 50Ω 共面波导线

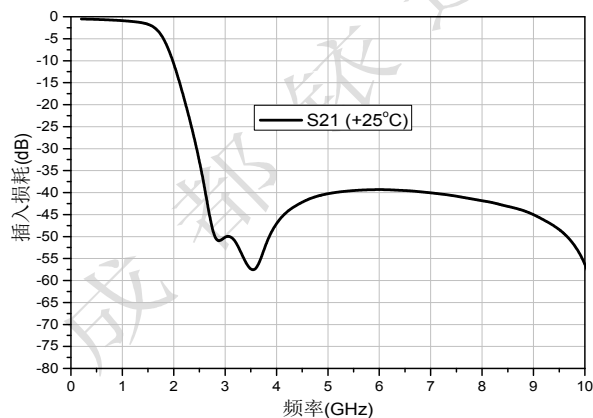
产品简介

YTLF-1P5T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。芯片尺寸 $1.5\text{mm}\times 0.75\text{mm}\times 0.1\text{mm}$ 。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

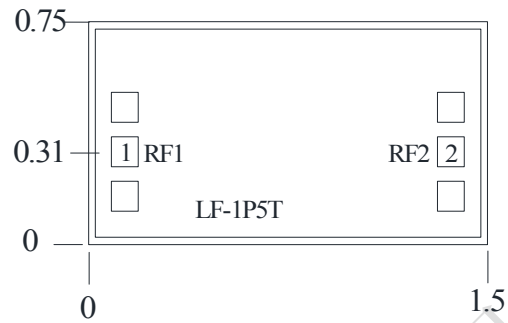


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C}\sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C}\sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

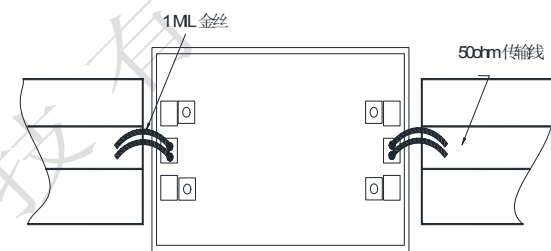


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm}\times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076\sim 0.152\text{mm}$ ($3\sim 6\text{ mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40\sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18\sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~2.0GHz

通带损耗: $\leq 1.4\text{dB}$

阻带衰减: $\geq 22\text{dB}@2.3\text{GHz}$

$\geq 40\text{dB}@2.6\text{--}11.0\text{GHz}$

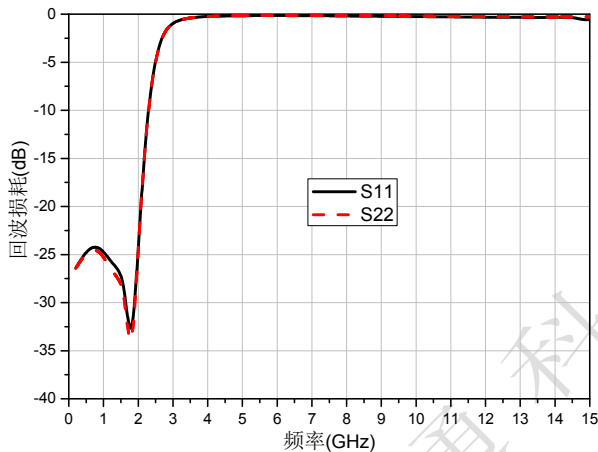
回波损耗: -20dB

接口: 50Ω共面波导线

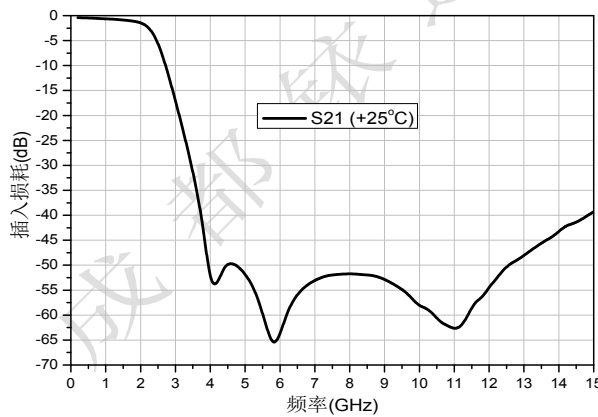
产品简介

YTLF-2T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

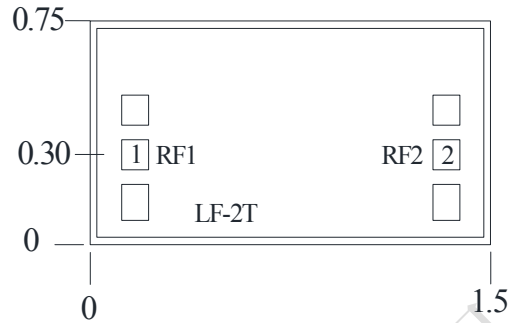


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65℃~+150℃
使用温度	-55℃~+125℃

外形尺寸

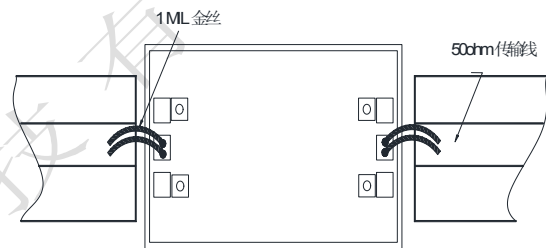


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076\text{--}0.152\text{ mm}$ ($3\text{--}6\text{ mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40\text{--}50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18\text{--}22\text{ gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~2.5GHz

通带损耗: $\leq 1.4\text{dB}$

阻带衰减: $\geq 22\text{dB}@3.9\text{GHz}$

$\geq 40\text{dB}@4.8\sim 20.0\text{GHz}$

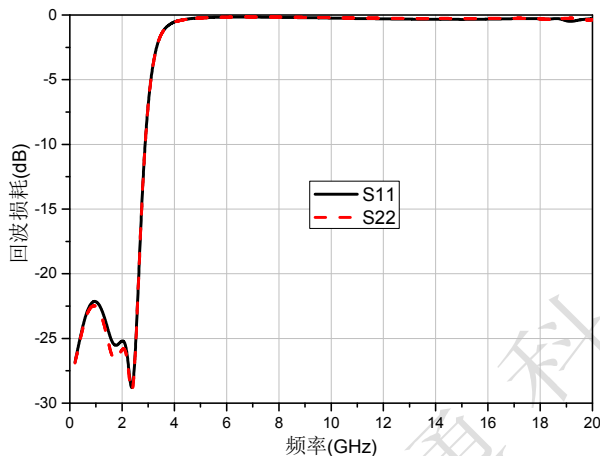
回波损耗: -20dB

接口: 50Ω共面波导线

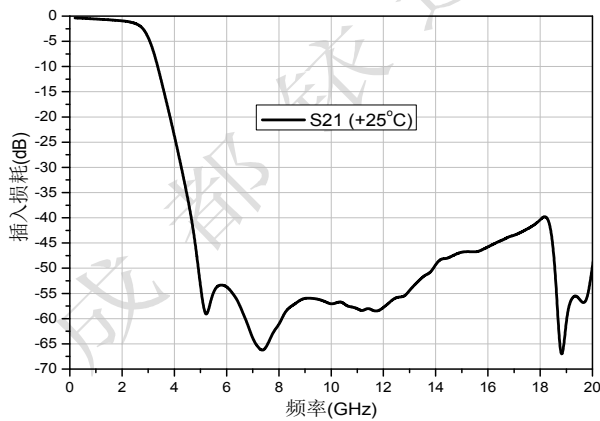
产品简介

YTLF-2P5T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

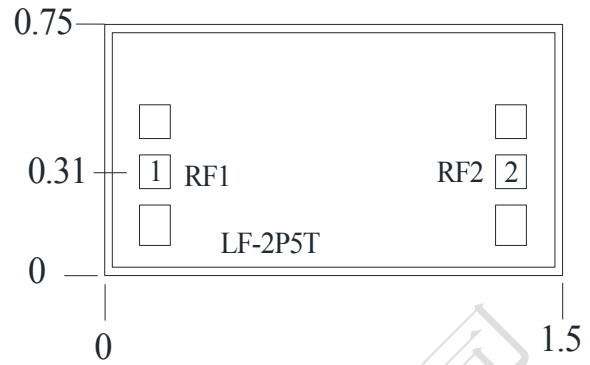


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C~+150°C
使用温度	-55°C~+125°C

外形尺寸

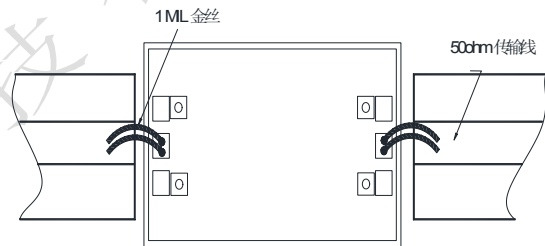


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076\sim 0.152\text{mm}$ (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40\sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18\sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: DC~3.0GHz

通带损耗: ≤ 1.2 dB

阻带衰减: ≥ 22 dB@4.6GHz

≥ 40 dB@5.2~17.0GHz

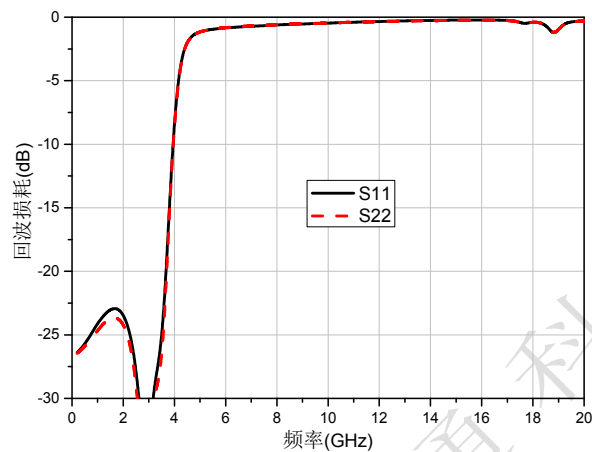
回波损耗: -20 dB

接口: 50Ω共面波导线

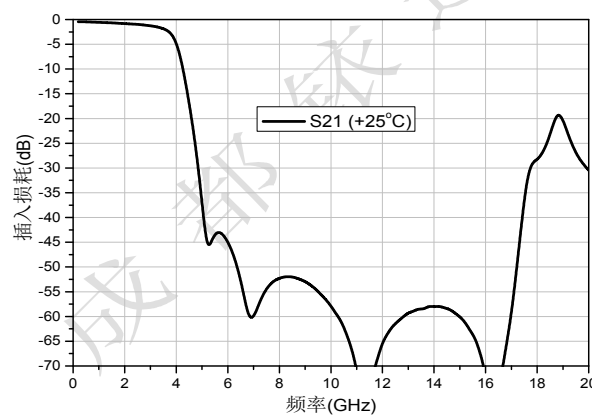
产品简介

YTLF-3T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.5mm×0.75mm×0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

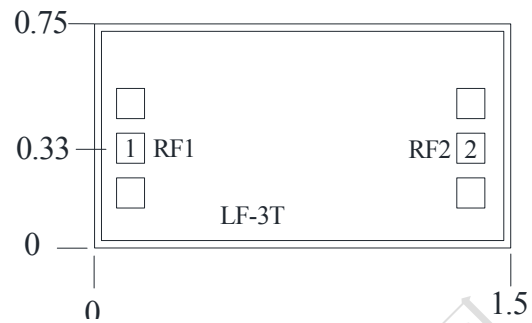


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65℃~+150℃
使用温度	-55℃~+125℃

外形尺寸

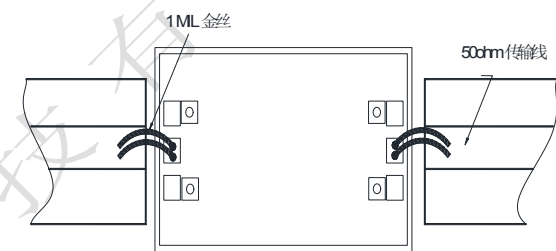


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152$ mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: DC~3.50GHz

通带损耗: $\leq 1.3\text{dB}$

阻带衰减: $\geq 23\text{dB}@5.2\text{GHz}$

$\geq 40\text{dB}@6.2\sim 30.0\text{GHz}$

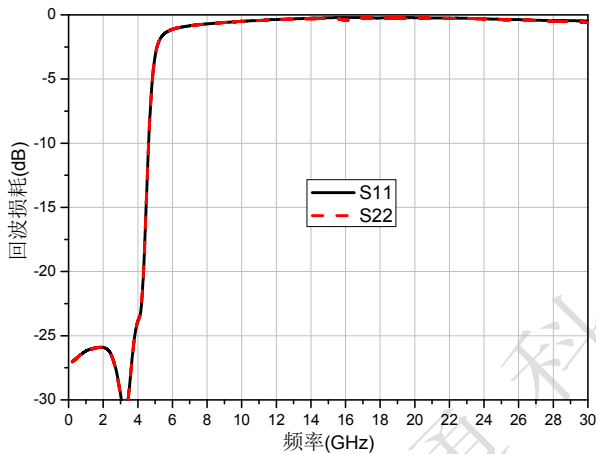
回波损耗: -25dB

接口: 50 Ω 共面波导线

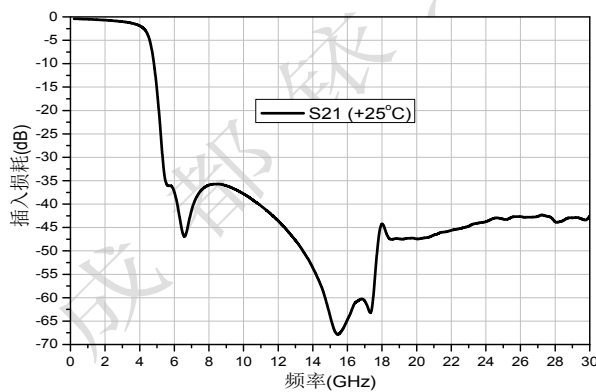
产品简介

YTLF-3P5T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.5mmx0.70mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

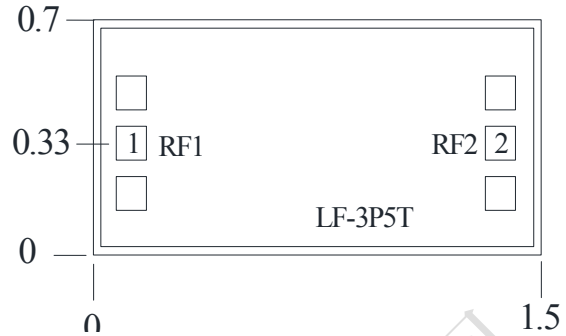


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65 $^\circ\text{C}$ ~+150 $^\circ\text{C}$
使用温度	-55 $^\circ\text{C}$ ~+125 $^\circ\text{C}$

外形尺寸

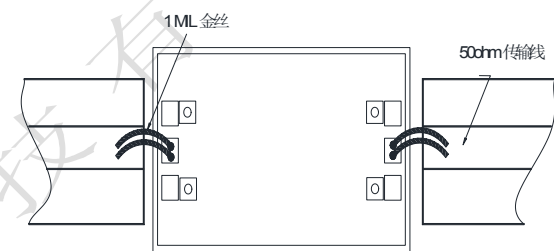


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076\sim 0.152\text{mm}$ ($3\sim 6\text{mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40\sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18\sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~4.0GHz

通带损耗: $\leq 1.8\text{dB}$

阻带衰减: $\geq 23\text{dB}@5.6\text{GHz}$

$\geq 40\text{dB}@6.8\sim 30.0\text{GHz}$

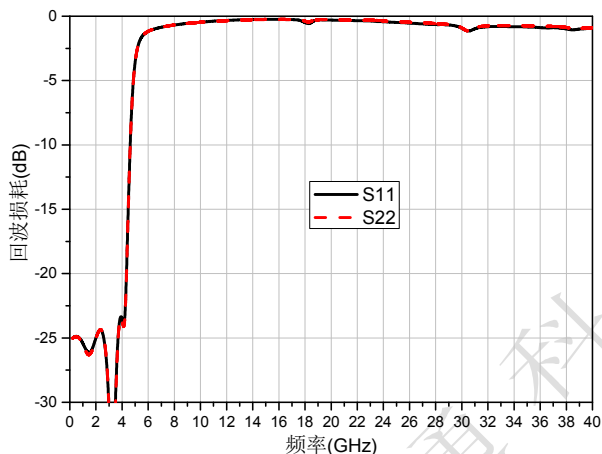
回波损耗: -21dB

接口: 50Ω共面波导线

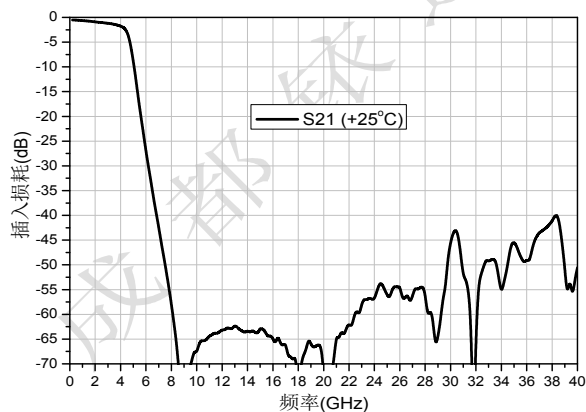
产品简介

YTLF-4是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.5mm×0.70mm×0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

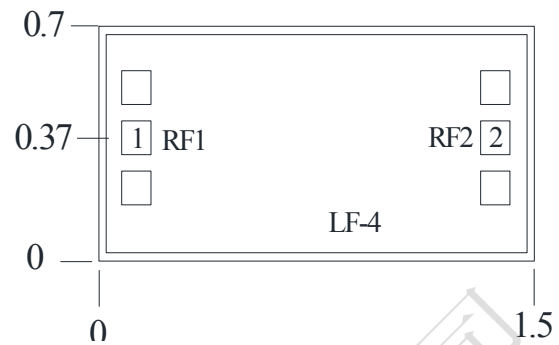


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C~+150°C
使用温度	-55°C~+125°C

外形尺寸

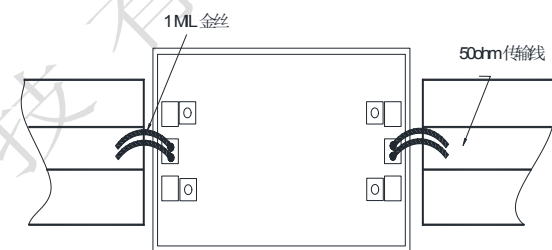


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076\sim 0.152\text{mm}$ ($3\sim 6\text{mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40\sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18\sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: DC~4.0GHz

通带损耗: $\leq 1.7\text{dB}$

阻带衰减: $\geq 23\text{dB}@5.2\text{GHz}$

$\geq 40\text{dB}@6.2\sim 19.0\text{GHz}$

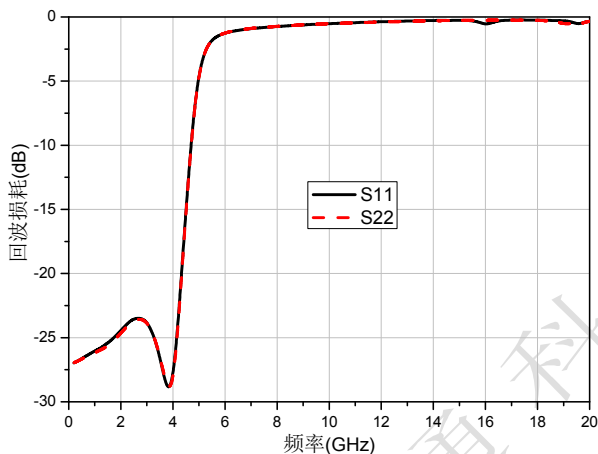
回波损耗: -23dB

接口: 50Ω共面波导线

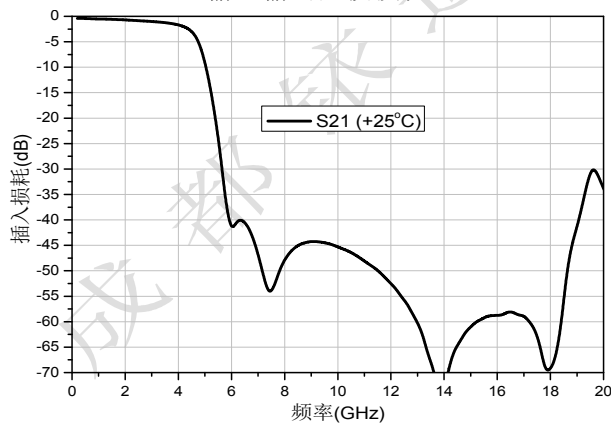
产品简介

YTLF-4T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.5mm×0.70mm×0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

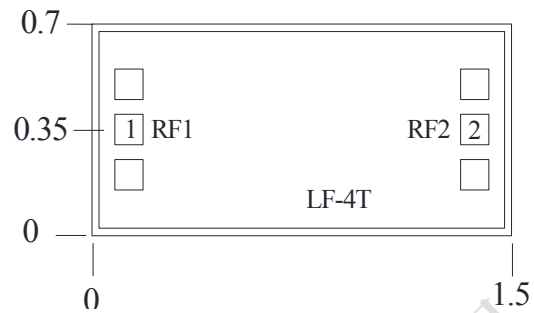


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65℃~+150℃
使用温度	-55℃~+125℃

外形尺寸

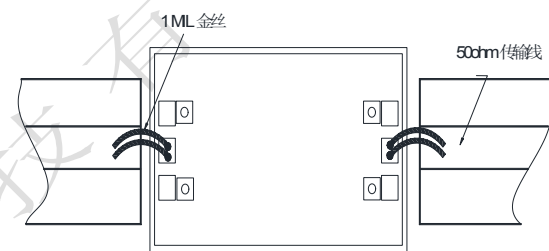


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076\sim 0.152\text{mm}$ ($3\sim 6\text{mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40\sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18\sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~5.0GHz

通带损耗: $\leq 1.2\text{dB}$

阻带衰减: $\geq 23\text{dB}@6.9\text{GHz}$

$\geq 40\text{dB}@7.5\sim 20.0\text{GHz}$

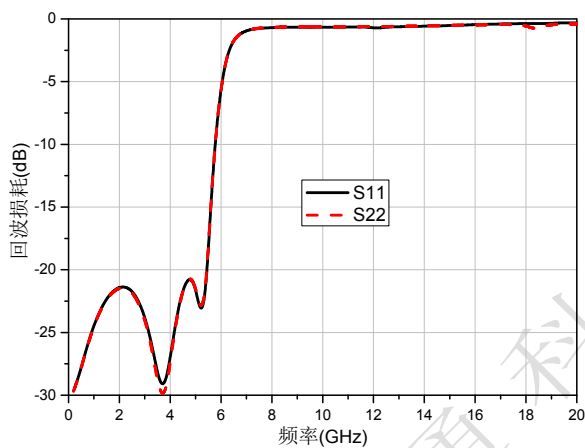
回波损耗: -22dB

接口: 50Ω共面波导线

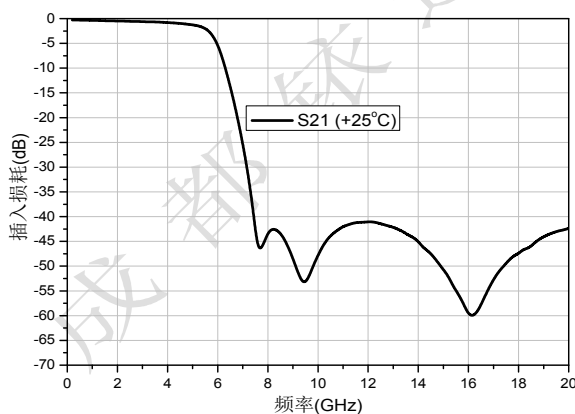
产品简介

YTLF-5T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.5mmx0.70mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

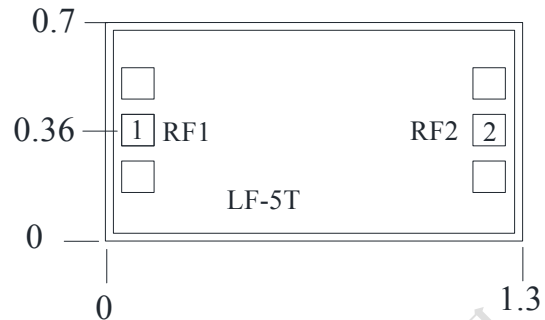


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C~+150°C
使用温度	-55°C~+125°C

外形尺寸

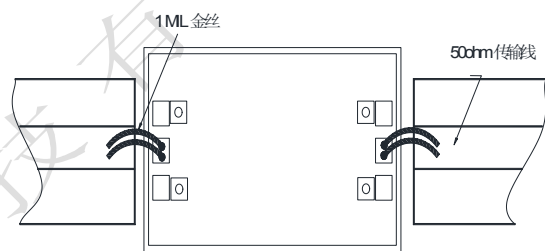


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076\sim 0.152\text{mm}$ ($3\sim 6\text{mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40\sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18\sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~6.0GHz

通带损耗: $\leq 1.4\text{dB}$

阻带衰减: $\geq 23\text{dB}@8.4\text{GHz}$

$\geq 40\text{dB}@10\text{--}40.0\text{GHz}$

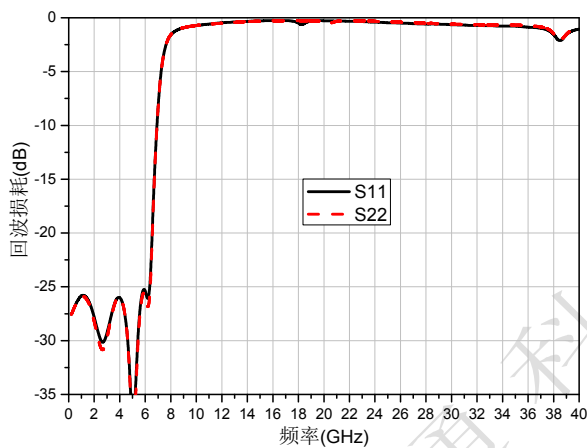
回波损耗: -20dB

接口: 50Ω共面波导线

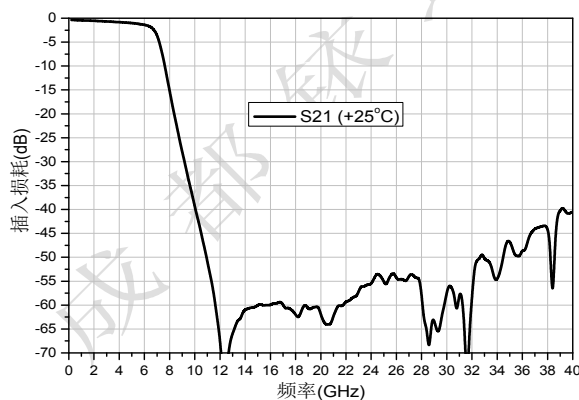
产品简介

YTLF-6是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.5mm×0.70mm×0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

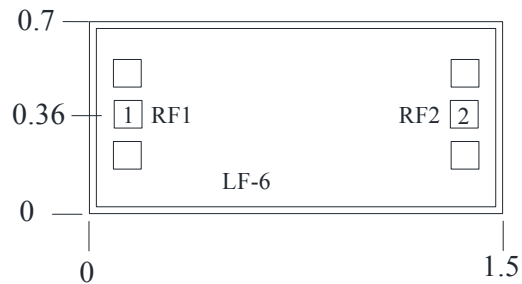


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65℃~+150℃
使用温度	-55℃~+125℃

外形尺寸

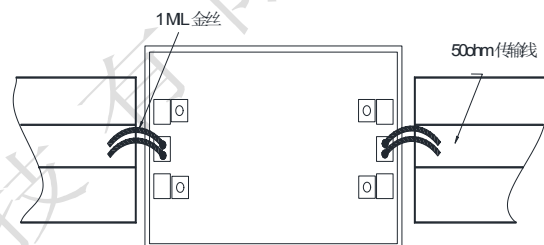


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076\text{--}0.152\text{ mm}$ (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40\text{--}50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18\text{--}22\text{ gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~6.0GHz

通带损耗: $\leq 1.7\text{dB}$

阻带衰减: $\geq 23\text{dB}@7.7\text{GHz}$

$\geq 40\text{dB}@8.3\sim 23.0\text{GHz}$

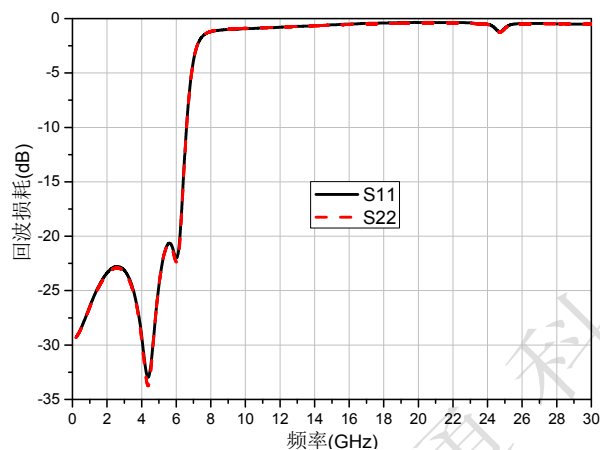
回波损耗: -22dB

接口: 50 Ω 共面波导线

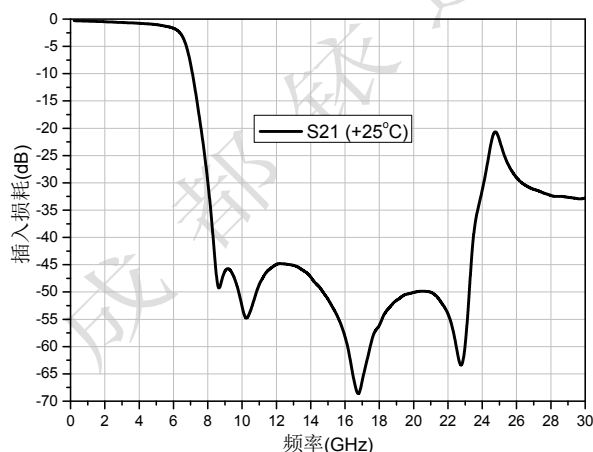
产品简介

YTLF-6T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.3mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

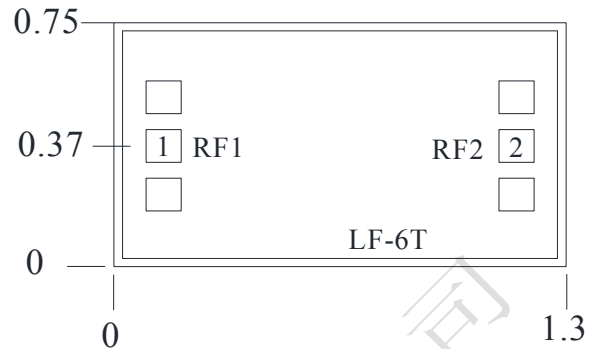


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65 $^\circ\text{C}$ ~+150 $^\circ\text{C}$
使用温度	-55 $^\circ\text{C}$ ~+125 $^\circ\text{C}$

外形尺寸

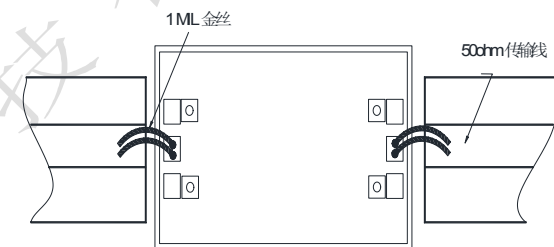


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076\sim 0.152\text{mm}$ ($3\sim 6\text{mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40\sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18\sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~7.0GHz

通带损耗: ≤ 1.6 dB

阻带衰减: ≥ 23 dB@9.5GHz

≥ 40 dB@11.4GHz

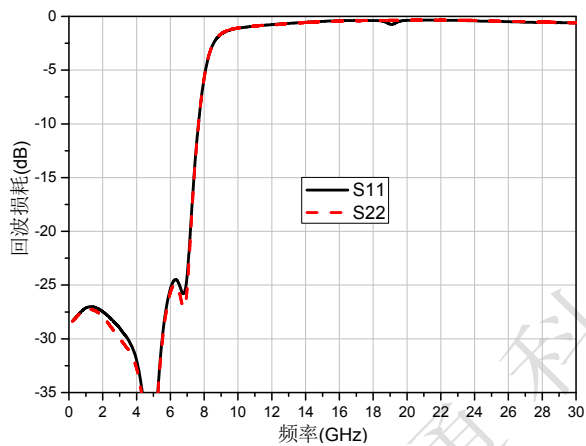
回波损耗: -22 dB

接口: 50 Ω 共面波导线

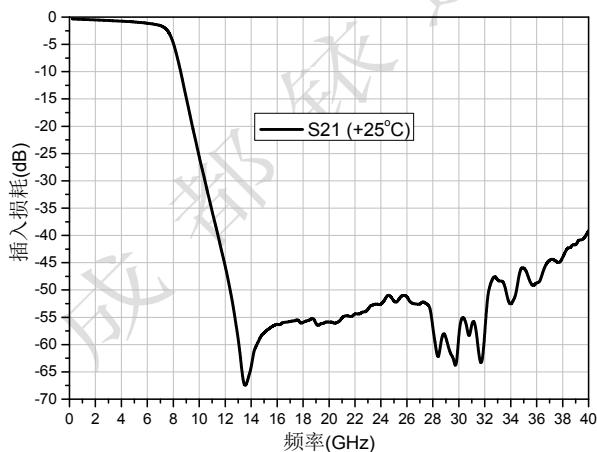
产品简介

YTLF-7是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.5mmx0.70mm x 0.1mm。

典型曲线 (T_A=+25°C)



输入输出回波损耗

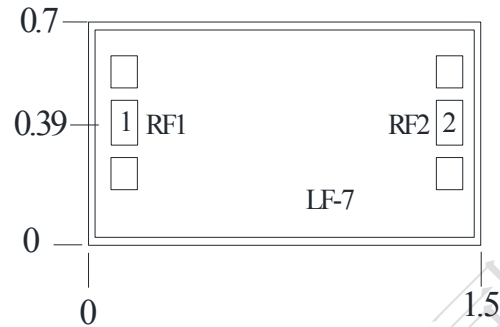


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C~+150°C
使用温度	-55°C~+125°C

外形尺寸

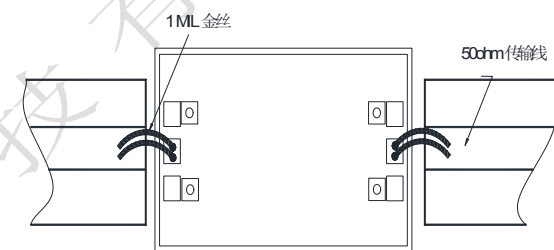


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: DC~8.0GHz

通带损耗: $\leq 1.8\text{dB}$

阻带衰减: $\geq 23\text{dB}@10.3\text{GHz}$
 $\geq 40\text{dB}@12.3\text{GHz}$

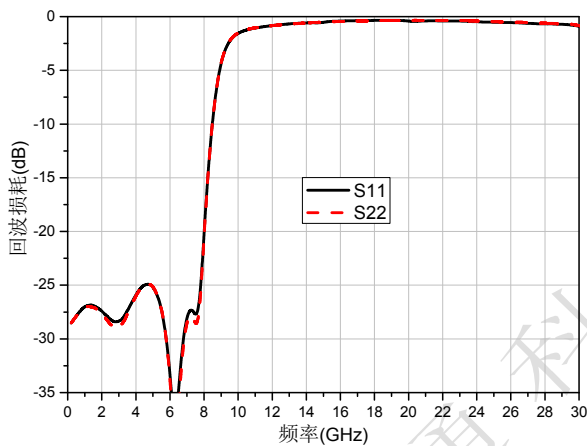
回波损耗: -20dB

接口: 50Ω共面波导线

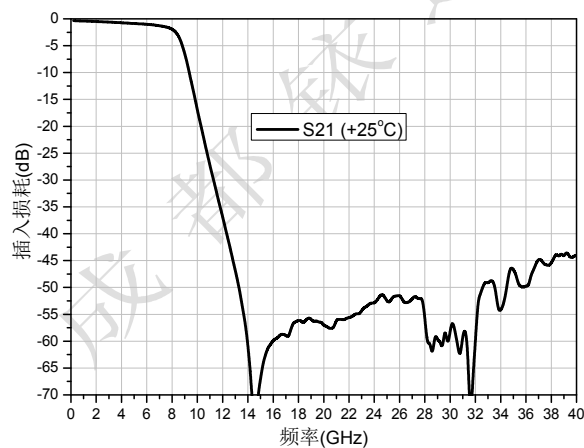
产品简介

YTLF-8是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.5mmx0.70mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

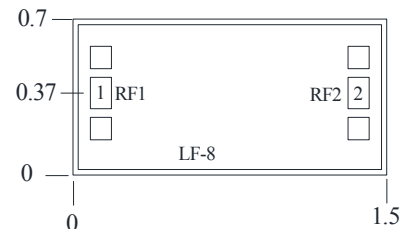


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65℃~+150℃
使用温度	-55℃~+125℃

外形尺寸

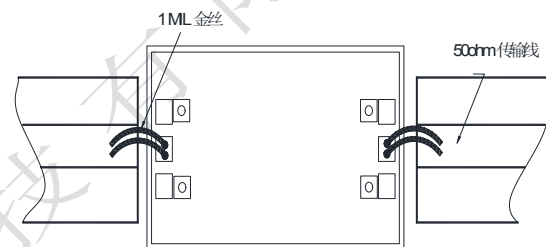


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076\sim 0.152\text{mm}$ ($3\sim 6\text{mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40\sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18\sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~9.0GHz

通带损耗: $\leq 1.6\text{dB}$

阻带衰减: $\geq 20\text{dB}@12.3\text{GHz}$

$\geq 40\text{dB}@14.6\text{GHz}$

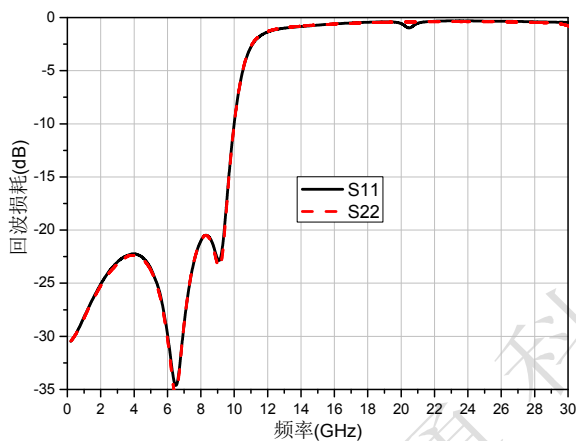
回波损耗: -20dB

接口: 50Ω共面波导线

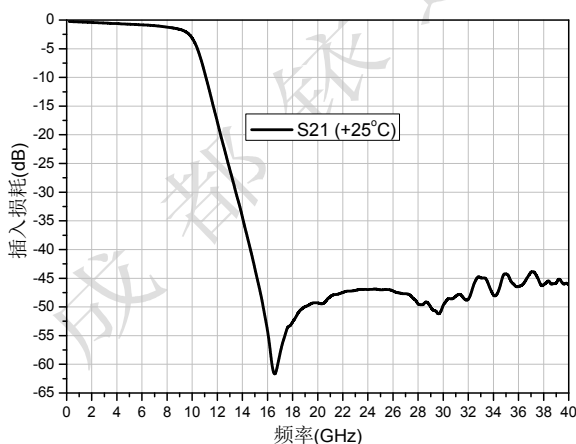
产品简介

YTLF-9是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.2mmx0.70mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

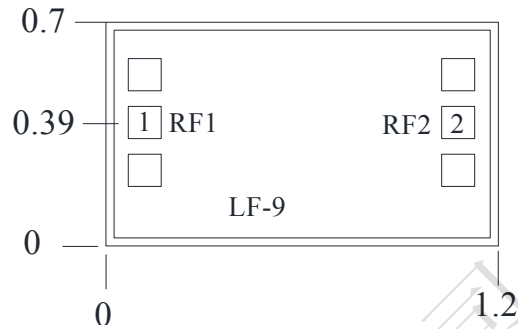


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C ~ +150°C
使用温度	-55°C ~ +125°C

外形尺寸

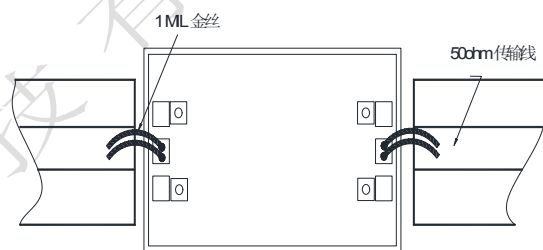


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152\text{ mm}$ ($3 \sim 6\text{ mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{ gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~10.0GHz

通带损耗: $\leq 2.1\text{dB}$

阻带衰减: $\geq 20\text{dB}@12.5\text{GHz}$

$\geq 40\text{dB}@14.8\text{GHz}$

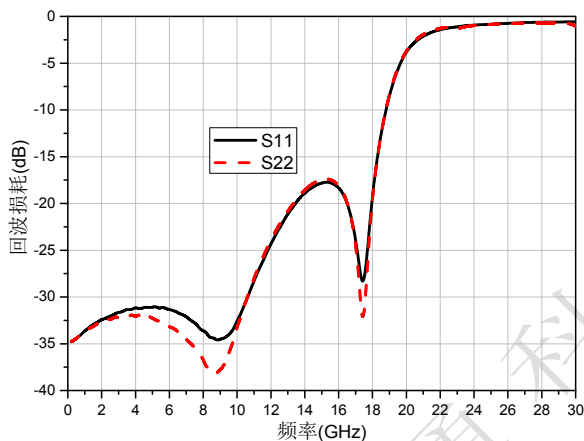
回波损耗: -20dB

接口: 50Ω共面波导线

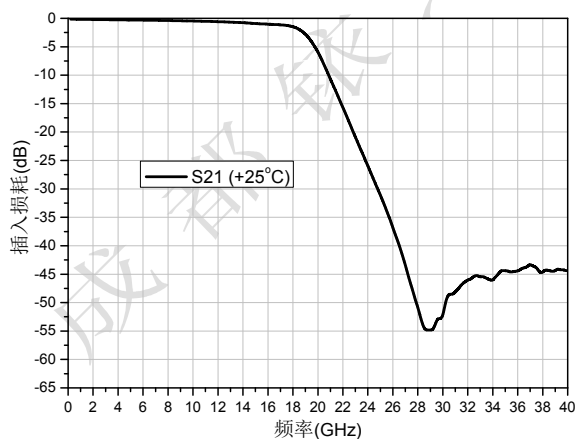
产品简介

YTLF-10是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.3mm×0.70mm×0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

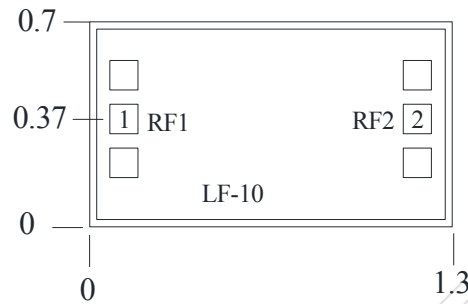


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65℃~+150℃
使用温度	-55℃~+125℃

外形尺寸

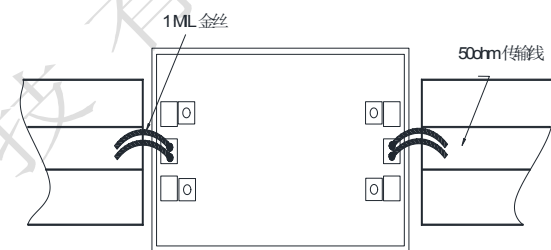


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076\sim 0.152\text{mm}$ ($3\sim 6\text{mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40\sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18\sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~12.0GHz

通带损耗: $\leq 2.5\text{dB}$

阻带衰减: $\geq 20\text{dB}@14.7\text{GHz}$

$\geq 40\text{dB}@17.2\text{GHz}$

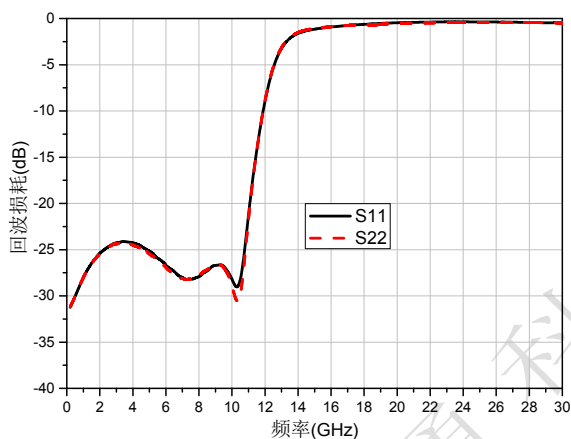
回波损耗: -20dB

接口: 50Ω共面波导线

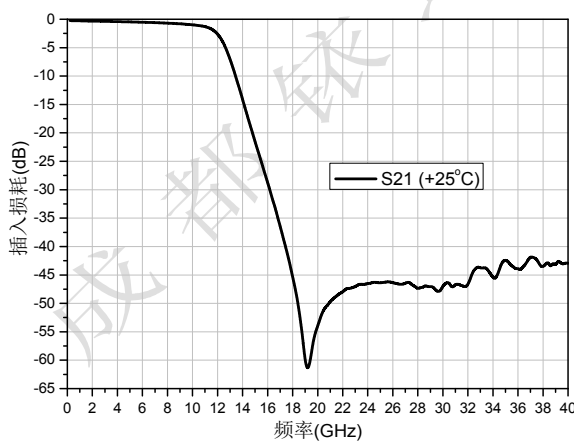
产品简介

YTLF-12是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.3mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

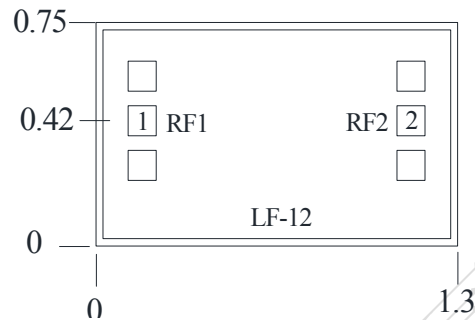


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C~+150°C
使用温度	-55°C~+125°C

外形尺寸

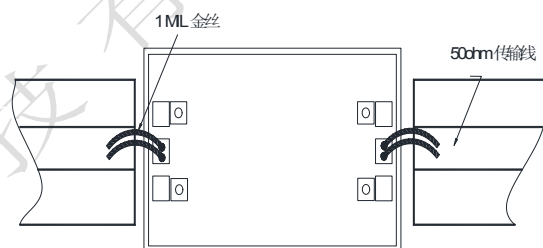


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076\sim 0.152\text{mm}$ ($3\sim 6\text{mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40\sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18\sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~14.0GHz

通带损耗: $\leq 2.1\text{dB}$

阻带衰减: $\geq 20\text{dB}@17.3\text{GHz}$

$\geq 40\text{dB}@20.2\text{GHz}$

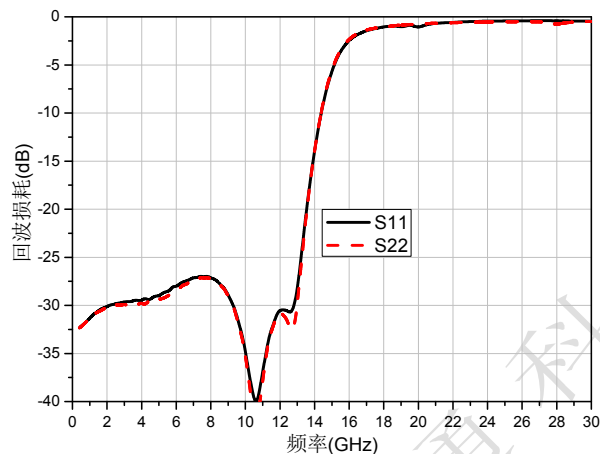
回波损耗: -20dB

接口: 50 Ω 共面波导线

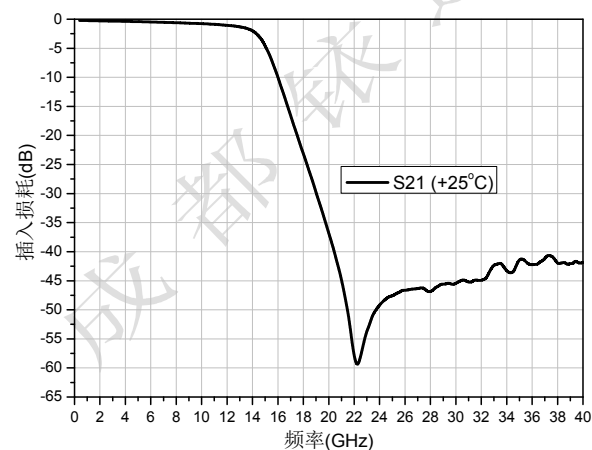
产品简介

YTLF-14是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.2mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

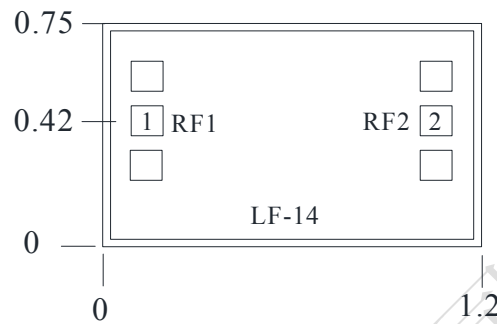


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65 $^\circ\text{C}$ ~+150 $^\circ\text{C}$
使用温度	-55 $^\circ\text{C}$ ~+125 $^\circ\text{C}$

外形尺寸

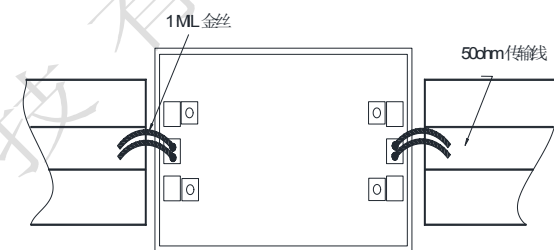


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152\text{ mm}$ ($3 \sim 6\text{ mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{ gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~16.0GHz

通带损耗: $\leq 2.5\text{dB}$

阻带衰减: $\geq 20\text{dB}@19.5\text{GHz}$

$\geq 40\text{dB}@22.7\text{GHz}$

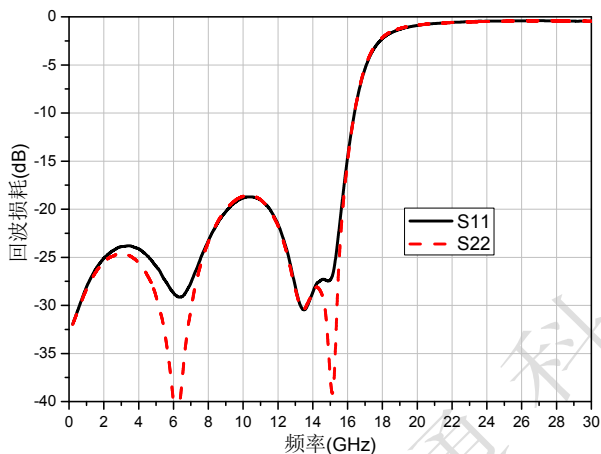
回波损耗: -21dB

接口: 50Ω共面波导线

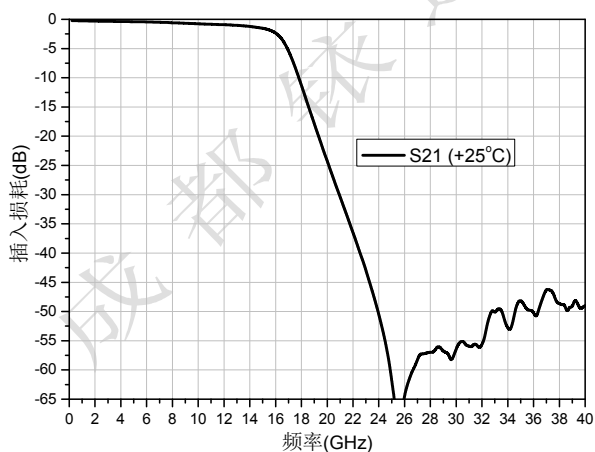
产品简介

YTLF-16是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.0mmx0.5mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

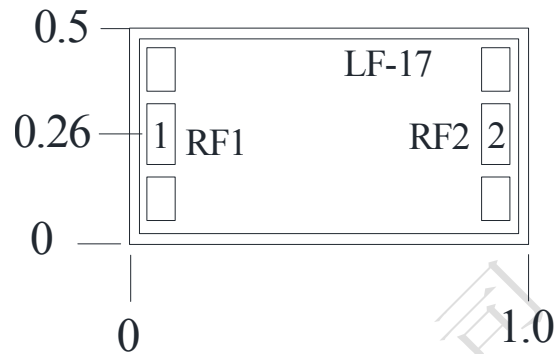


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

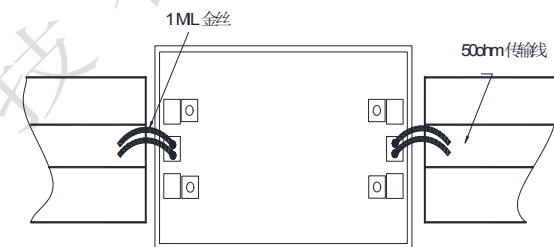


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152\text{ mm}$ ($3 \sim 6\text{ mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{ gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~19.0GHz

通带损耗: ≤ 2.5 dB

阻带衰减: ≥ 20 dB@22.7GHz

≥ 40 dB@26.5GHz

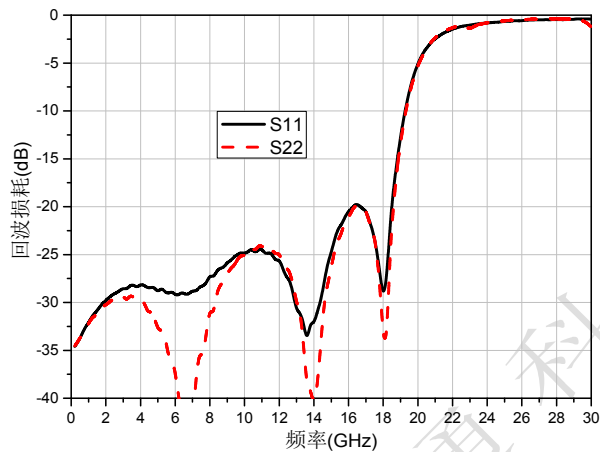
回波损耗: -20 dB

接口: 50 Ω 共面波导线

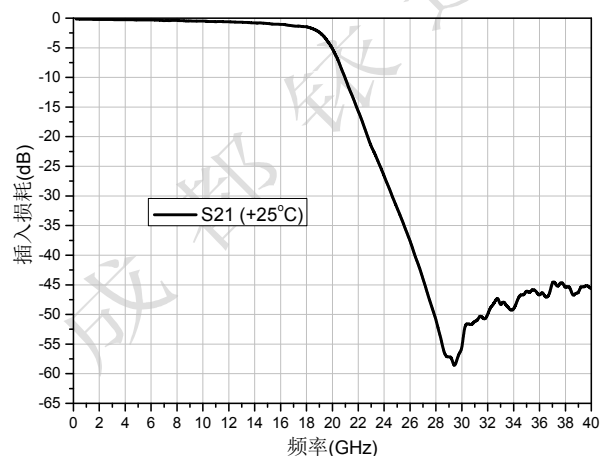
产品简介

YTLF-19是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.2mmx0.7mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

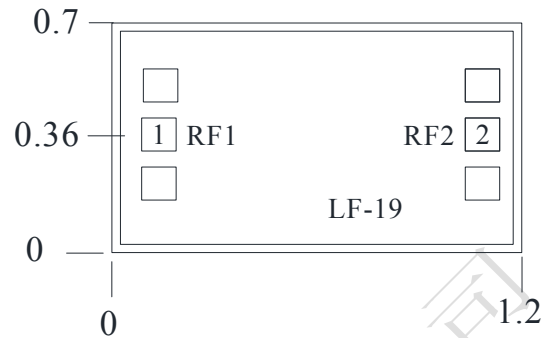


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

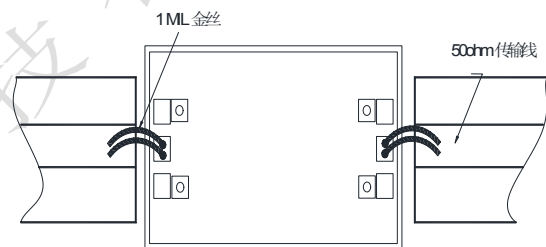


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: 2~18 GHz

通带损耗: ≤ 2.4 dB

阻带衰减: ≥ 20 dB@1.5 GHz

≥ 40 dB@1.45 GHz

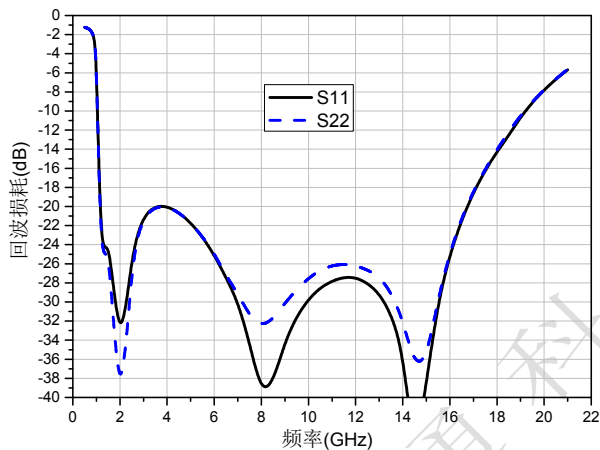
回波损耗: -20 dB

接口: 50 Ω 共面波导线

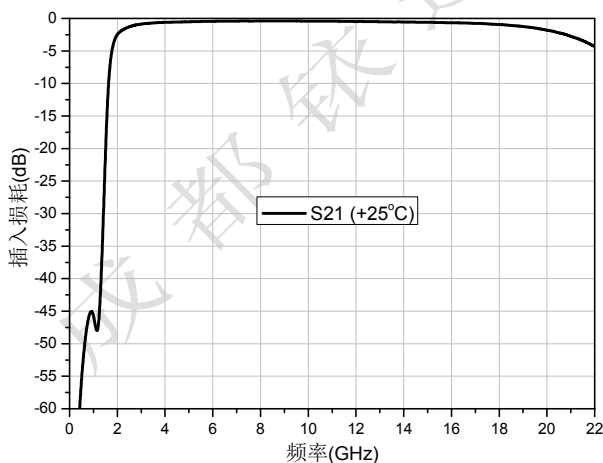
产品简介

YTHF-2T是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

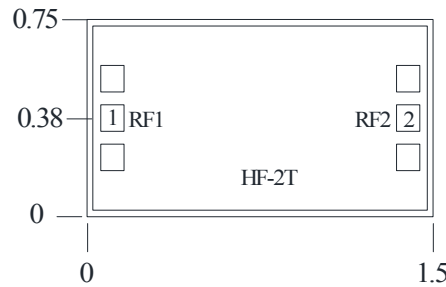


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65 $^\circ\text{C}$ ~+150 $^\circ\text{C}$
使用温度	-55 $^\circ\text{C}$ ~+125 $^\circ\text{C}$

外形尺寸

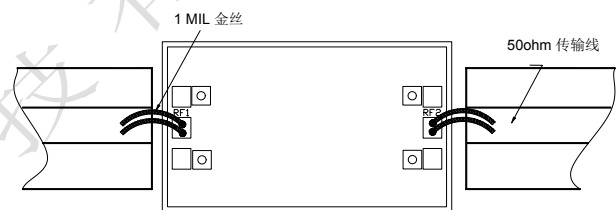


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150 $^\circ\text{C}$ 。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: 3~18 GHz

通带损耗: ≤ 1.5 dB

阻带衰减: ≥ 25 dB@1.9 GHz

≥ 48 dB@1.7 GHz

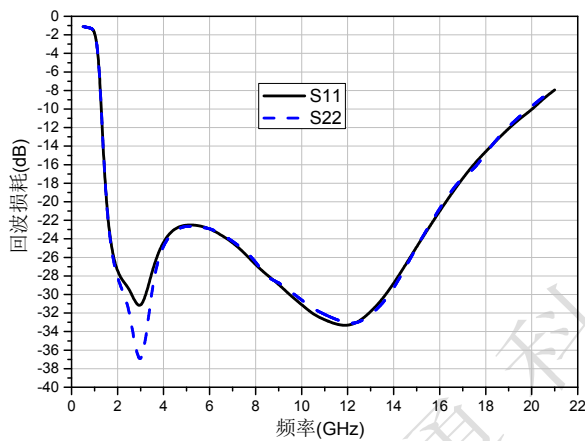
回波损耗: -20 dB

接口: 50Ω共面波导线

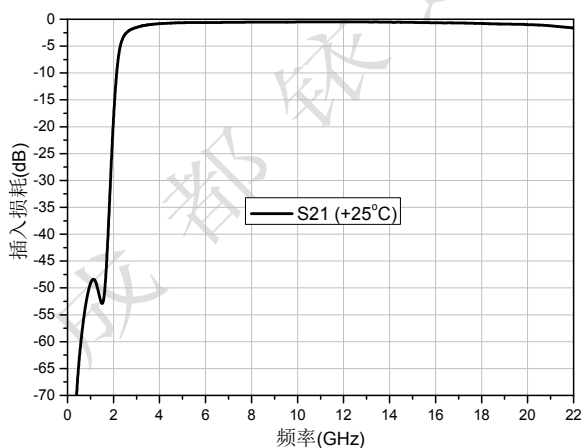
产品简介

YTHF-3T是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

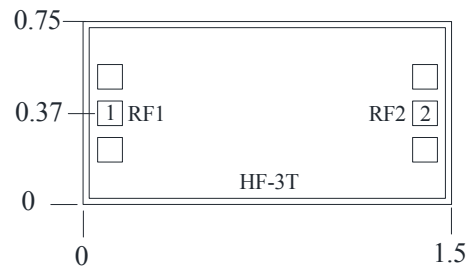


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C ~ +150°C
使用温度	-55°C ~ +125°C

外形尺寸

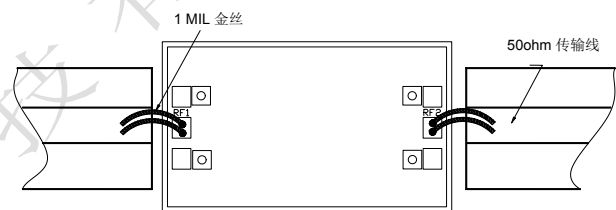


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: 4~20 GHz

通带损耗: ≤ 2.1 dB

阻带衰减: ≥ 20 dB@3.1 GHz

≥ 40 dB@2.8 GHz

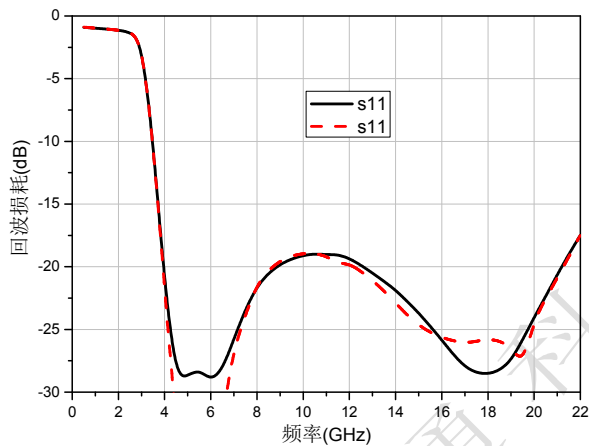
回波损耗: -20 dB

接口: 50 Ω 共面波导线

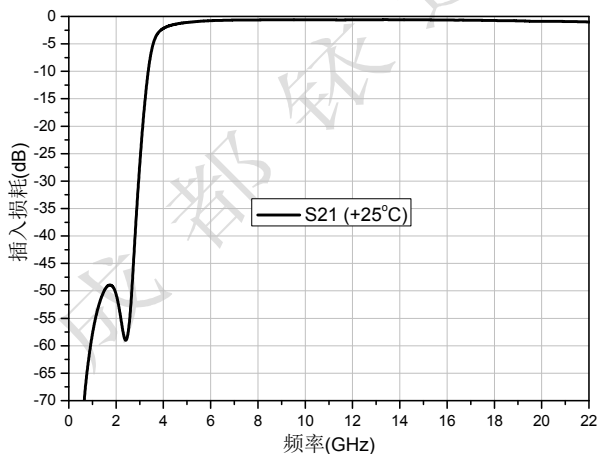
产品简介

YTHF-4T是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

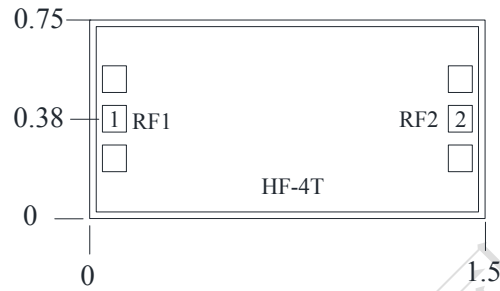


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65 $^\circ\text{C}$ ~+150 $^\circ\text{C}$
使用温度	-55 $^\circ\text{C}$ ~+125 $^\circ\text{C}$

外形尺寸

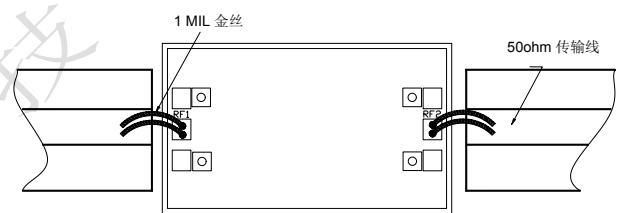


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或模型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150 $^\circ\text{C}$ 。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: 5~30 GHz

通带损耗: ≤ 1.8 dB

阻带衰减: ≥ 22 dB@3.6 GHz

≥ 43 dB@3.2 GHz

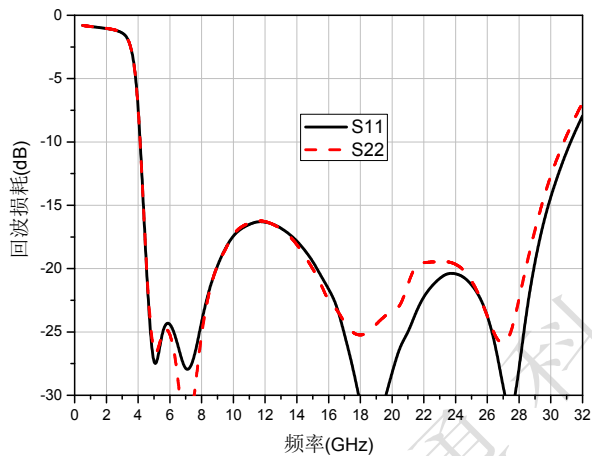
回波损耗: -20 dB

接口: 50Ω共面波导线

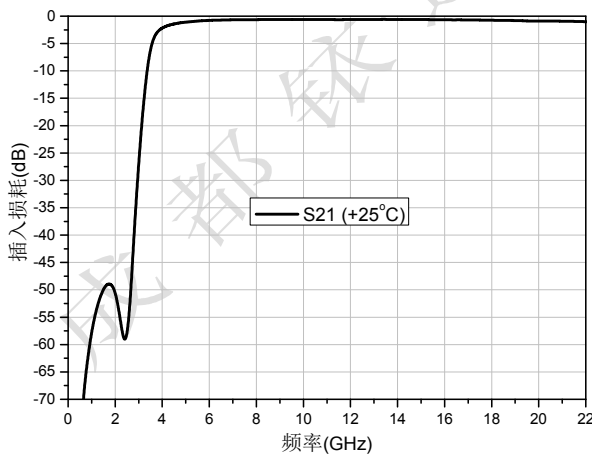
产品简介

YTHF-5是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 (T_A=+25°C)



输入输出回波损耗

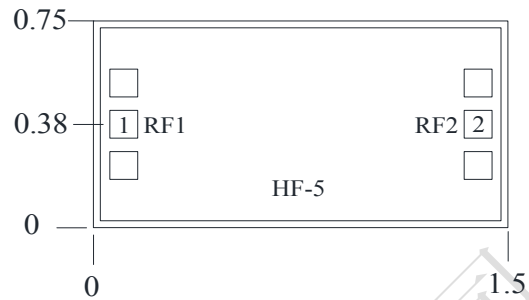


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C ~ +150°C
使用温度	-55°C ~ +125°C

外形尺寸



说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或模型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: 6~30 GHz

通带损耗: ≤ 1.8 dB

阻带衰减: ≥ 22 dB@3.6 GHz

≥ 43 dB@3.2 GHz

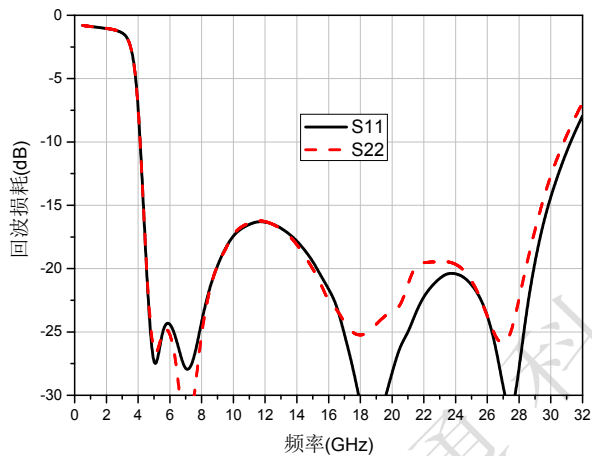
回波损耗: -20dB

接口: 50Ω共面波导线

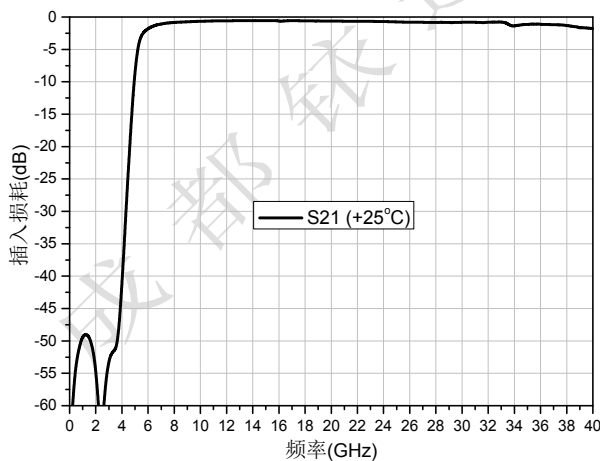
产品简介

YTHF-6T是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现, 性能不受外部箱体影响, 使用简单方便。芯片尺寸1.2mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 (T_A=+25°C)



输入输出回波损耗

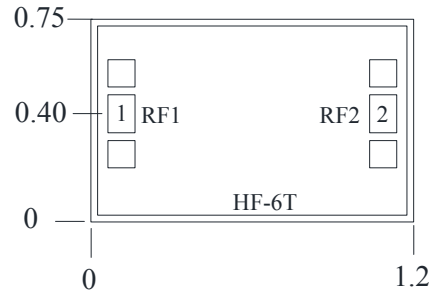


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C ~ +150°C
使用温度	-55°C ~ +125°C

外形尺寸

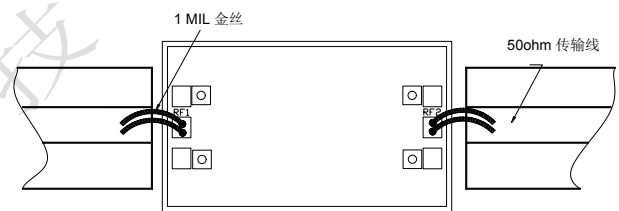


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔形键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: 7~30 GHz

通带损耗: ≤ 1.4 dB

阻带衰减: ≥ 22 dB@5.0 GHz

≥ 41 dB@4.4 GHz

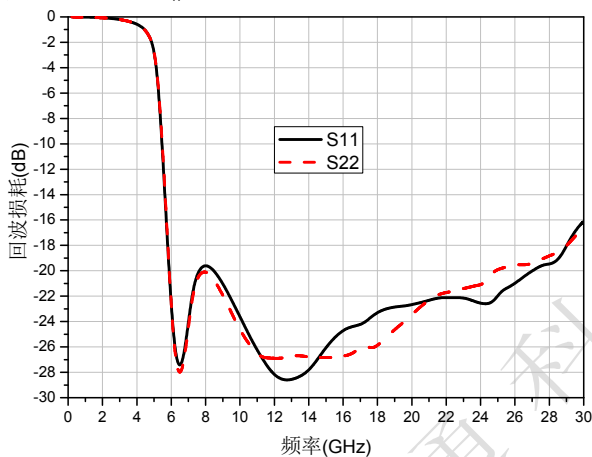
回波损耗: -20 dB

接口: 50 Ω 共面波导线

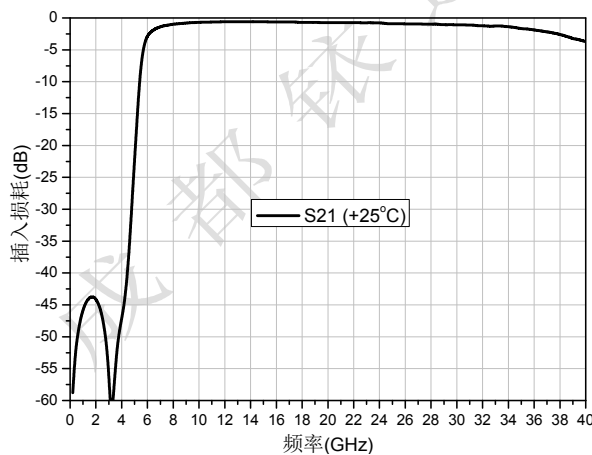
产品简介

YTHF-7T是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.2mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

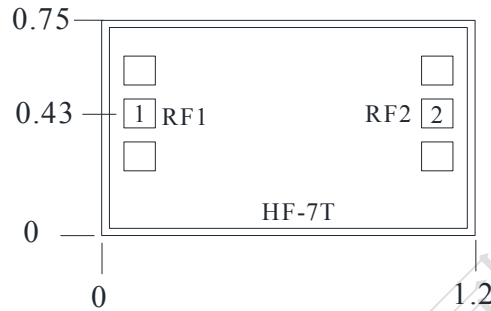


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

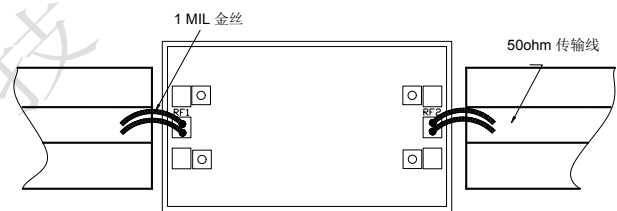


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152$ mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或模型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50$ gf, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22$ gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: 8~30 GHz

通带损耗: ≤ 1.8 dB

阻带衰减: ≥ 21 dB@6.5 GHz

≥ 40 dB@6.2 GHz

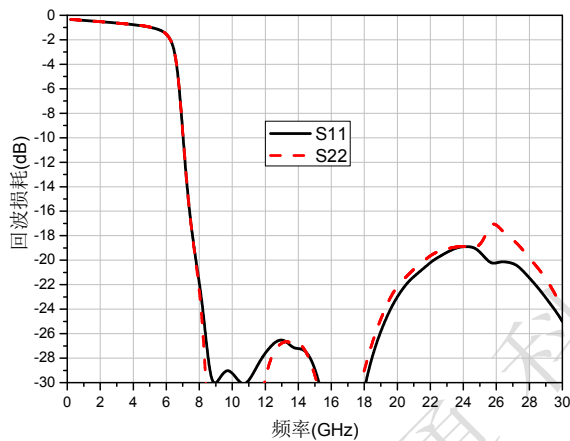
回波损耗: -20 dB

接口: 50 Ω 共面波导线

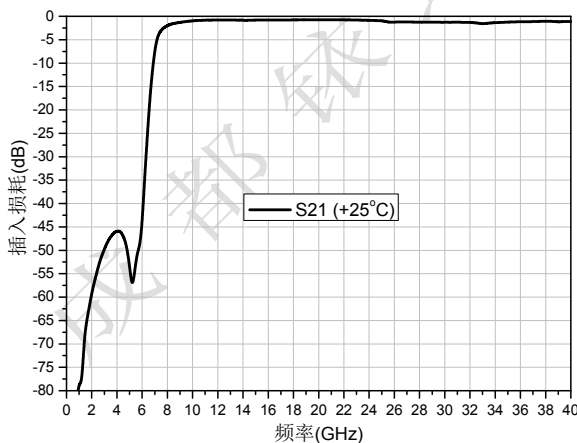
产品简介

YTHF-8T是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现, 性能不受外部箱体影响, 使用简单方便。芯片尺寸1.5mm \times 0.75mm \times 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

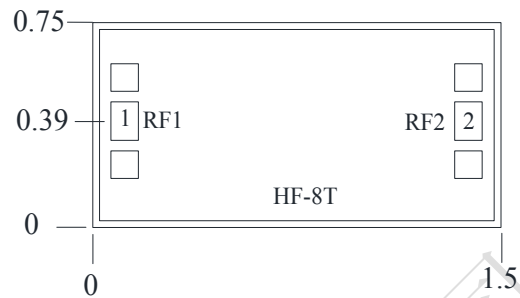


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

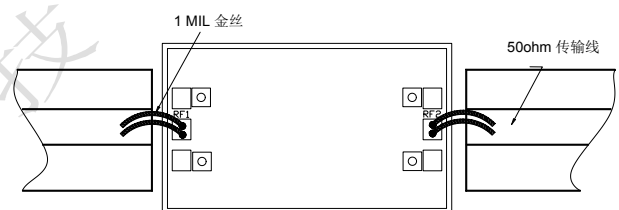


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm \times 0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: 9~30 GHz

通带损耗: ≤ 1.35 dB

阻带衰减: ≥ 21 dB@6.0 GHz

≥ 40 dB@4.8 GHz

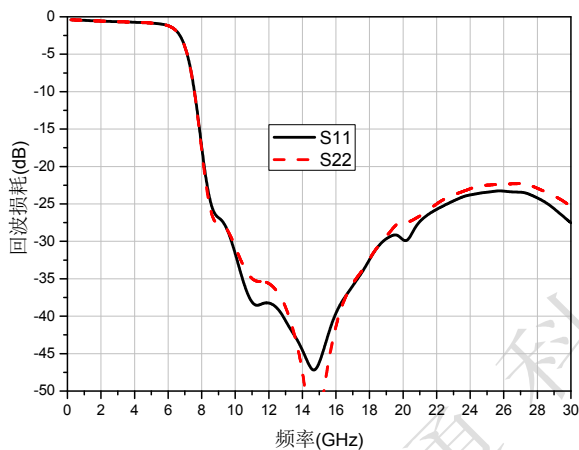
回波损耗: -20dB

接口: 50Ω共面波导线

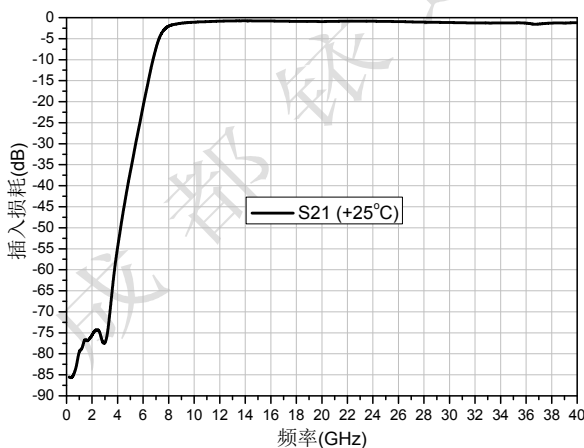
产品简介

YTHF-9是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

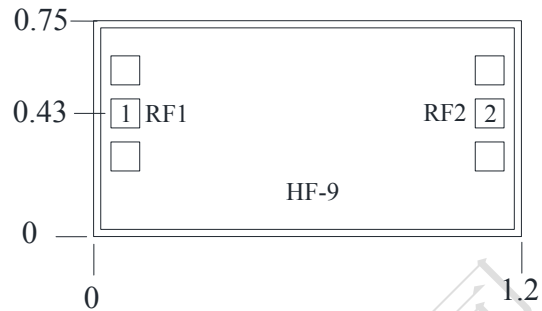


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65°C ~ +150°C
使用温度	-55°C ~ +125°C

外形尺寸

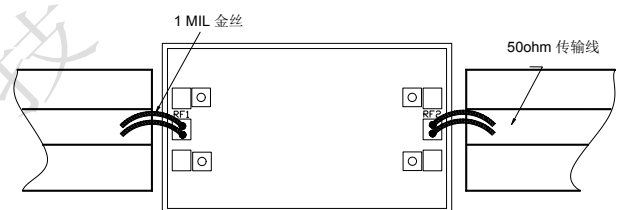


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: 10~30 GHz

通带损耗: ≤ 1.4 dB

阻带衰减: ≥ 21 dB@6.8 GHz

≥ 40 dB@5.4 GHz

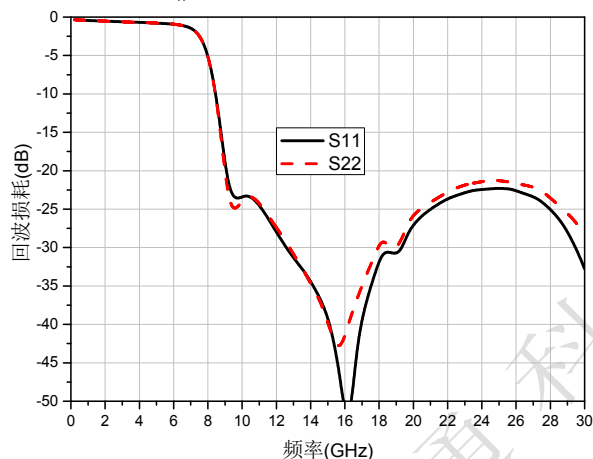
回波损耗: -20 dB

接口: 50 Ω 共面波导线

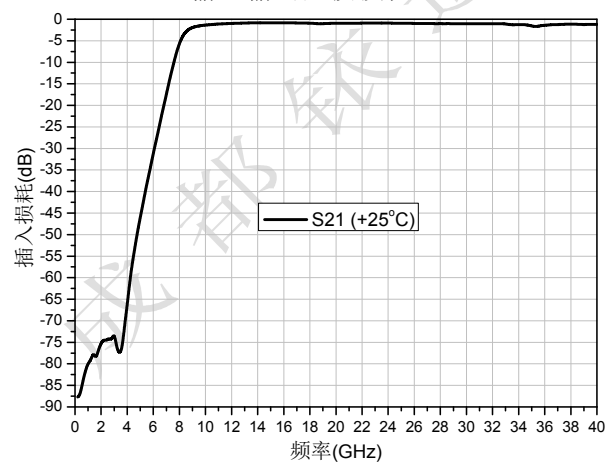
产品简介

YTHF-10是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

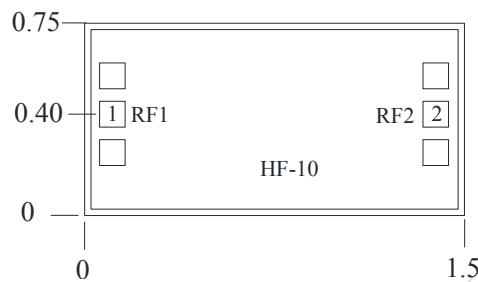


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

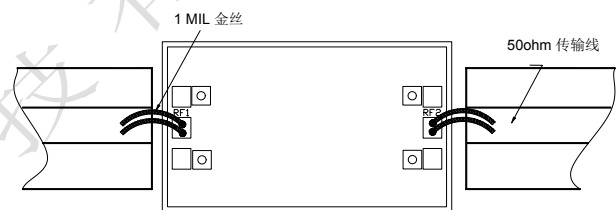


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152$ mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: 1.0~2.0GHz

通带损耗: ≤ 0.3 dB

均衡量: 2.0dB

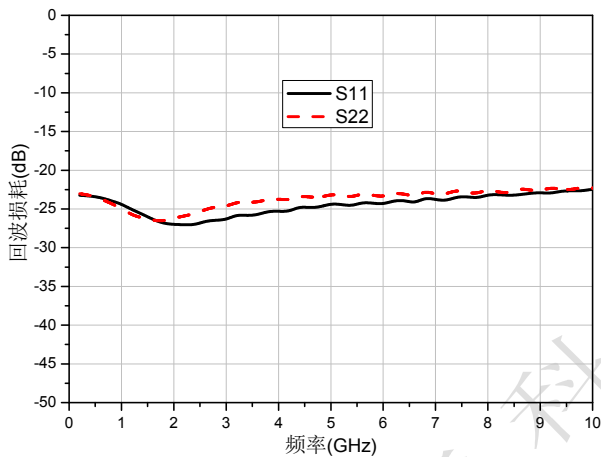
回波损耗: -22 dB

接口: 50 Ω 共面波导线

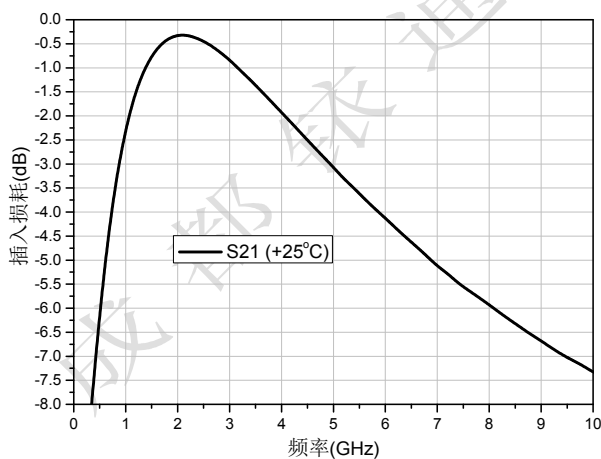
产品简介

YTJH-1/2-2是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点,广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.00mm \times 0.75mm \times 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

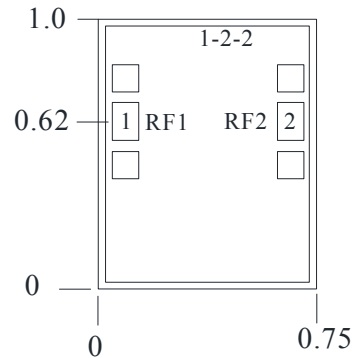


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

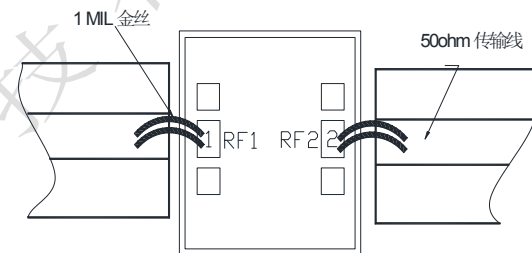


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm \times 0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: 1.0~2.0GHz

通带损耗: ≤ 0.45 dB

均衡量: 3.0dB

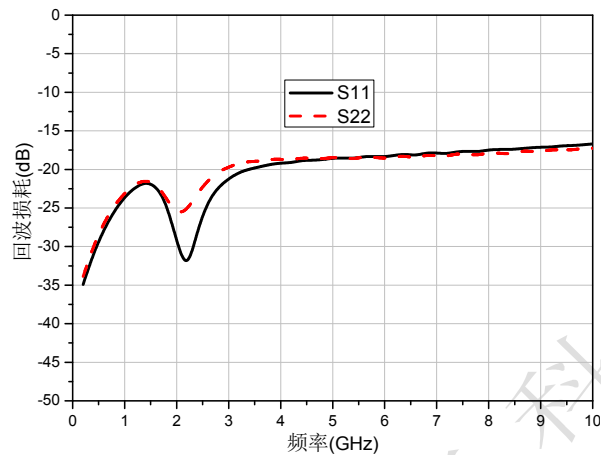
回波损耗: -22 dB

接口: 50 Ω 共面波导线

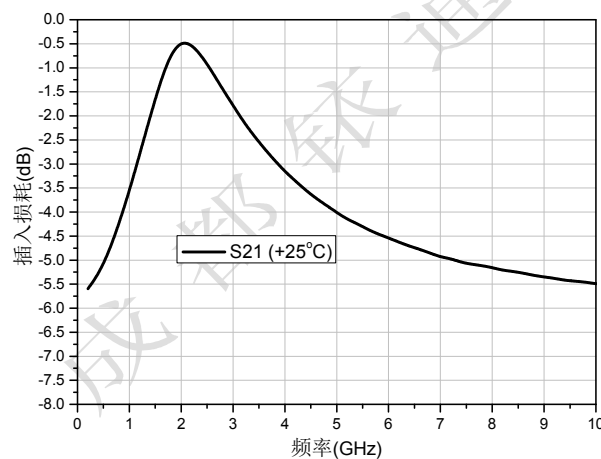
产品简介

YTJH-1/2-3是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点,广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.00mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

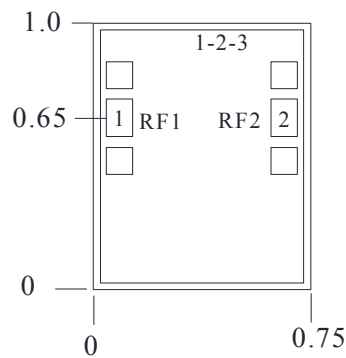


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

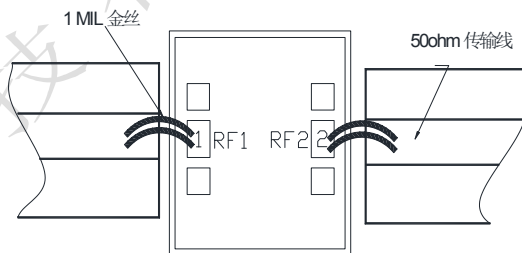


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: 1.0~6.0GHz

通带损耗: ≤ 0.43 dB

均衡量: 3.5dB

回波损耗: -20 dB

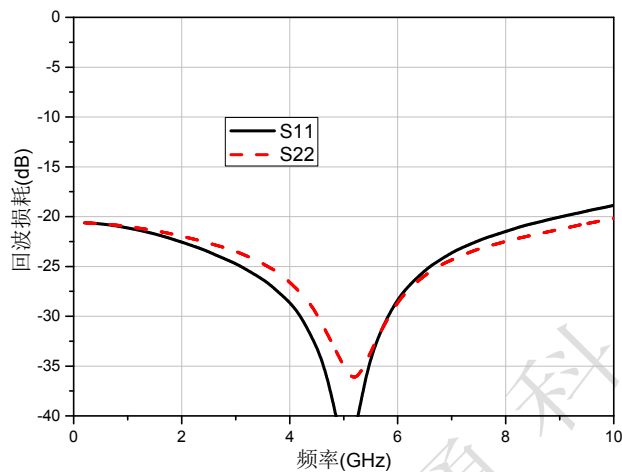
接口: 50Ω共面波导线

产品简介

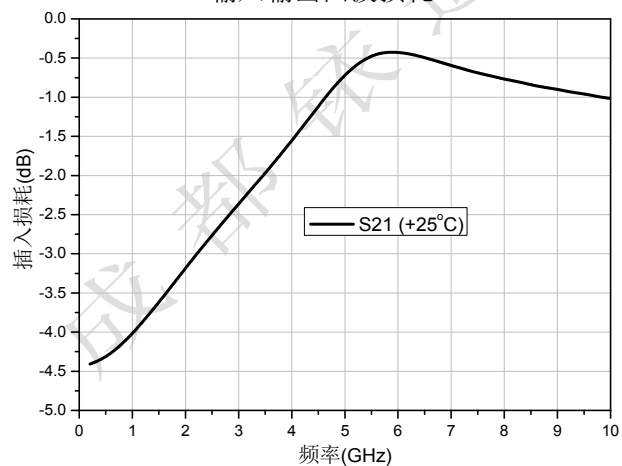
YTJH-1/6-3P5是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点,广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。

芯片尺寸 $0.85\text{mm} \times 0.80\text{mm} \times 0.1\text{mm}$ 。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

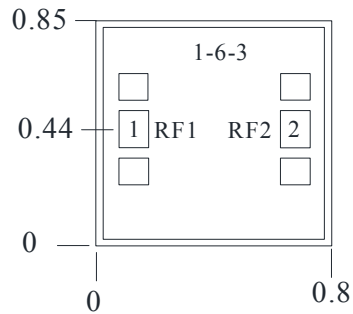


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

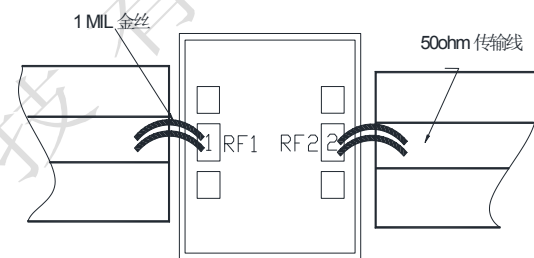


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152$ mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: 1.0~8.0GHz

通带损耗: ≤ 0.47 dB

均衡量: 4.0dB

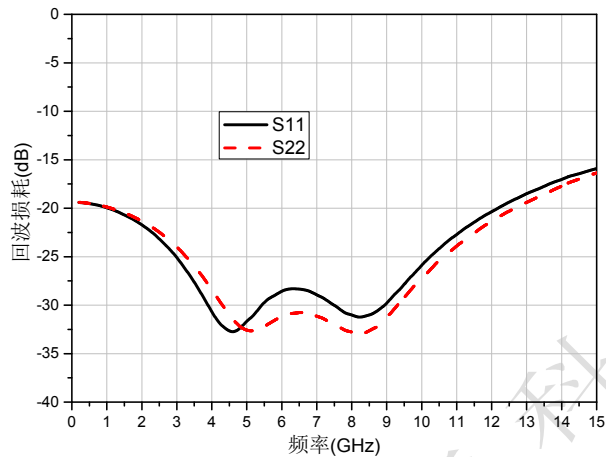
回波损耗: -22 dB

接口: 50 Ω 共面波导线

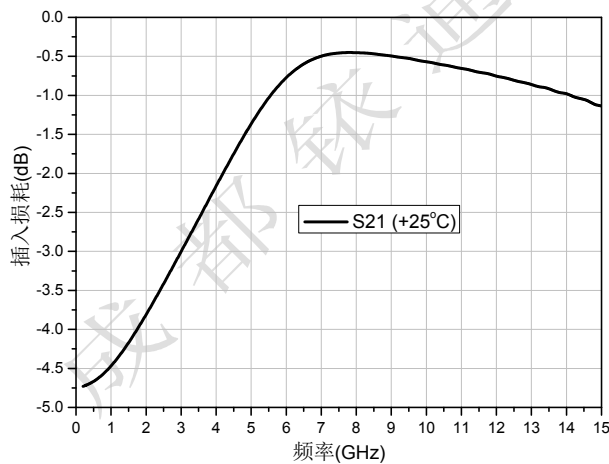
产品简介

YTJH-1/8-4是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点,广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现,性能不受外部箱体影响,使用简单方便。芯片尺寸0.85mmx0.80mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

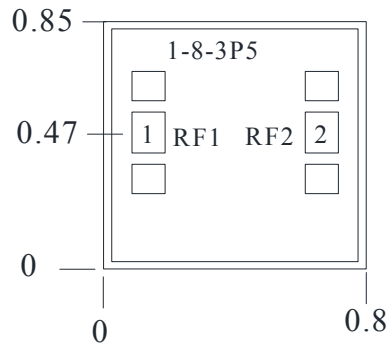


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

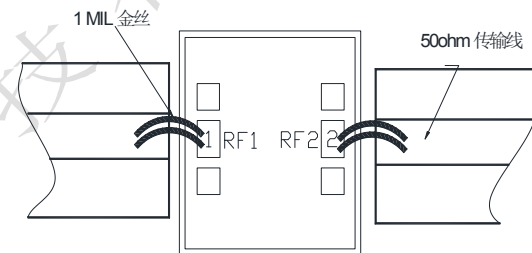


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: 2.0~4.0GHz

通带损耗: ≤ 0.6 dB

均衡量: 3.0dB

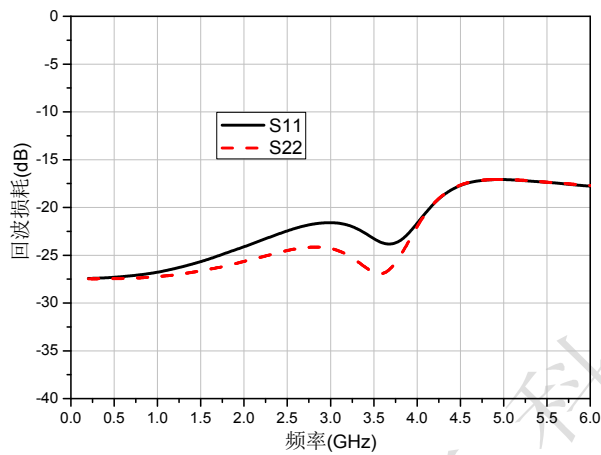
回波损耗: -21 dB

接口: 50Ω共面波导线

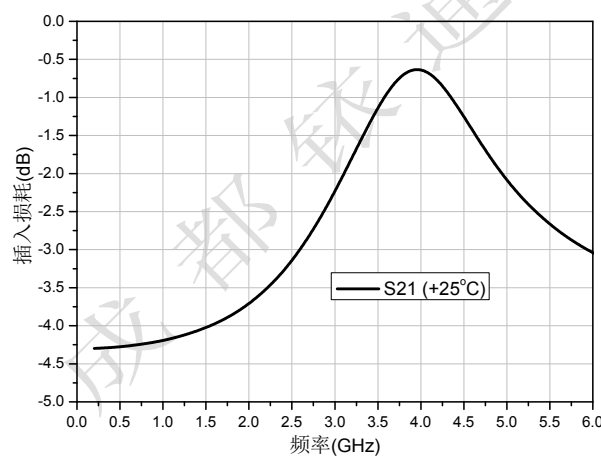
产品简介

YTJH-2/4-3是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点,广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。芯片尺寸0.85mmx0.80mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

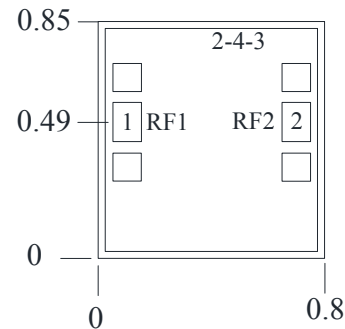


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

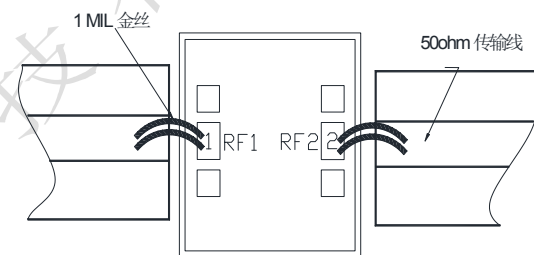


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152$ mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: 2.0~4.0GHz

通带损耗: ≤ 0.6 dB

均衡量: 4.0dB

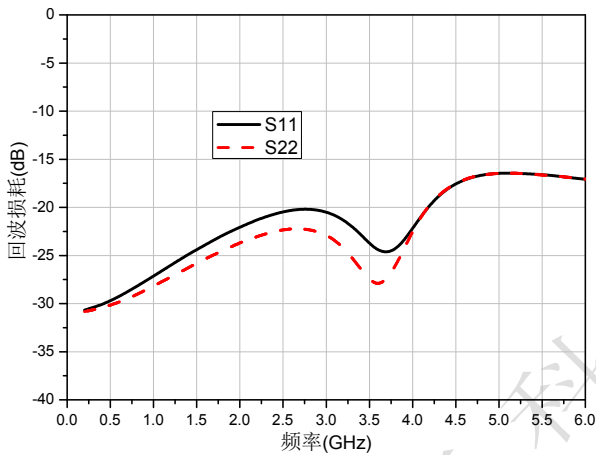
回波损耗: -20 dB

接口: 50 Ω 共面波导线

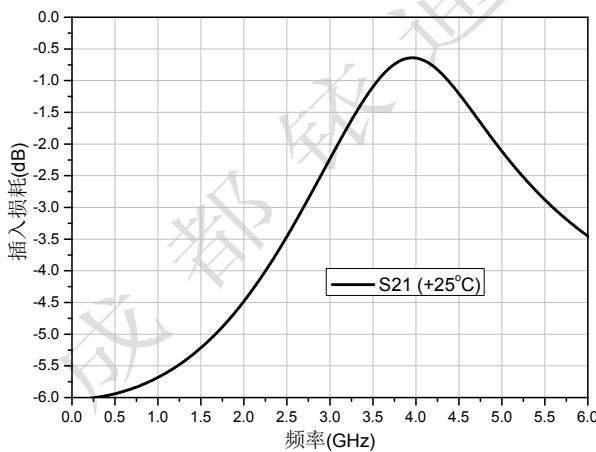
产品简介

YTJH-2/4-4是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点,广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。芯片尺寸0.85mmx0.80mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

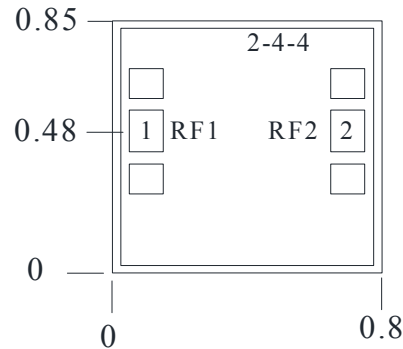


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

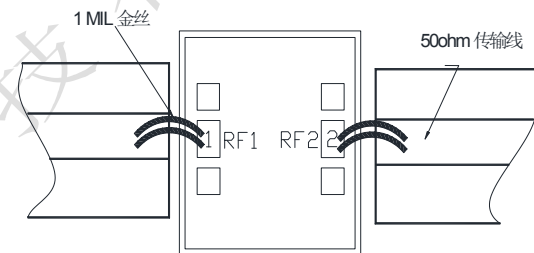


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: 2.0~18.0GHz

通带损耗: ≤ 1.2 dB

均衡量: 8.4dB

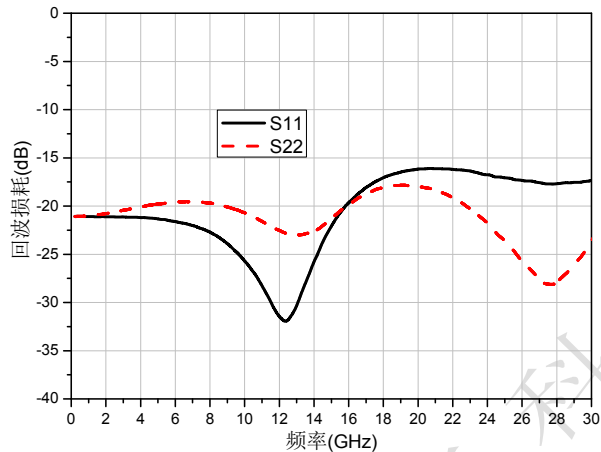
回波损耗: -18 dB

接口: 50 Ω 共面波导线

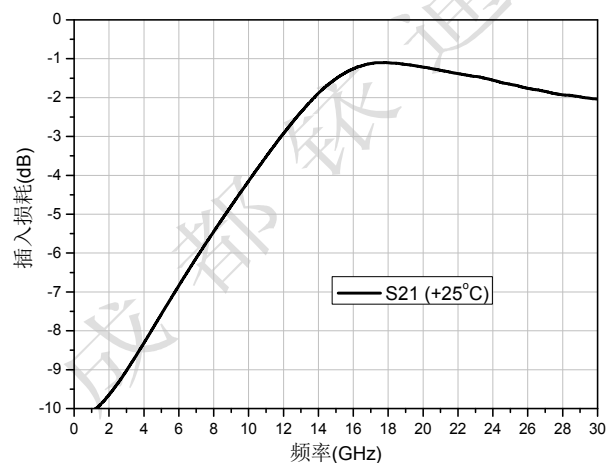
产品简介

YTJH-2/18-8是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点,广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。芯片尺寸0.85mm \times 0.80mm \times 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

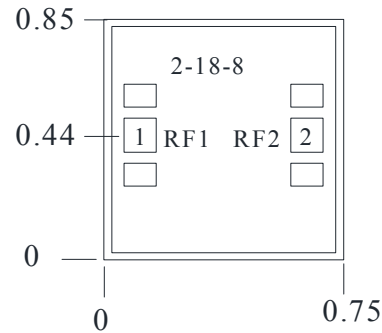


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

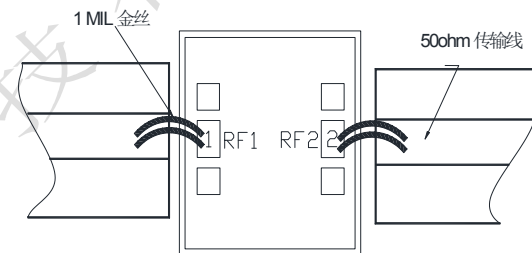


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm \times 0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: 6.0~12.0GHz

通带损耗: ≤ 0.9 dB

均衡量: 3.4dB

回波损耗: -20 dB

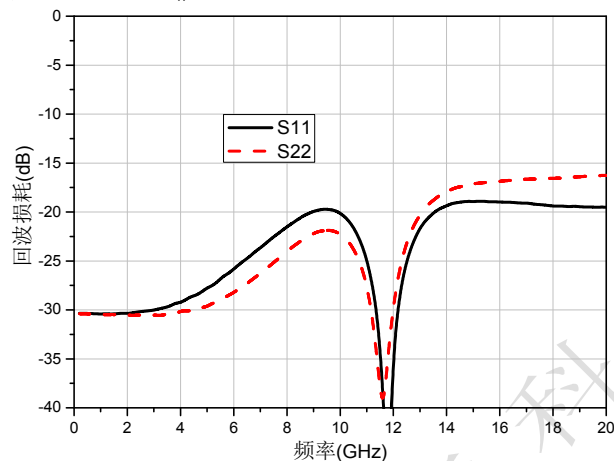
接口: 50 Ω 共面波导线

产品简介

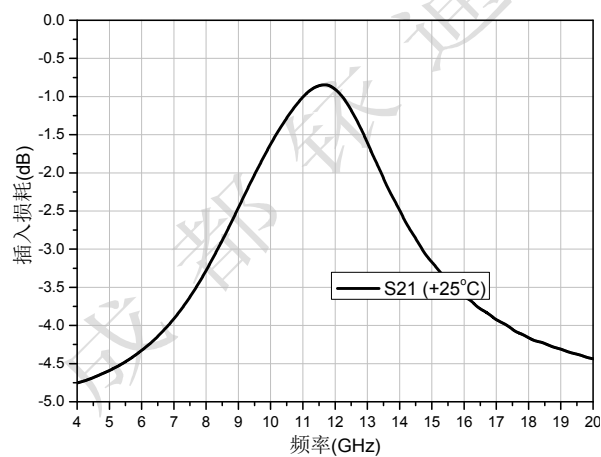
YTJH-6/12-3是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点,广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。

芯片尺寸0.85mm \times 0.80mm \times 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

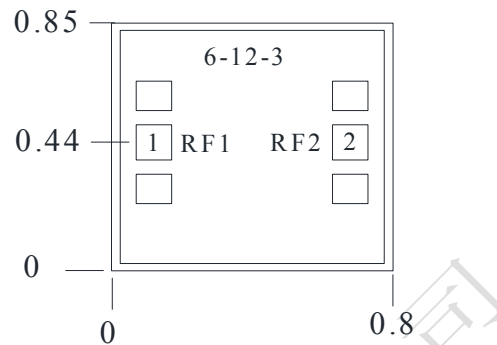


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

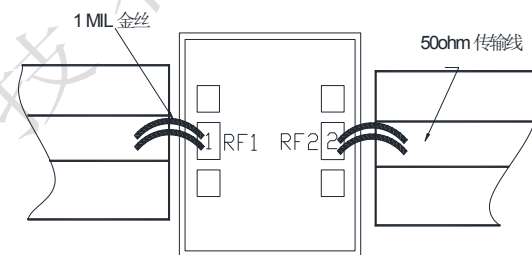


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm \times 0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: 6.0~18.0GHz

通带损耗: ≤ 1.0 dB

均衡量: 3.0dB

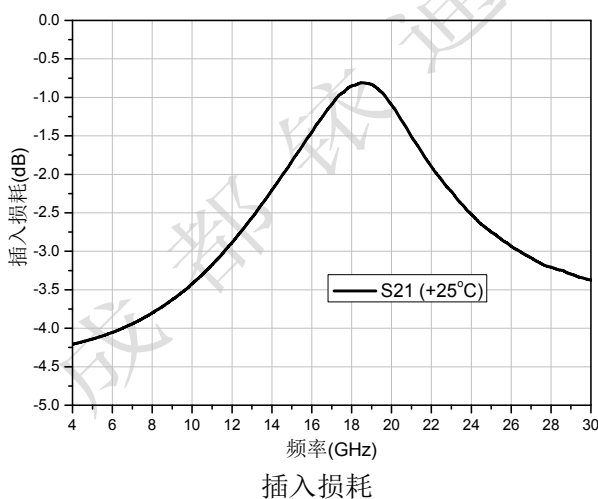
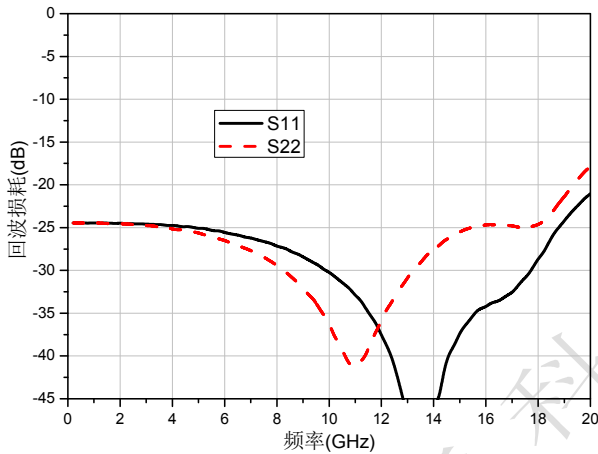
回波损耗: -25 dB

接口: 50 Ω 共面波导线

产品简介

YTJH-6/18-3是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点,广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。芯片尺寸0.85mmx0.75mm x 0.1mm。

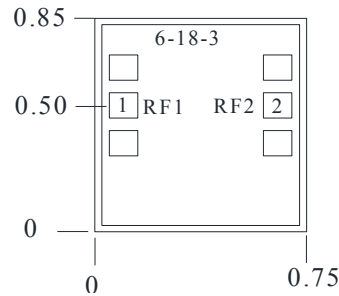
典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

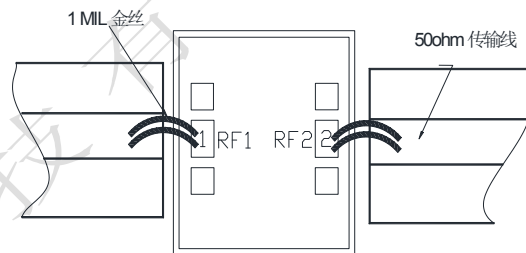


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152$ mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: 6.0~18.0GHz

通带损耗: ≤ 0.9 dB

均衡量: 4.0dB

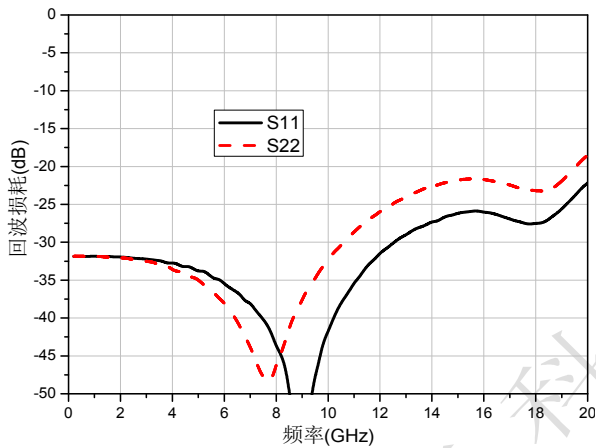
回波损耗: -22 dB

接口: 50Ω共面波导线

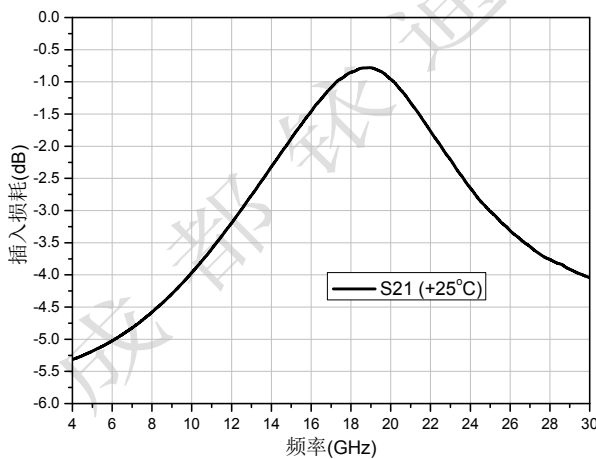
产品简介

YTJH-6/18-4是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点,广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。芯片尺寸0.85mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

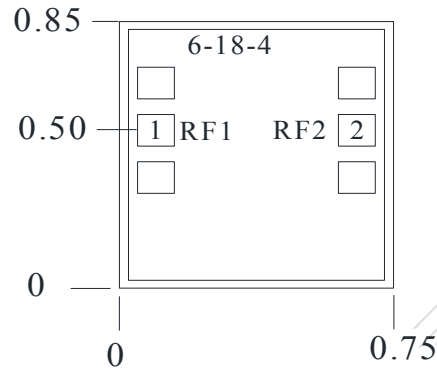


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

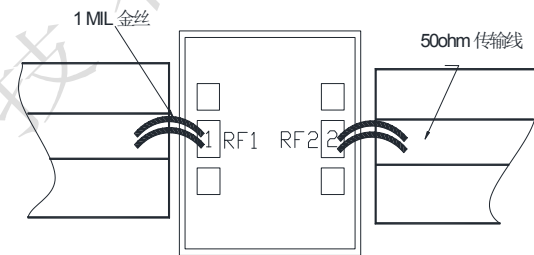


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152$ mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: 6.0~18.0GHz

通带损耗: ≤ 1.0 dB

均衡量: 5.0dB

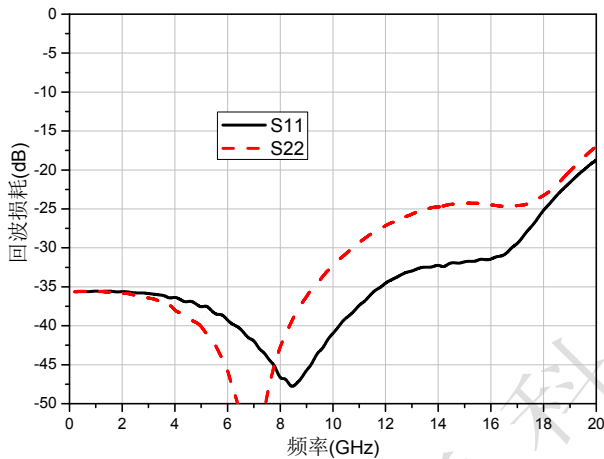
回波损耗: -25dB

接口: 50 Ω 共面波导线

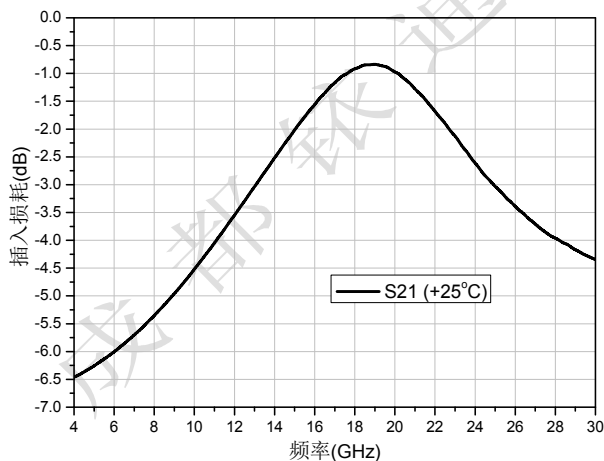
产品简介

YTJH-6/18-5是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点,广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。芯片尺寸0.85mm \times 0.75mm \times 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

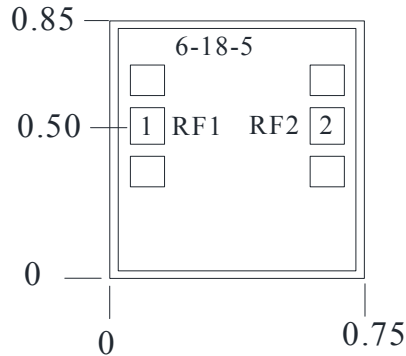


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	-65 $^\circ\text{C}$ ~+150 $^\circ\text{C}$
使用温度	-55 $^\circ\text{C}$ ~+125 $^\circ\text{C}$

外形尺寸

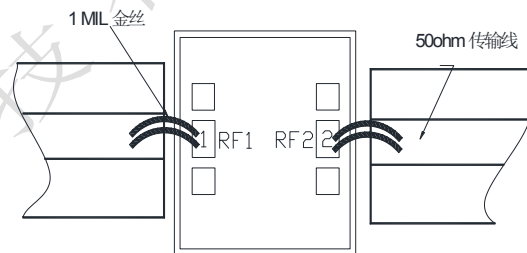


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm \times 0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil)金丝。热超声键合温度 150 $^\circ\text{C}$ 。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: 6.0~18.0GHz

通带损耗: ≤ 1.2 dB

均衡量: 6.0dB

回波损耗: -22 dB

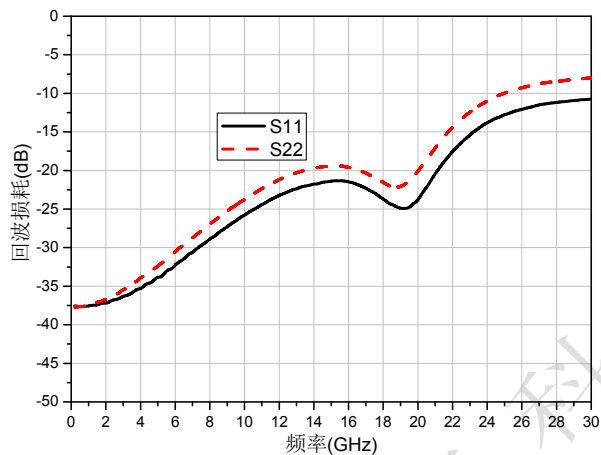
接口: 50 Ω 共面波导线

产品简介

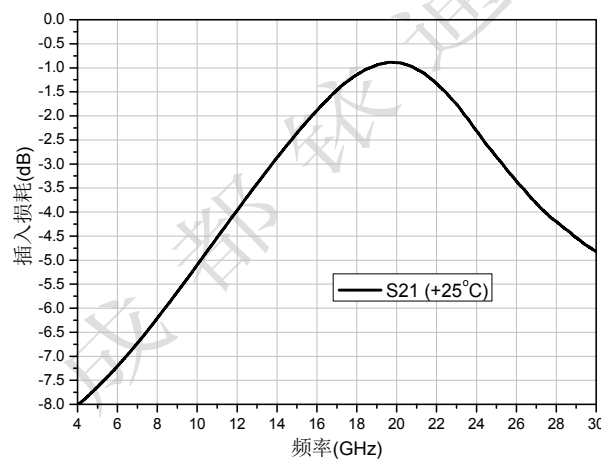
YTJH-6/18-6是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点,广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。

芯片尺寸0.85mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^{\circ}\text{C}$)



输入输出回波损耗

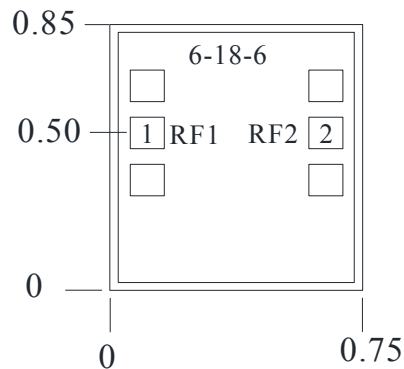


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
使用温度	$-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

外形尺寸

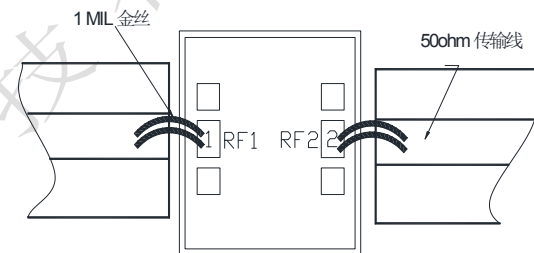


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: 8.0~12.0GHz

通带损耗: ≤ 0.7 dB

均衡量: 2.0dB

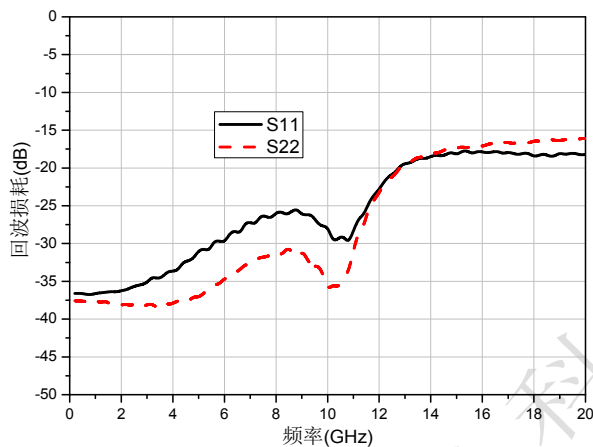
回波损耗: -22 dB

接口: 50 Ω 共面波导线

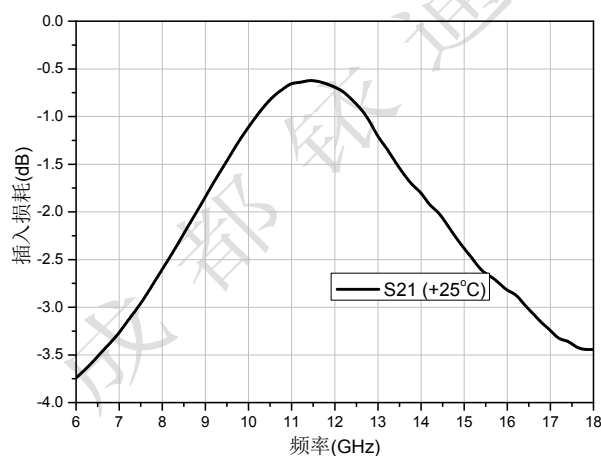
产品简介

YTJH-8/12-2是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点,广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.00mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

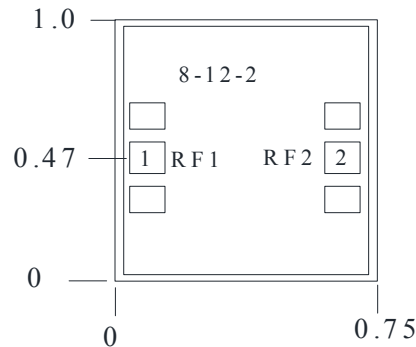


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

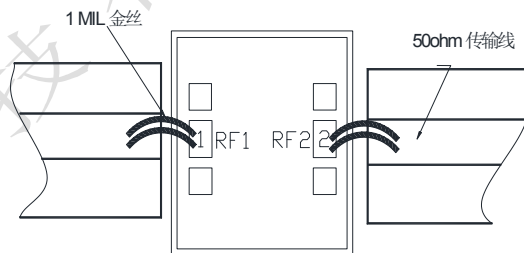


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: 8.0~12.0GHz

通带损耗: ≤ 1.0 dB

均衡量: 3.0dB

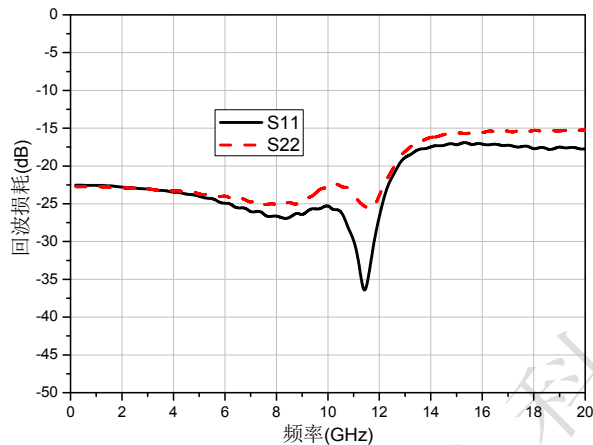
回波损耗: -22 dB

接口: 50 Ω 共面波导线

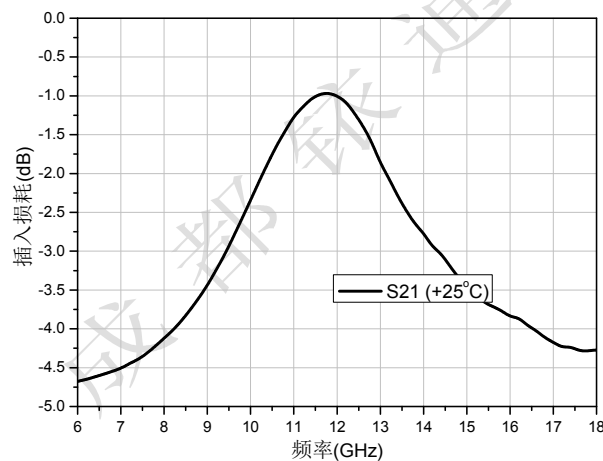
产品简介

YTJH-8/12-3是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点,广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.00mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

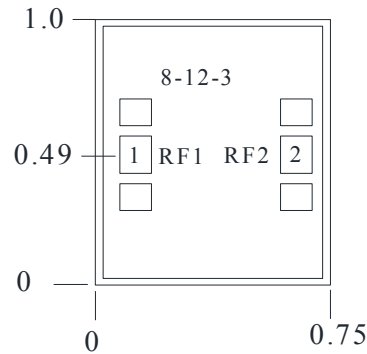


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

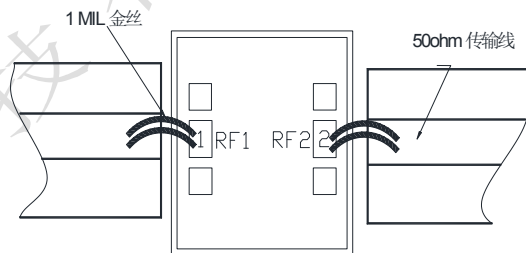


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: 8.0~12.0GHz

通带损耗: ≤ 1.0 dB

均衡量: 4.0dB

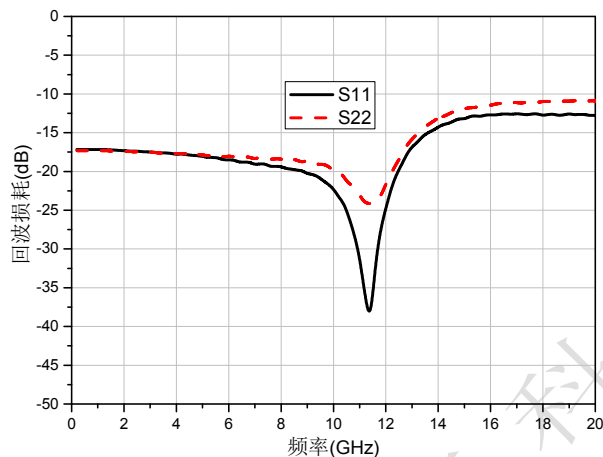
回波损耗: -16 dB

接口: 50 Ω 共面波导线

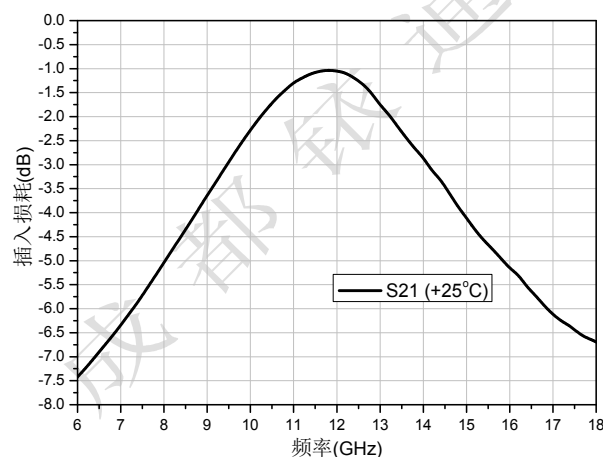
产品简介

YTJH-8/12-4是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点,广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。芯片尺寸1.00mmx0.75mm x 0.1mm。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

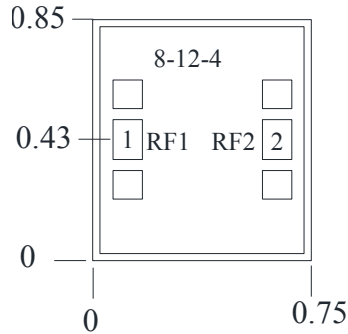


插入损耗

极限参数

最高输入功率	+30dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

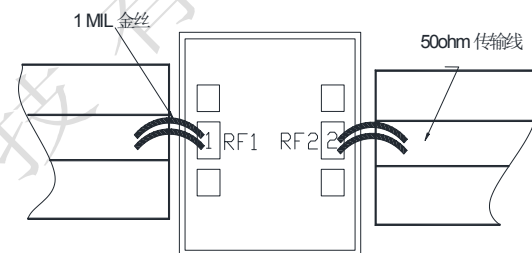


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: DC~40 GHz

衰减量: 0 dB

衰减精度: ± 0.2 dB

回波损耗: > 20 dB

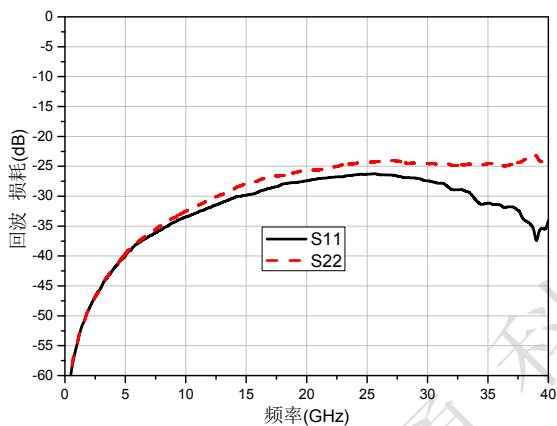
芯片尺寸: $0.5\text{mm} \times 0.5\text{mm} \times 0.1\text{mm}$

接口: 50Ω 共面波导线

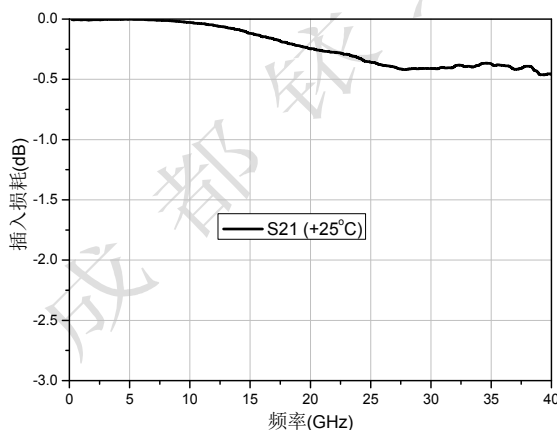
产品简介

YTGS-0是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

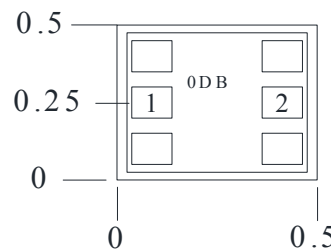


衰减量

极限参数

最高输入功率	+27 dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

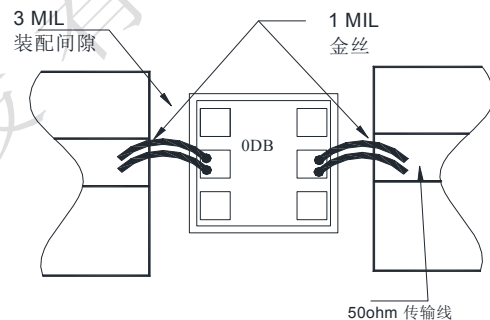


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152\text{mm}$ ($3 \sim 6\text{mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~40 GHz

衰减量: 0.5 dB

衰减精度: ± 0.2 dB

回波损耗: > 20 dB

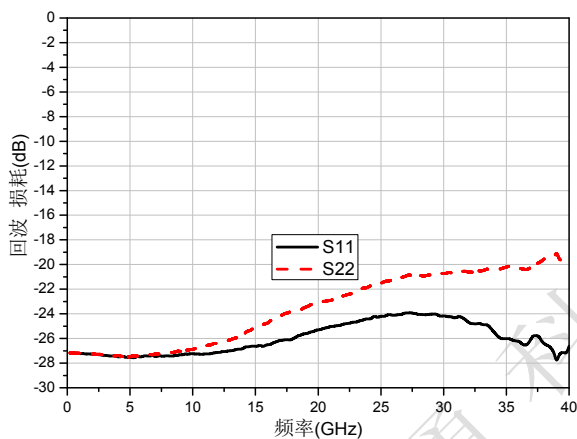
芯片尺寸: 0.5mmx0.5mm x 0.1mm

接口: 50Ω共面波导线

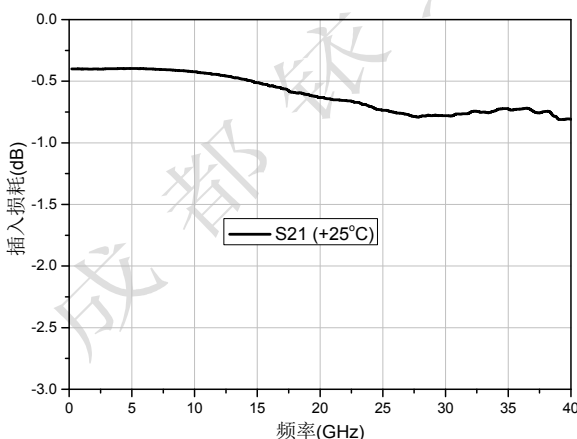
产品简介

YTGS-0P5是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等特点, 广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理, 适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

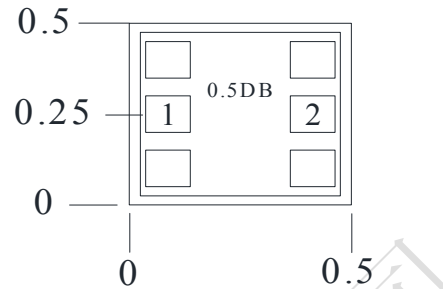


衰减量

极限参数

最高输入功率	+27dBm
存储温度	-65°C ~ +150°C
使用温度	-55°C ~ +125°C

外形尺寸

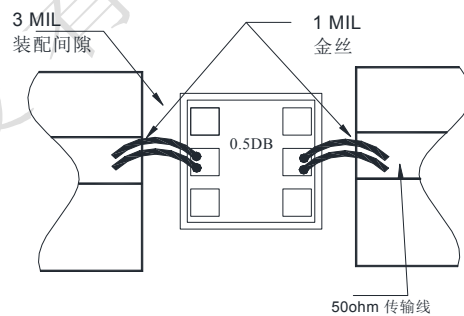


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~40 GHz

衰减量: 1dB

衰减精度: ± 0.2 dB

回波损耗: > 20 dB

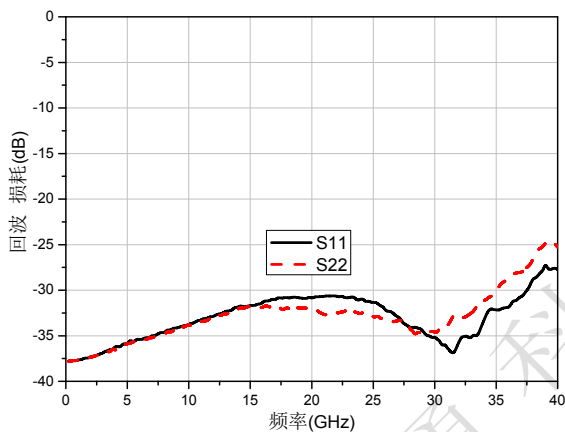
芯片尺寸: 0.5mmx0.5mm x 0.1mm

接口: 50 Ω 共面波导线

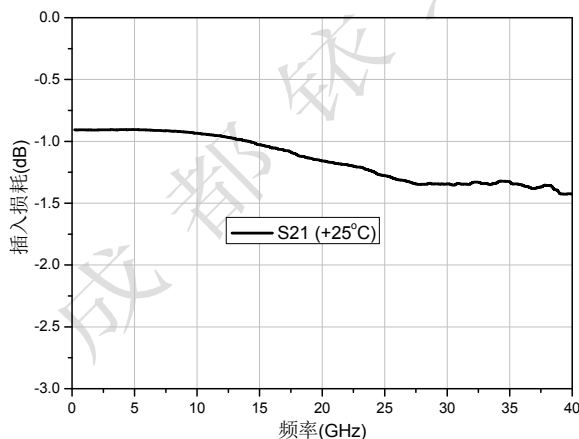
产品简介

YTGS-1是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

典型曲线 ($T_A=+25^{\circ}\text{C}$)



输入输出回波损耗

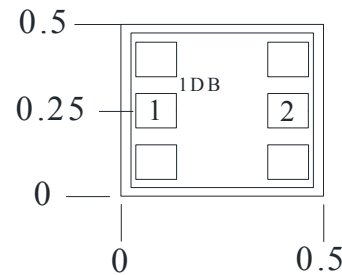


衰减量

极限参数

最高输入功率	+27dBm
存储温度	-65 $^{\circ}\text{C}$ ~+150 $^{\circ}\text{C}$
使用温度	-55 $^{\circ}\text{C}$ ~+125 $^{\circ}\text{C}$

外形尺寸

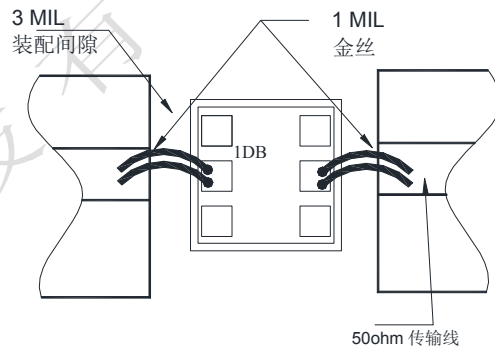


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150 $^{\circ}\text{C}$ 。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~40 GHz

衰减量: 2dB

衰减精度: ± 0.3 dB

回波损耗: > 20 dB

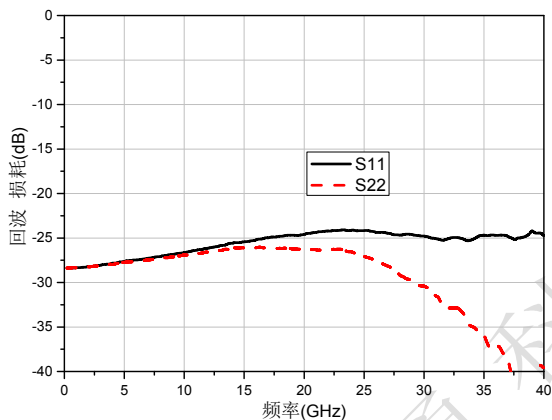
芯片尺寸: $0.5\text{mm} \times 0.5\text{mm} \times 0.1\text{mm}$

接口: 50Ω 共面波导线

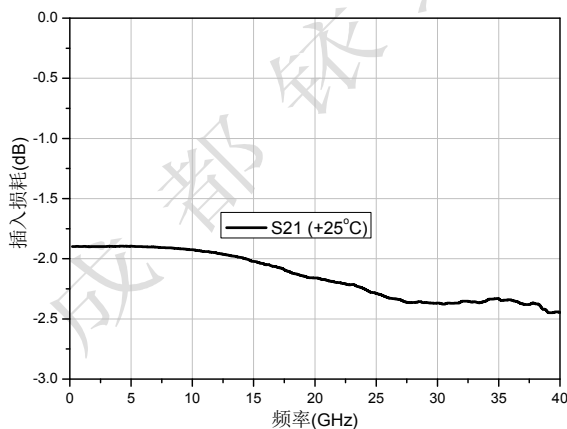
产品简介

YTGS-2是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

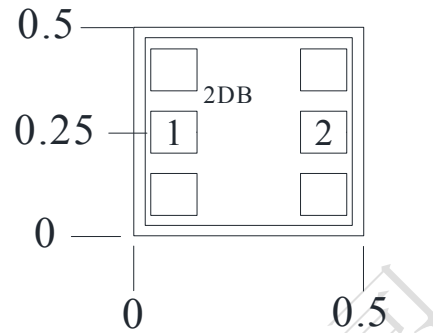


衰减量

极限参数

最高输入功率	+27dBm
存储温度	-65°C ~ +150°C
使用温度	-55°C ~ +125°C

外形尺寸

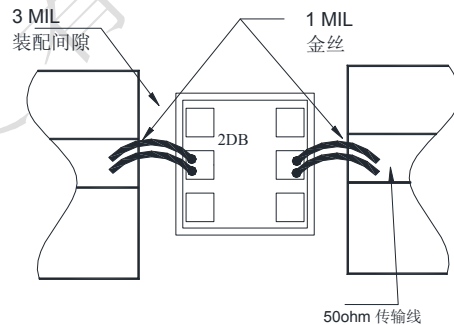


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152$ mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~40 GHz

衰减量: 3dB

衰减精度: ± 0.3 dB

回波损耗: > 20 dB

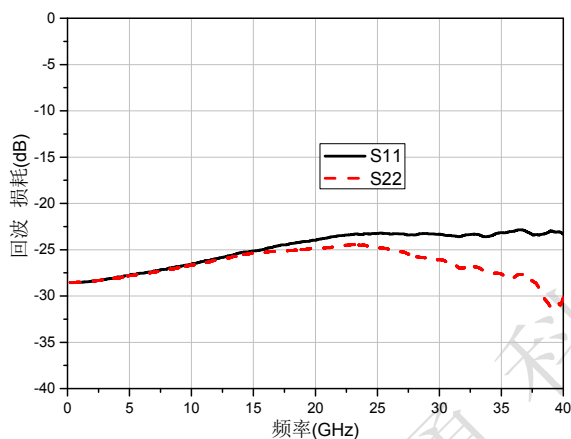
芯片尺寸: $0.5\text{mm} \times 0.5\text{mm} \times 0.1\text{mm}$

接口: 50Ω 共面波导线

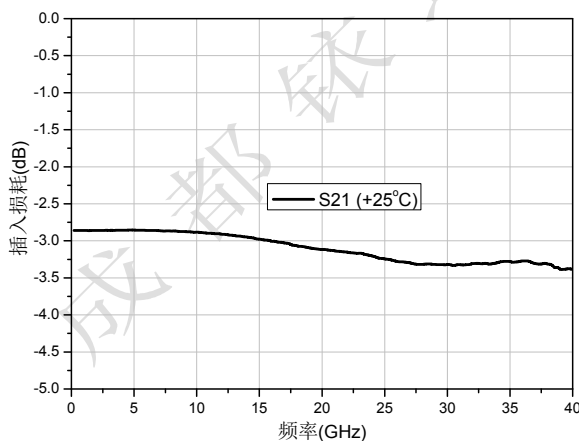
产品简介

YTGS-3是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

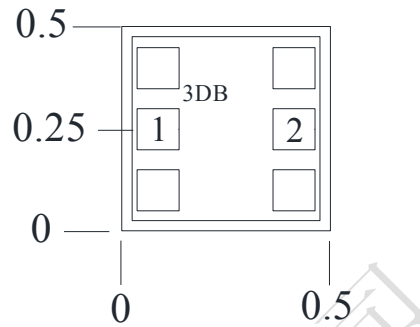


衰减量

极限参数

最高输入功率	+27dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

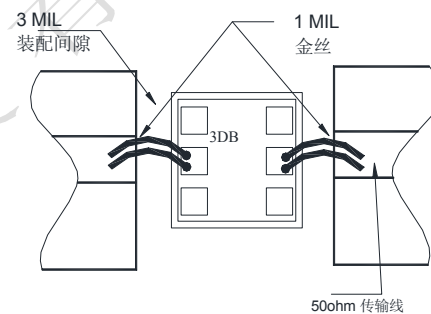


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152\text{mm}$ ($3 \sim 6\text{mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~40 GHz

衰减量: 4dB

衰减精度: $\pm 0.3\text{dB}$

回波损耗: $> 20\text{dB}$

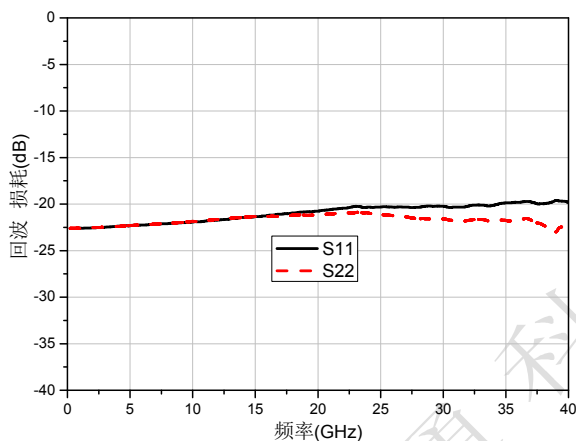
芯片尺寸: $0.5\text{mm} \times 0.5\text{mm} \times 0.1\text{mm}$

接口: 50Ω 共面波导线

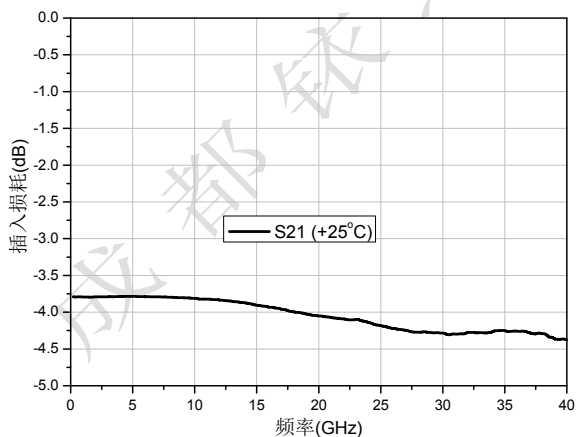
产品简介

YTGS-4是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

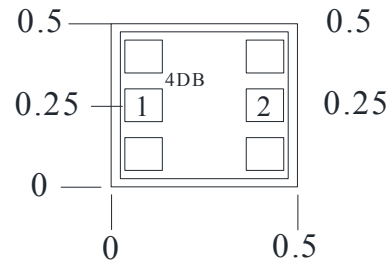


衰减量

极限参数

最高输入功率	+27dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

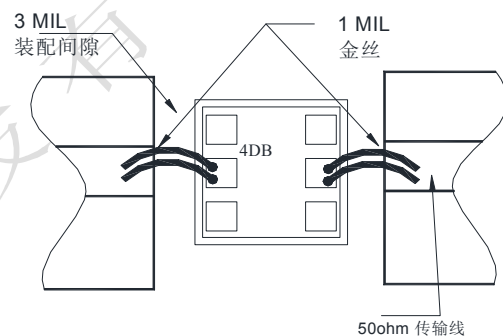


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152\text{mm}$ ($3 \sim 6\text{mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~40 GHz

衰减量: 5dB

衰减精度: ± 0.4 dB

回波损耗: > 20 dB

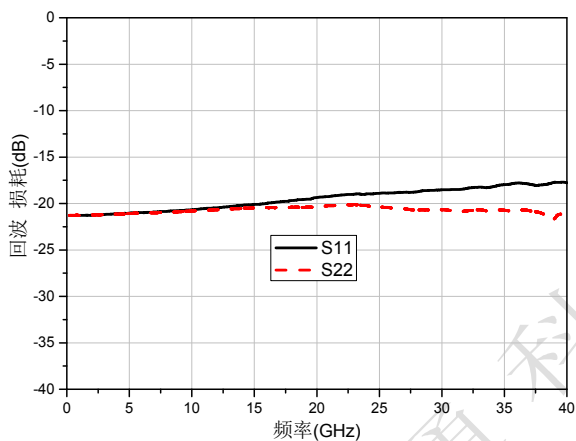
芯片尺寸: 0.5mmx0.5mm x 0.1mm

接口: 50 Ω 共面波导线

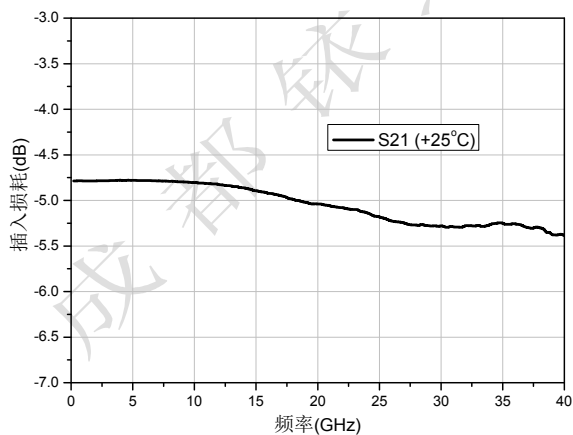
产品简介

YTGS-5是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

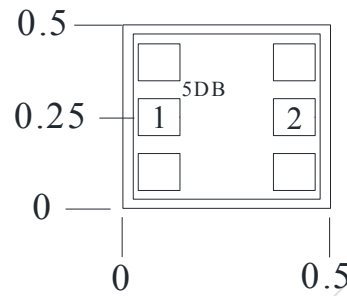


衰减量

极限参数

最高输入功率	+27dBm
存储温度	-65 $^\circ\text{C}$ ~+150 $^\circ\text{C}$
使用温度	-55 $^\circ\text{C}$ ~+125 $^\circ\text{C}$

外形尺寸

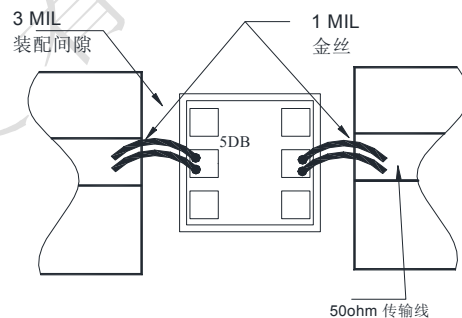


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150 $^\circ\text{C}$ 。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~40 GHz

衰减量: 6dB

衰减精度: ± 0.4 dB

回波损耗: > 18 dB

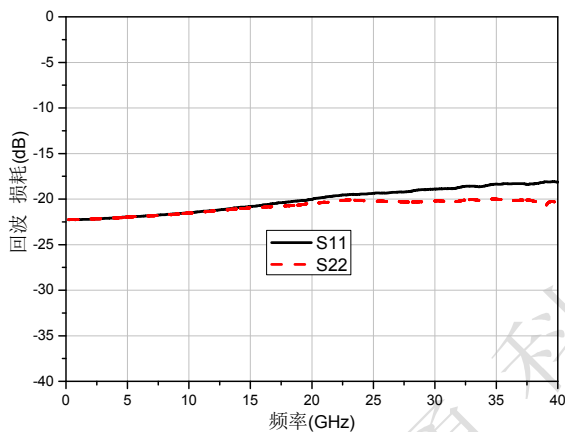
芯片尺寸: 0.5mmx0.5mm x 0.1mm

接口: 50Ω共面波导线

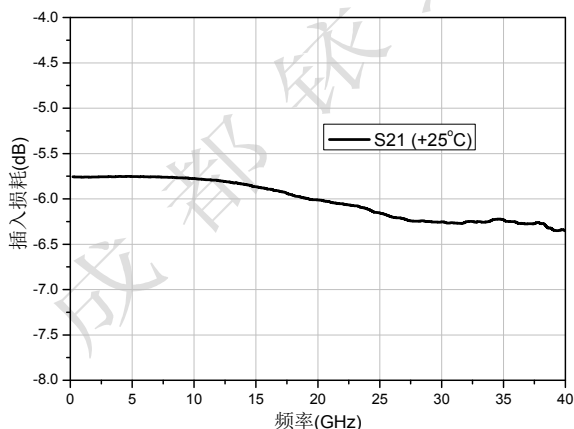
产品简介

YTGS-6是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

典型曲线 ($T_A=+25^{\circ}C$)



输入输出回波损耗

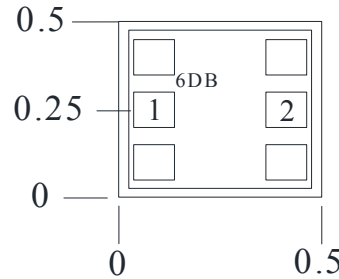


衰减量

极限参数

最高输入功率	+27dBm
存储温度	-65°C ~ +150°C
使用温度	-55°C ~ +125°C

外形尺寸

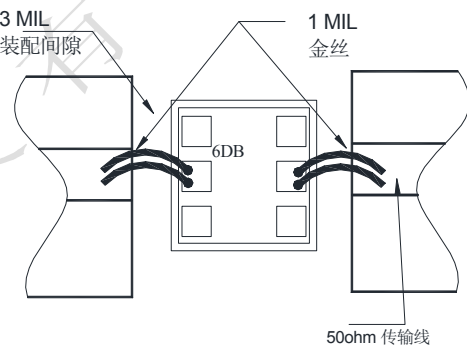


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: DC~40 GHz

衰减量: 8dB

衰减精度: ± 0.4 dB

回波损耗: > 18 dB

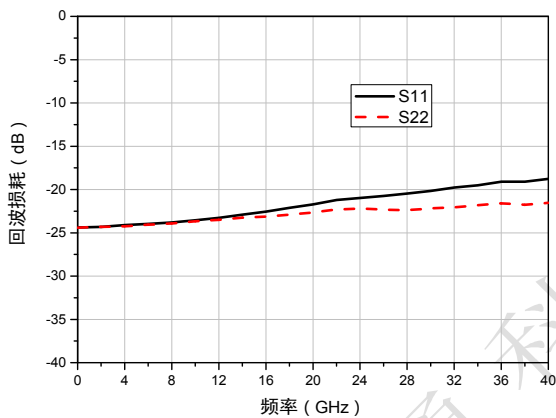
芯片尺寸: 0.5mmx0.5mm x 0.1mm

接口: 50Ω共面波导线

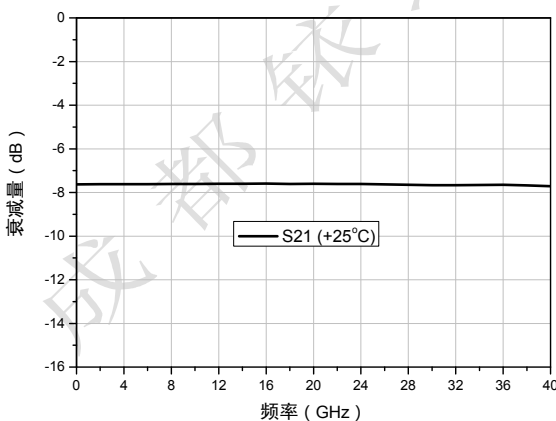
产品简介

YTGS-8是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

典型曲线 ($T_A=+25^{\circ}\text{C}$)



输入输出回波损耗

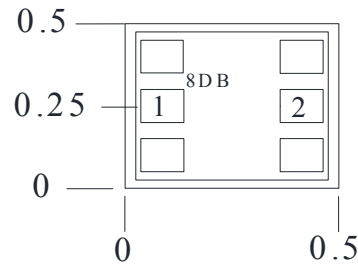


衰减量

极限参数

最高输入功率	+27dBm
存储温度	-65°C ~ +150°C
使用温度	-55°C ~ +125°C

外形尺寸

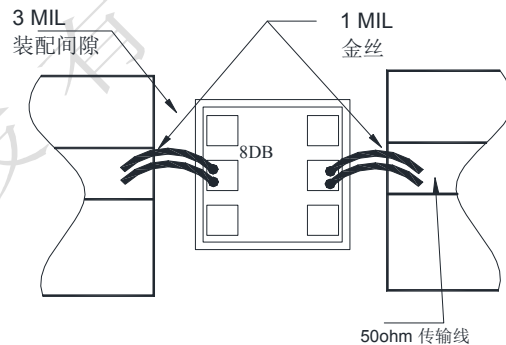


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: 0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025$ mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: DC~40 GHz

衰减量: 10 dB

衰减精度: ± 0.3 dB

回波损耗: -20 dB

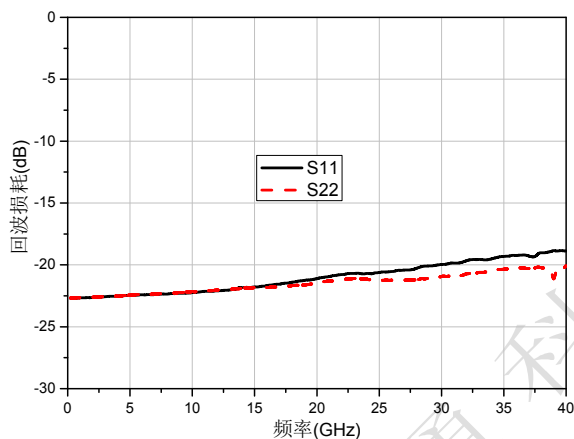
芯片尺寸: $0.8\text{mm} \times 0.5\text{mm} \times 0.1\text{mm}$

接口: 50Ω 共面波导线

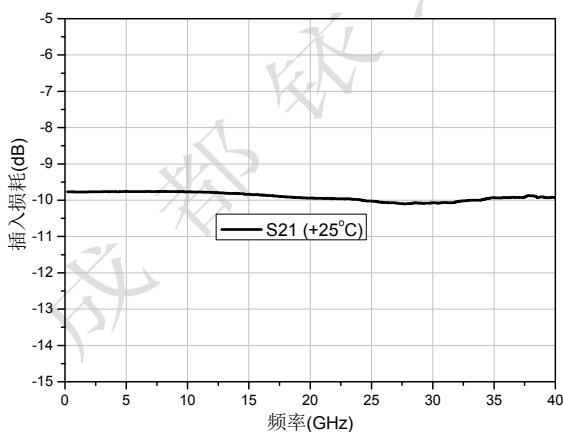
产品简介

YTGS-10是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

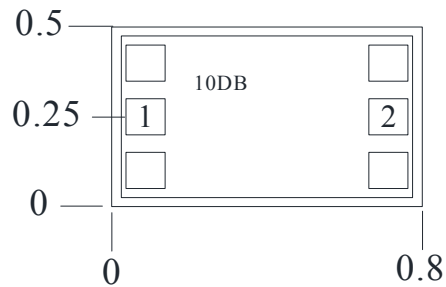


衰减量

极限参数

最高输入功率	+27 dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

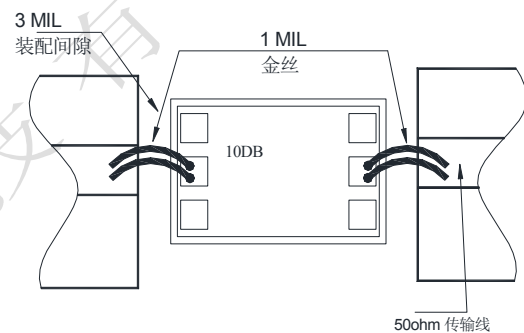


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: ± 0.05 mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152$ mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~40 GHz

衰减量: 15 dB

衰减精度: ± 0.7 dB

回波损耗: -20 dB

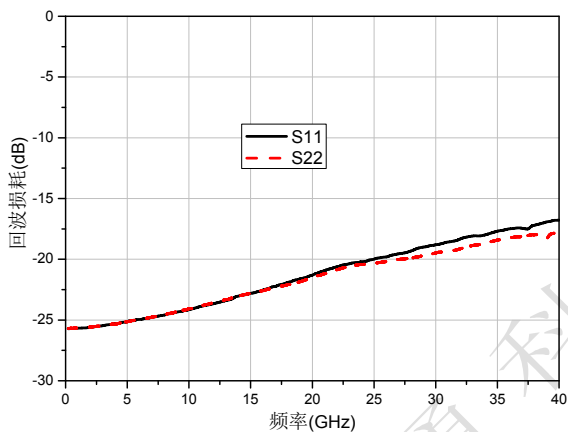
芯片尺寸: $0.8\text{mm} \times 0.5\text{mm} \times 0.1\text{mm}$

接口: 50Ω 共面波导线

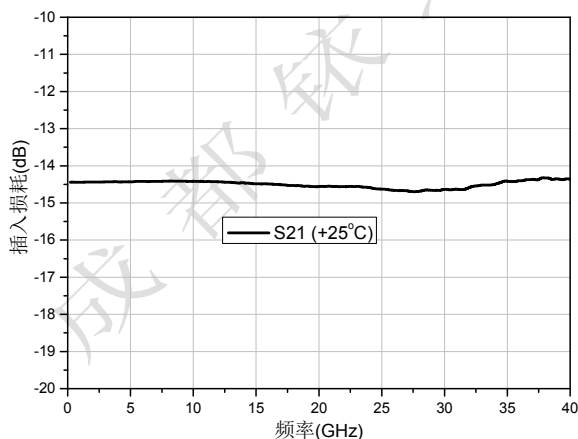
产品简介

YTGS-15是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

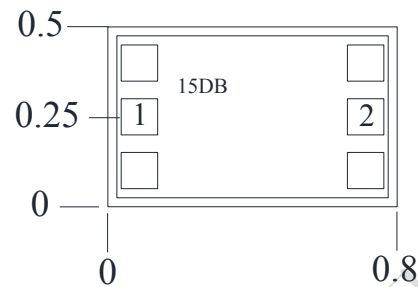


衰减量

极限参数

最高输入功率	+27 dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

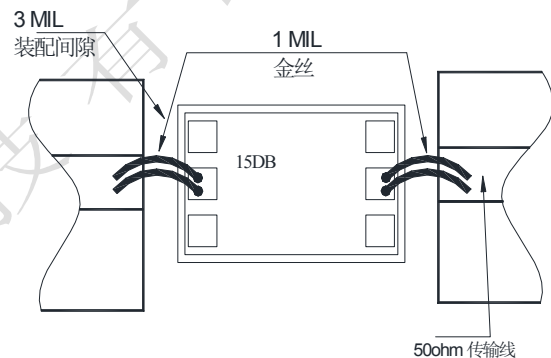


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152\text{ mm}$ ($3 \sim 6\text{ mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{ gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~40 GHz

衰减量: 20 dB

衰减精度: $\pm 0.8\text{dB}$

回波损耗: -20dB

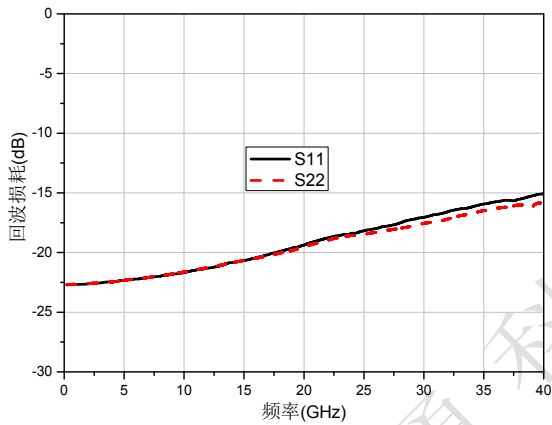
芯片尺寸: $0.8\text{mm} \times 0.5\text{mm} \times 0.1\text{mm}$

接口: 50Ω 共面波导线

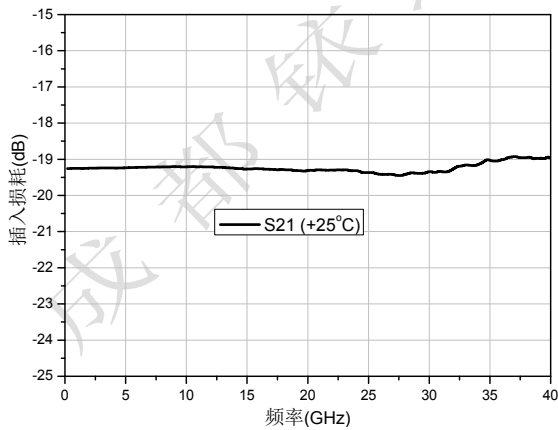
产品简介

YTGS-20是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



输入输出回波损耗

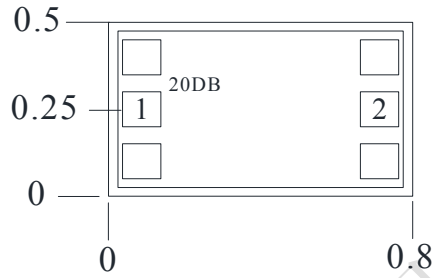


衰减量

极限参数

最高输入功率	+27dBm
存储温度	$-65^\circ\text{C} \sim +150^\circ\text{C}$
使用温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

外形尺寸

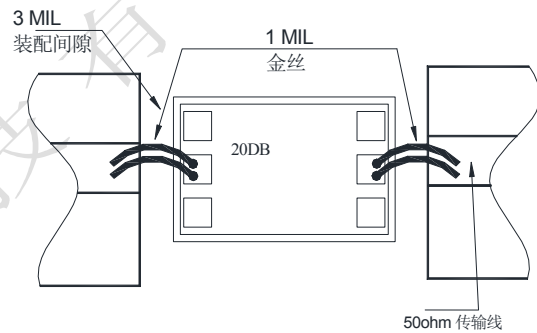


说明:

1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152\text{mm}$ ($3 \sim 6\text{mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板)。

性能特点

通带频段: DC~40 GHz

衰减量: 0/0.5dB/1dB

衰减精度: ± 0.2 dB

回波损耗: > 20 dB

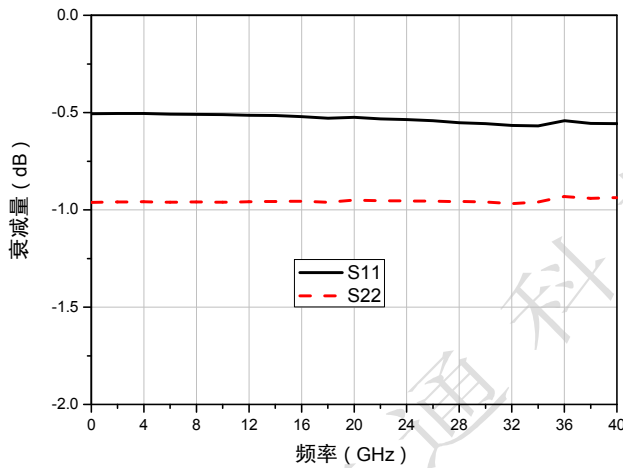
芯片尺寸: 1.0mmx0.5mm x 0.1mm

接口: 50 Ω 共面波导线

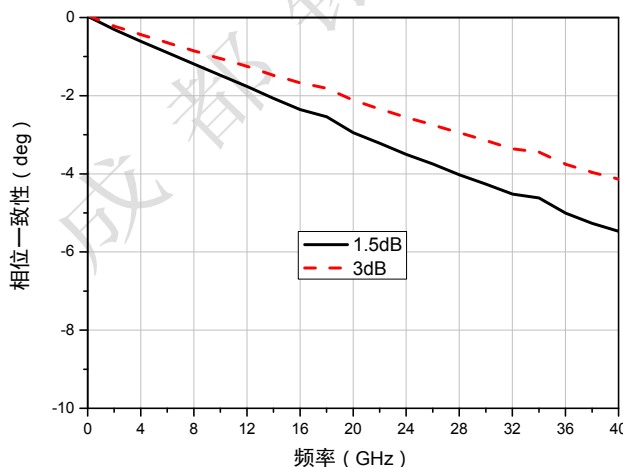
产品简介

YTGS-0P5/0/1是一款砷化镓单片可选固定衰减器芯片。该衰减器器芯片具有衰减精度高、衰减量可选、体积小、重量轻、易集成等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和通道幅度改善。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

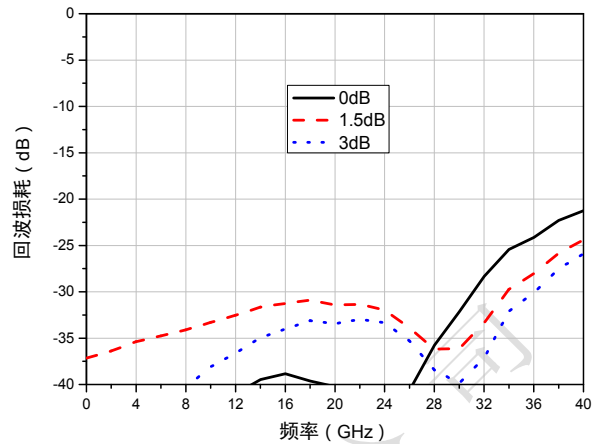
典型曲线 ($T_A=+25^{\circ}\text{C}$)



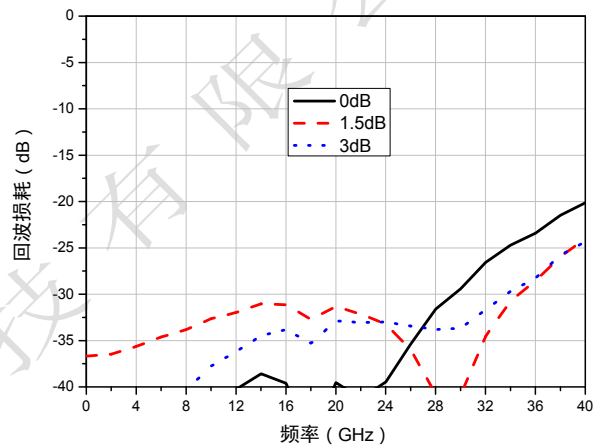
衰减量



相位一致性



输入回波损耗

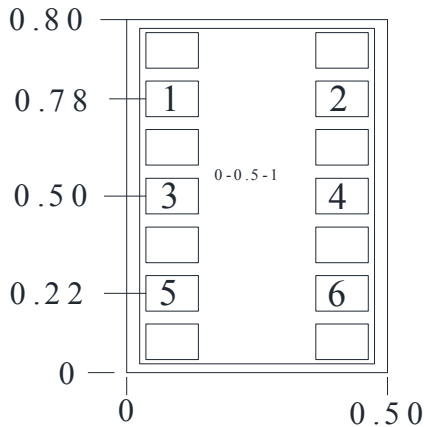


输出回波损耗

极限参数

最高输入功率	+27dBm
存储温度	-65 $^{\circ}\text{C}$ ~+150 $^{\circ}\text{C}$
使用温度	-55 $^{\circ}\text{C}$ ~+125 $^{\circ}\text{C}$

外形尺寸



说明:

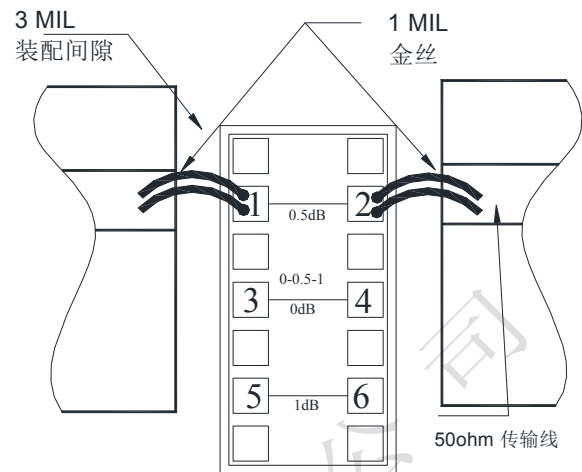
1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1, 2	0.5dB, RF _{in} , RF _{out}	0.5dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
3, 4	0dB, RF _{in} , RF _{out}	0dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
5, 6	1dB, RF _{in} , RF _{out}	1dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
其他	GND	

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152\text{mm}$ (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22\text{gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~40 GHz

衰减量: 0/1dB/2dB

衰减精度: ± 0.2 dB

回波损耗: > 20 dB

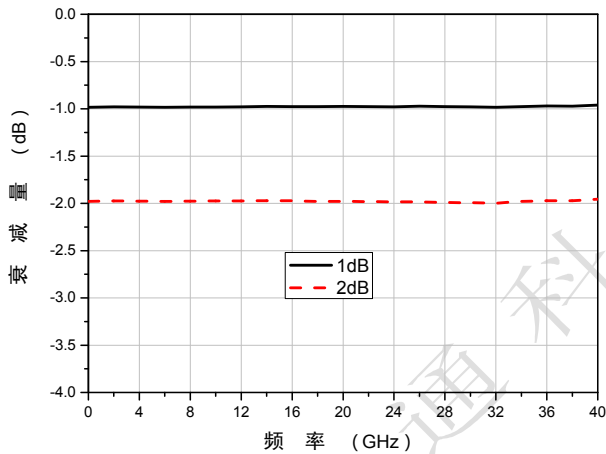
芯片尺寸: 1.0mmx0.5mm x 0.1mm

接口: 50 Ω 共面波导线

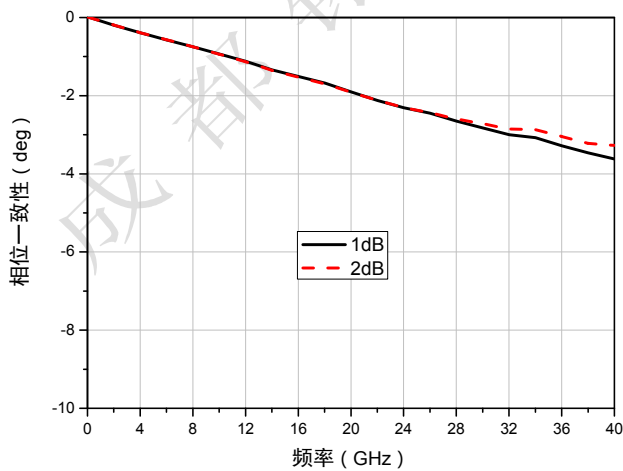
产品简介

YTGS-1/0/2是一款砷化镓单片可选固定衰减器芯片。该衰减器芯片具有衰减精度高、衰减量可选、体积小、重量轻、易集成等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和通道幅度改善。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

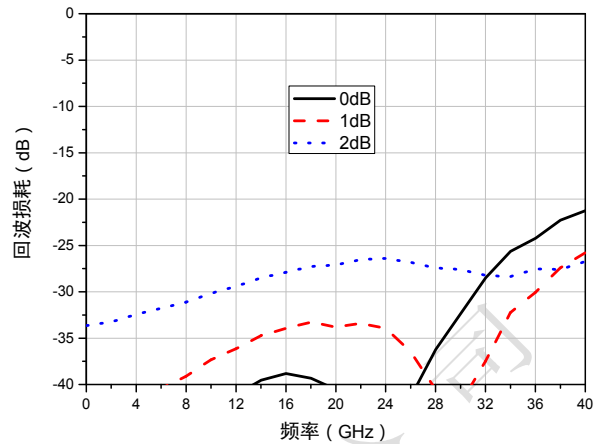
典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



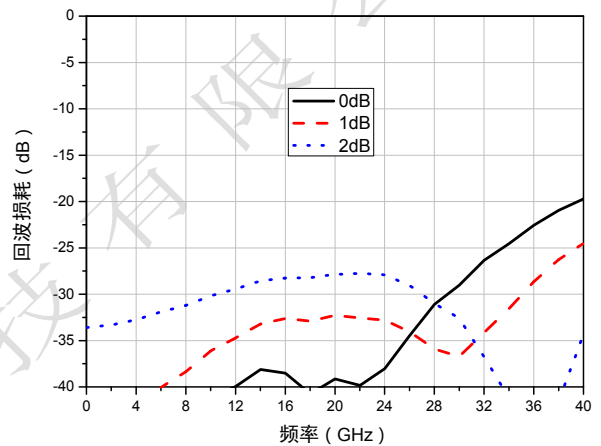
衰减量



相位一致性



输入回波损耗

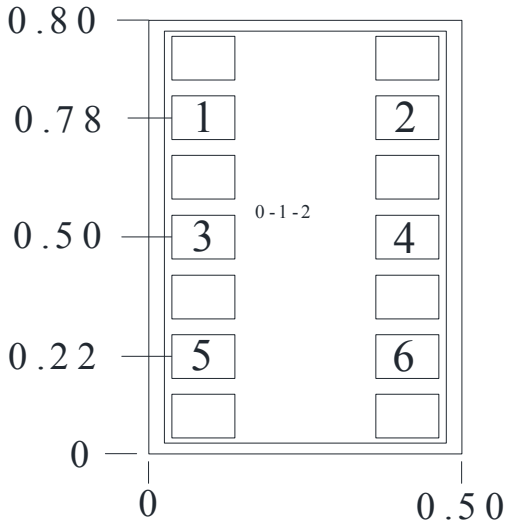


输出回波损耗

极限参数

最高输入功率	+27dBm
存储温度	-65 $^\circ\text{C}$ ~ +150 $^\circ\text{C}$
使用温度	-55 $^\circ\text{C}$ ~ +125 $^\circ\text{C}$

外形尺寸



说明:

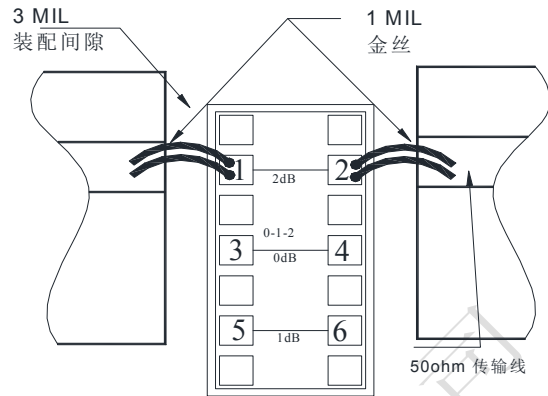
1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1, 2	1dB, RF _{in} , RF _{out}	1dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
3, 4	0dB, RF _{in} , RF _{out}	0dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
5, 6	2dB, RF _{in} , RF _{out}	2dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
其他	GND	

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152 \text{ mm}$ ($3 \sim 6 \text{ mils}$)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22 \text{ gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~40 GHz

衰减量: 0/1.5dB/3dB

衰减精度: ± 0.2 dB

回波损耗: > 20 dB

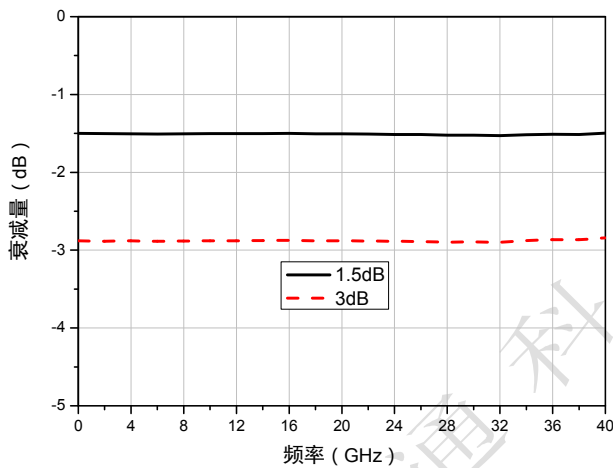
芯片尺寸: 1.0mmx0.5mm x 0.1mm

接口: 50Ω共面波导线

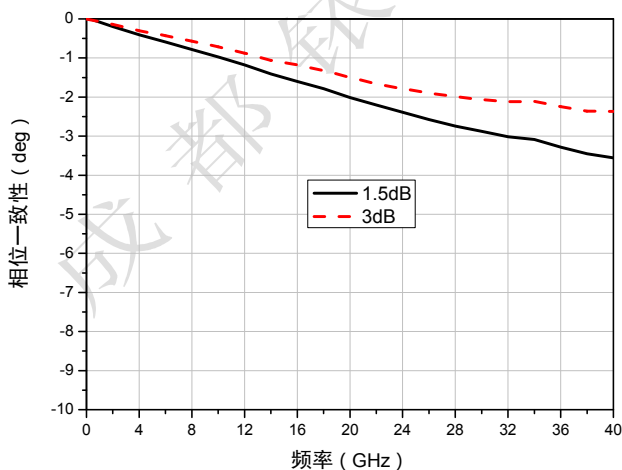
产品简介

YTGS-1.5/0/3是一款砷化镓单片可选衰减器芯片。该衰减器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等特点, 广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理, 适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

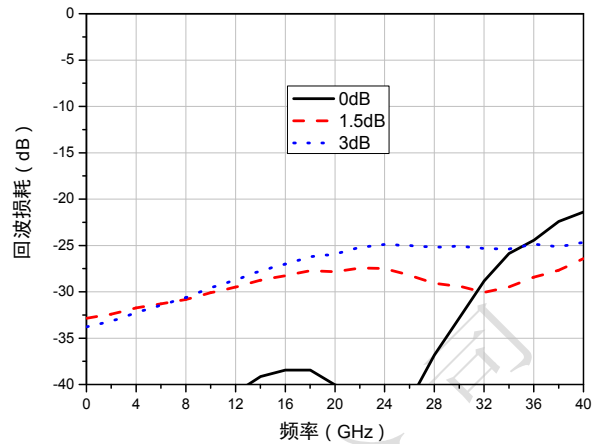
典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



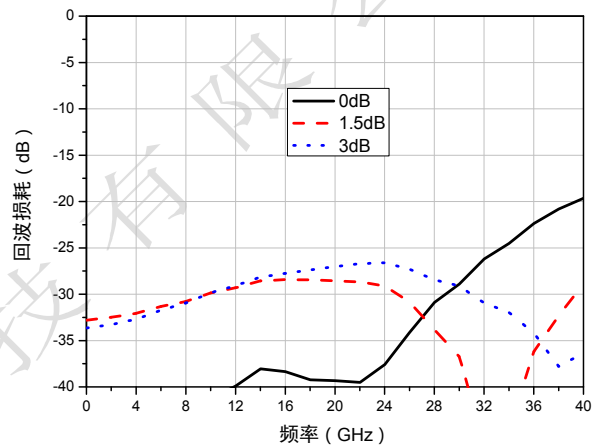
衰减量



相位一致性



输入回波损耗

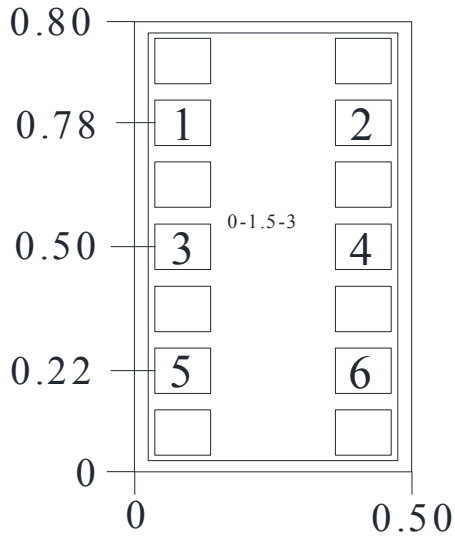


输出回波损耗

极限参数

最高输入功率	+27dBm
存储温度	-65°C ~ +150°C
使用温度	-55°C ~ +125°C

外形尺寸



说明:

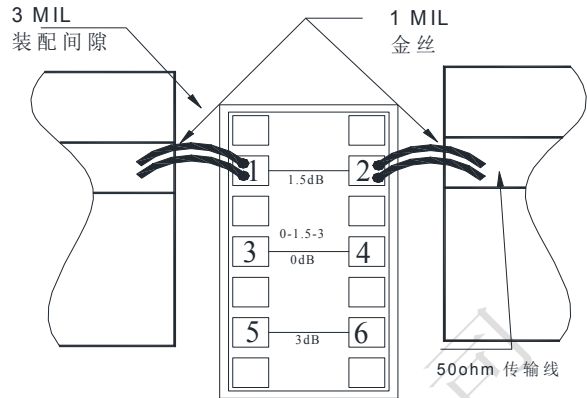
1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1, 2	1.5dB, RF _{in} , RF _{out}	1.5dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
3, 4	0dB, RF _{in} , RF _{out}	0dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
5, 6	3dB, RF _{in} , RF _{out}	3dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
其他	GND	

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。

常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 40~50gf, 楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。

性能特点

通带频段: DC~40 GHz

衰减量: 0/2dB/4dB

衰减精度: ± 0.2 dB

回波损耗: > 20 dB

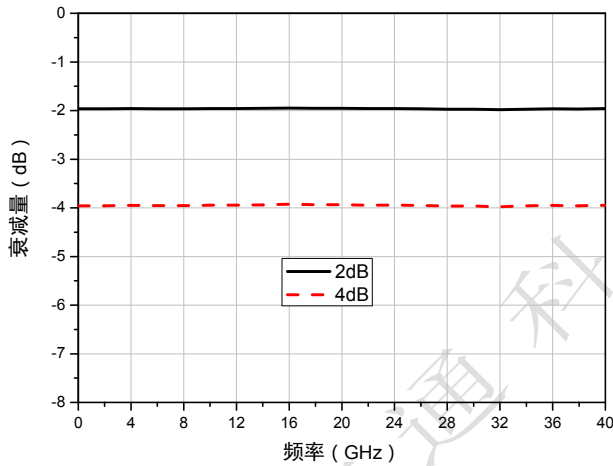
芯片尺寸: 1.0mmx0.5mm x 0.1mm

接口: 50Ω共面波导线

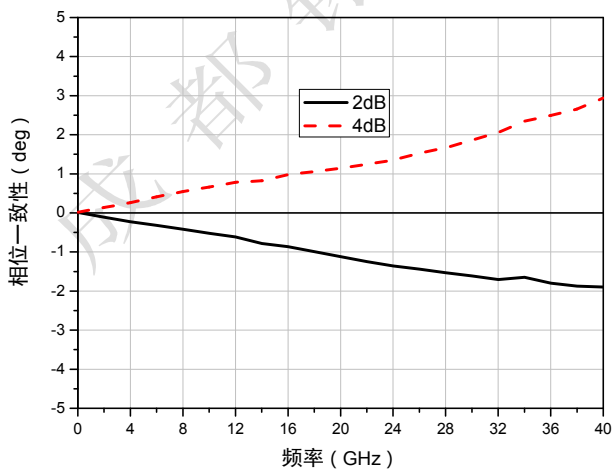
产品简介

YTGS-2/0/4是一款砷化镓单片可选固定衰减器芯片。该衰减器芯片具有衰减精度高、衰减量可选、体积小、重量轻、易集成等特点, 广泛应用于改善阻抗匹配和通道幅度改善。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理, 适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

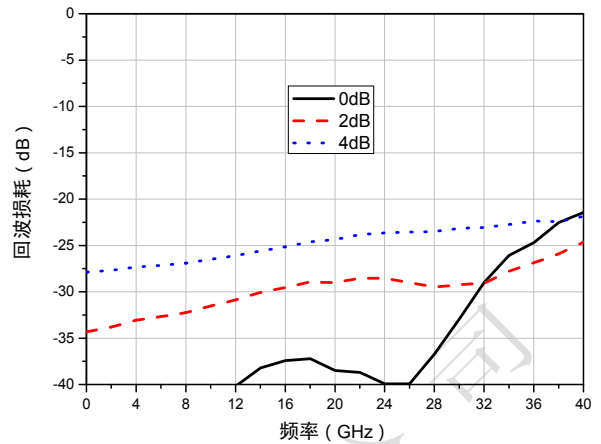
典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



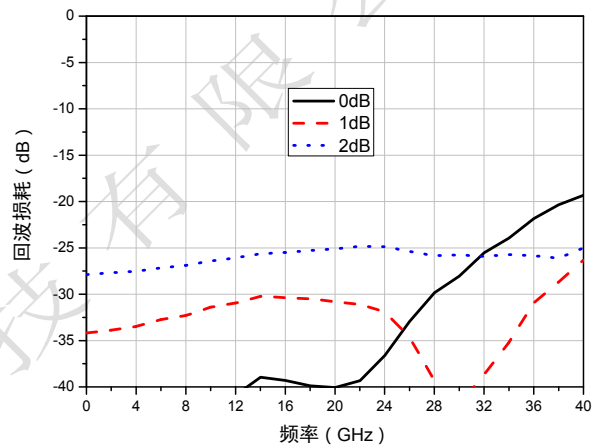
衰减量



相位一致性



输入回波损耗

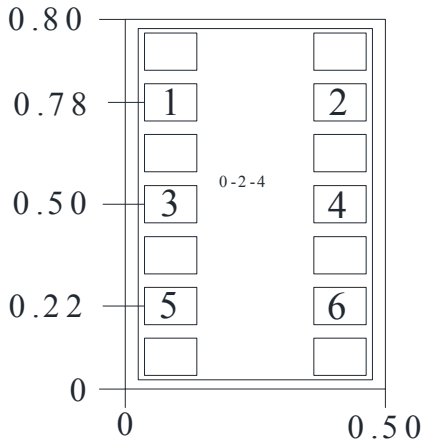


输出回波损耗

极限参数

最高输入功率	+27dBm
存储温度	-65°C ~ +150°C
使用温度	-55°C ~ +125°C

外形尺寸



说明：

1. 单位：毫米，公差：±0.05mm
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金，压点尺寸：0.1mm*0.1mm
4. 不能在通孔上进行键合

注：陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

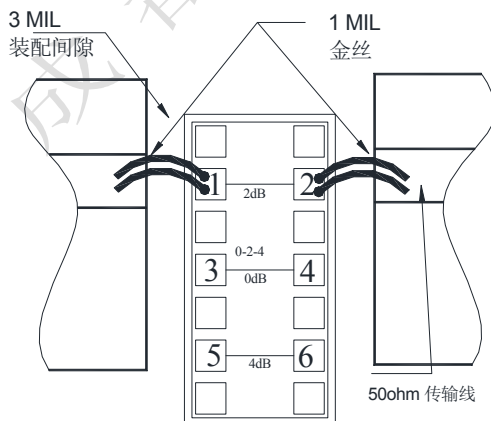
键合操作：球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf，楔形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1, 2	2dB, RF _{in} , RF _{out}	2dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
3, 4	0dB, RF _{in} , RF _{out}	0dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
5, 6	4dB, RF _{in} , RF _{out}	4dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
其他	GND	

应用信息

1. 装配示意图



性能特点

通带频段: DC~40 GHz

衰减量: 0/3dB/5dB

衰减精度: ± 0.2 dB

回波损耗: > 20 dB

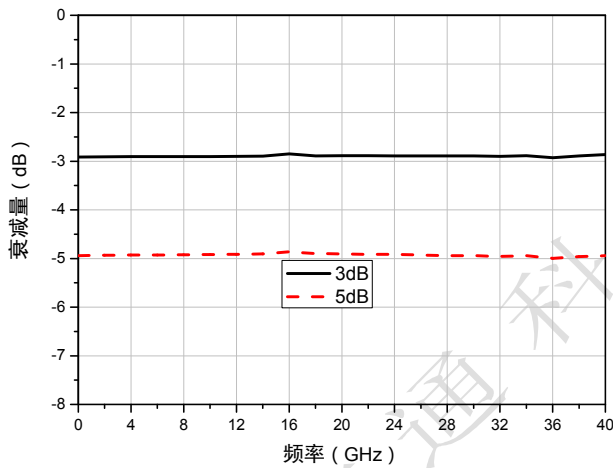
芯片尺寸: 1.0mmx0.5mm x 0.1mm

接口: 50Ω共面波导线

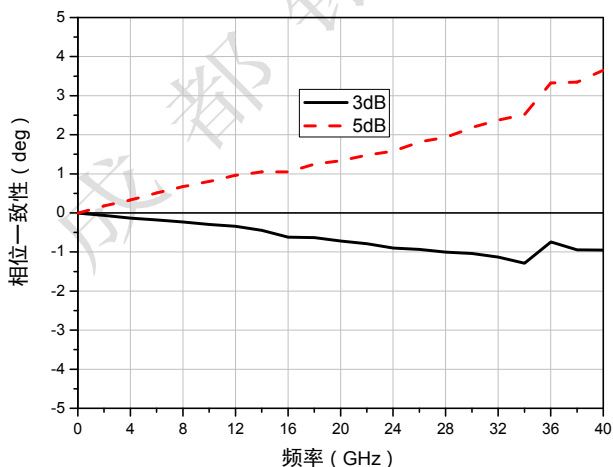
产品简介

YTGS-3/0/5是一款砷化镓单片可选固定衰减器芯片。该衰减器芯片具有衰减精度高、衰减量可选、体积小、重量轻、易集成等特点, 广泛应用于改善阻抗匹配和通道幅度改善。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理, 适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。

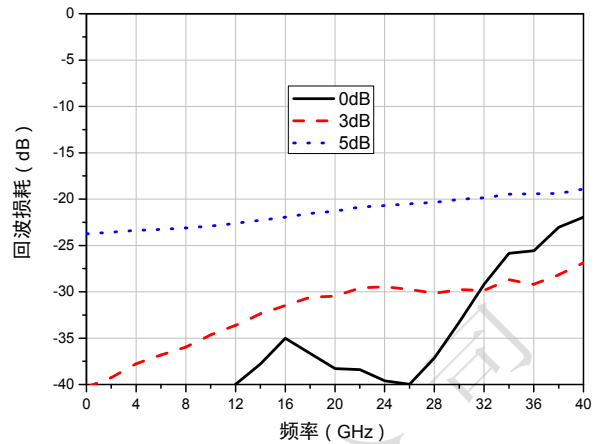
典型曲线 ($T_A=+25^\circ\text{C}$)



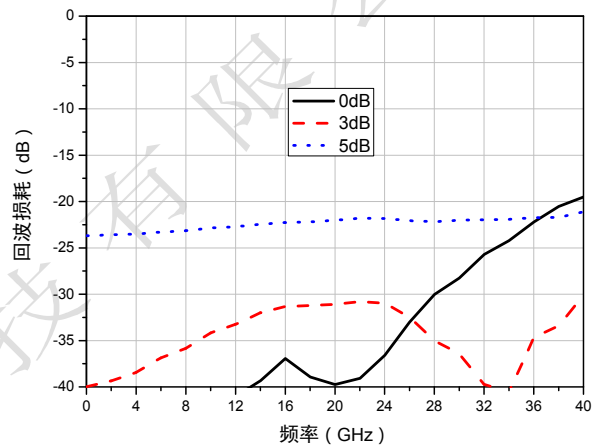
衰减量



相位一致性



输入回波损耗

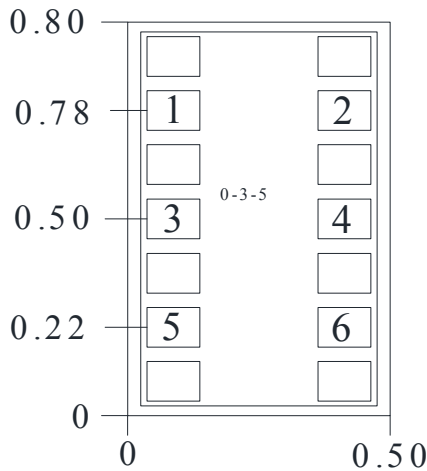


输出回波损耗

极限参数

最高输入功率	+27dBm
存储温度	-65°C ~ +150°C
使用温度	-55°C ~ +125°C

外形尺寸



说明:

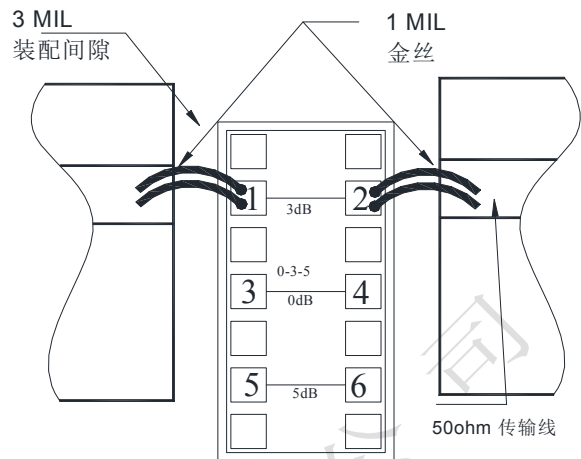
1. 单位: 毫米, 公差: $\pm 0.05\text{mm}$
2. 芯片背面镀金、接地
3. 键合压点镀金, 压点尺寸: $0.1\text{mm} \times 0.1\text{mm}$
4. 不能在通孔上进行键合

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1, 2	3dB, RF _{in} , RF _{out}	3dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
3, 4	0dB, RF _{in} , RF _{out}	0dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
5, 6	5dB, RF _{in} , RF _{out}	5dB 射频输入、输出, 阻抗 50ohm
其他	GND	

应用信息

1. 装配示意图



注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的装配间隙是 $0.076 \sim 0.152 \text{ mm}$ (3 ~ 6 mils)。

2. 操作注意事项

存储: 芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中, 并在氮气环境下保存。

清洁处理: 裸芯片必须在净化环境中操作使用, 禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护: 请严格遵守 ESD 防护要求, 避免器件静电损伤。
常规操作: 拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作: 芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作: 球形或楔型键合均采用 $\Phi 0.025\text{mm}$ (1mil) 金丝。热超声键合温度 150°C 。球形键合劈刀压力 $40 \sim 50\text{gf}$, 楔形键合劈刀压力 $18 \sim 22 \text{ gf}$ 。采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点, 终止于封装 (或基板)。